

ЗАПИСКИ

фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой перовскита

Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Петра Стучки

Проблемная лаборатория физики сегнето- и пъезоэлектриков

Ученые записки
Латвийского государственного университета
имени Петра Стучки
том 189

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА 189

УДК 537.226.33

Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой перовскита. Учен. зап. ЛГУ им.П.Стучки, 1974, т.189. 186 с. Отв.редактор Фрицберг В.Я.

Публикуется часть основных результатов экспериментальных работ по комплексному исследованию сегнетоэлектрических твердых растворов (СЭТР), проведенных в Проблемной лаборатории физики сегнето- и пьезоэлектриков ЛГУ им.П. Стучки в течение 1972-1973 г.г. Приводятся соответствующие данные по исследованию таких вопросов, как выполнение обобщенного закона Кюри-Вейсса в неполярной фазе СЭТР и характер отклонения от него в области разинтого фазового перехода, выяснение закономерностей, которым подчиняется дивлектрическая нелинейность и эффекты электрострикции в неполярной фазе, а также исследованию эффектов спонтанной деформации при фазовом переходе методами дилатометрии и рентгеноструктурного анализа. Основным результатом представленных работ можно очитать экспериментальное установление концентрационных зависимостей таких фундаментальных параметров как постоянной Кюри-Вейсса, приведенного скачка спонтанной деформации и поляризации при фазовом переходе, а также коэффициентов нелинейности и электрострикции в неполярной фазе СЭТП.

Табл. - 6, илл. - 60, библиогр. - 137 назв.

BIBLIOT 74 231-1-74

1

С Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.П.Стучки, 1974 г.

Φ 0-2-3-2-029y 418-73 M 8I2(II)-74

предисловив

В сборнике представлени результати экспериментальных работ, проведенных коллективом авторов —
сотрудниками Проблемной лаборатории физики сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков Латвийского государственного университета имени Петра Стучки под руководством доцента, канд. физ.-мат. наук В.Я.Фрицберга.
Эти работи являются естественным продолжением и
дальнейшим развитием исследований, результаты которых сообщены в предыдущем сборнике "Фазовые перекоды в сегнетоэлектриках" (изд. "Зинатне", Рига. 1971).

По сравнению с предыдущим этапом вначительно усовершенствована методика эксперимента и техника обработки непосредственных результатов измерения. Широко использовались ЭВМ ВЦ Латвийского госуниверситета. Это повволило осуществить более точное и глубоксе изучение выдвинутых проблем при некотором сужении набора изучаемых объектов — в данном случае исследовались исключительно поликристаллические сегнетоэлектрические твердые растворы со структурой перовскита.

В центре внимания настоящего этапа исследований находились такие прослемы, как вопрос о выполнении обобщенного закона Кюри-Вейсса в неполярной фазе и карактер отклонений от этого закона в области фазового перехода, вопрос о закономерностях, которым подчиняется дивлектрическая нелинейность и эффекти электро-

стрикции в неполярной фазе, а также исследование эффектов спонтанной деформации при фазовом переходе, где использованы как методы дилатометрии, так и методы рентгеноструктурного анализа.

Основным результатом представленных в настоящем сборнике работ можно считать экспериментальное установление концентрационных зависимостей таких фундаментальных параметров как постоянной Кюри-Вейсса, скачка спонтанной деформации и поляризации при фазовом переходе, коэффициентов нелинейности и электрострикции в неполярной фазе сегнетовлектрических твердых растворов.

Большое значение, естественно, придавалось тому, чтобы изучаемые явления проявлялись в наиболее "чистом" виде, поэтому очень большое внимание уделялось качеству образцов, изготовление и контроль основных характеристик которых осуществлялись под руководством А.Э.Бранта. В этой связи авторы публикуемых ниме работ выражают глубокую благодарность всем работникам группы синтеза и контроля образцов Проблемной лаборатории.

А.Я.Брок, В.Я.Фрицберг, З.А.Такере, Р.Я.Олехнович, З.А.Тункун

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОБЩЕННОГО ЗАКОНА КЮРИ-ВЕЙССА В СИСТЕМАХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СО СТРУКТУРОЙ ТИПА ПЕРОВСКИТА

введение

Сегнетоэлектрические фазовые переходы (СЭФП), как известно, карактеризуются поляризационной аномалией, которая на кривых температурной зависимости диалектрической проницаемости $\mathcal{E}(T)$ отражается в виде хорошо выраженного максимума. При этом обычно предполагается, что зависимость в неполярной фазе вблизи этого максимума следует так называемому классическому закону Кюри-Вейсса.

Более подробное ознакомление с обширным экспериментальным материалом, накопившимся за последние 15-20 лет, показывает однако, что в этом вопросе следует проявить определенную осторожность.

Во-первых, это относится к классическим системам сегнетоэлектрических твердых растворов (СТР) типа (ва, sr)тіо₃, ва(ті, sn)о₃ и др. При этом, котя и имеются соответствующие данные о выполнении закона Кюри-Вейсса, значения его карактерных параметров (например, постоянной Кюри-Вейсса) отличаются очень большой неопределенностью, а их концентрационные зависимости расплывчаты и даже противоречивы /1-5/.

Во-вторых, принципиально важным и не решенным является вопрос о выполнении закона Кюри-Вейсса вообще в случае
сегнетовлектриков (соединений и СТР), характеризующихся
очень размытым СЭФП. Установлено, что для ряда перовекитовых сегнетовлектриков сложного состава, например, соединения Ръмд_{1/3}Nb_{2/3}O₃ и СТР на его основе, зависимость
в определенном диапазоне температур выше её максимума
значительно отличается от поведения согласно этому закону
/6/.

Наконец, в-третьих, необходимо обратить особое внимание на актуальность подробного исследования $\mathcal{E}(T)$ в широкой области температур неполирной фазы, когда $\mathcal{E}(T)$ уже не подчиняется классическому закону Кюри-Вейсса и может быть рассмотрен т.н. обобщенный закон Кюри-Вейсса /4,11/.

Вполне естественно, что указанное положение не только свидетельствует о существенном пробеле в общем плане следования СТР, но и значительно тормозит дальнейшее развитие теории СЭФП в перовскитах /7+13/. В этой связи била поставлена настоящая работа, посвященная тщательному NSAчению зависимости Е(Т) в её высокотемпературной части для следующих шести систем СТР, вилочающих вещества нак с четкими, так и размытыми СЭФП: (Ba,Sr)TiO, (Pb, Sr)T10,, Ba(T1,Zr)03, (SrBi2/3)T103. Ba(Ti,Sn)03, Рь(мg, N1) 1/3 Nb2/304. Все исследованные объекты - поликристалличны.

Ставились следующие частные задачи работы:

- усовершенствование методики измерения зависимости в (T) и её математической аппроксимации в широкой области параэлектрической фазы вещества;
- проверка выполнения обобщенного закона Кори-Вейсса, с последующим обределением значений соответствующих параметров и их концентрационных зависимостей;
- 3) исследование особенности поведения $\mathcal{E}(T)$ в области размытого СЭФП и, в частности, проверка выполнения квадратичной зависимости типа $\mathcal{L}(T) = A + B(T T_m)^2$

особенности методики исследования

А. Некоторые общие вопросы методики исследования

Мы исходим из положения, что в параэлектрической фазе ьыполняется обобщенный закон Кюри-Вейсса (в.КВ), если температурное изменение относительной статической диэлектрической проницаемости может быть описано следующим выражением:

 $\varepsilon(T) = \varepsilon_L + \frac{C_W}{T - T_0}$

где \mathcal{E}_L - константа, \mathcal{E}_W - постоянная Кюри-Вейсса, \mathcal{T}_O температура Кюри-Вейсса.

Устанавливая связь приведенной выше записи обобщенного закона Кюри-Вейсса с термодинамической теорией ЛандауГинзбурга-Девоншира (ЛГД), органически связанной с классическим з.КВ, следует отметить, что в последней при этом
фактически рассматривается как бы только температур.: о вависимая часть полной диэлектрической проницаемости $\mathcal{E} = \mathcal{E} - \mathcal{E}_{\mathcal{E}}$ и, говоря о законе Кюри-Вейсса, имеется в виду выражение

$$\tilde{\mathcal{E}} = \frac{C_W}{\overline{r} \cdot T_D} \tag{2}$$

Согласно теории ЛГД /I4/ для параэлентрической фазы имеем

$$\frac{1}{\overline{H}(T)} = 2\alpha(T) = 2\alpha_W(T - T_0)$$
 (3)

где ∞ — коэффициент квадратичного члена разложения электрического термодинамического потенциала в виде ряда $\Phi = \Phi_0 + \infty P^2 + \ldots - EP; \quad \infty_W - постоянная, характеривующая данное вещество; <math>T_0$ — температура Кюри-Вейсса; H — температурно зависимая часть диэлектрической восприимчивости.

Далее, с учетом общего соотношения $\mathcal{E}=1+4\pi\mathcal{A}$, которое ввиду того, что $\mathcal{E}\gg 1$ во всем практически рассматриваемом диапазоне температур, может быть заменено через $\mathcal{E}=4\pi\mathcal{A}$, окончательно имеем следующую свизь (I) и (3):

$$\alpha(T) = \frac{2\pi}{\varepsilon}(T) = \frac{2\pi}{c_W}(T - T_0) = \frac{2\pi}{\varepsilon - \varepsilon_L}(T)$$

Отметим кстати, что наличие коэффициента 2π зависит от выбора формы записи квадратичного члена разложения электрического термодинамического потенциала. В случае записи его в форме $\frac{2\pi}{2}$ вместо коэффициента 2π появляется коэффициент 4π . Следует также указать, что иногда обобщенный з.КВ записывается для диалектрической восприимчивости и представляется в форме $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{L} + C_{W} (T-T_{0})^{-1}$. При этом необходимо учесть, что $C_{W} = 4\pi C_{W}$, где C_{W} — постоянная

Кюри-Вейсса в записи занона для диэлектрической проницаемости. Ниже всюду будет употребляться значение \mathcal{C}_{ω} .

При экспериментальном исследовании выполнения обобщенного закона Кюри-Вейсса, особенно в случае веществ в поликристаллической форме и также при наличии размытого ФП (РФП), необходимо учесть два важных требования:

- определяемая зависимость є (7) должна соответствовать вкладу только основного механизма поляризации вещества;
- 2) определение зависимости $\mathcal{E}(T)$ выше её максимума должно быть проведено в максимально ш и р о к о м диапазоне температур.

Первое требование отражает стремление и тому, чтобы и анализу не подвергались эксперидальнейшей обработке ментальные данные, которые кроме вклада основного механизма поляризации в эначительной степени содержат вклады различных других механизмов. В случае интересующих нас перовскитовых материалов основным механизмом поляризации, с которым собственно и связывается выполнение щенного закона Кюри-Вейсса, является ионно-электронный межанизм, в основе которого лежит вызванное внешним полем возмущение движения образующих регулярную кристаллическую решетку полиризуемых монов. В начестве неосновных механизмов поляризации обычно выступают механизмы, обусловленные дефектностью структуры (меканизм тепловой поляризации слабо закрепленных заряженных частиц), а также не нулевой электропроводностью диэлектриков в комбинации с наличием различного рода внутренних граничных поверхностей, которых могут накапливаться носители электрического заряда (межанизи межслойной поляризации).

Второе требование диктуется необходимостью обеспечения уверенного определения зависимости $\mathcal{E}(T)$ не только в окрестности СЭФП, в которой могут иметь место отклонения от обобщенного в. КВ, но в самой параэлектрической фазе вещества, для которой, собственно, и проводится проверка выполнимости обобщенного в. КВ. Учет этого требования

играет особо важную роль в случае исследования веществ, претерпевающих РФП. Кроме стремления и четкому виделению температурной границы параэлектрической фазы, широкий температурный диапазон зависимости & (7) необходим также для обеспечения достаточной надежности проверки выполнения в этой фазе обобщенного в.КВ, так как при этом по сути дела проводится анализ возможности аппроксимации экспериментальной зависимости & (7) аналитическим выражением типа(I). Естественно, что уверенные выводы нельзя сделать на базе рассмотрения лишь узкого участка экспериментально полученной зависимости.

Удовлетворить одновременно обоим основным требованиям можно, соответственно выбрав методику экспериментального определения диэлектрической проницаемости. Эффективным решением вопроса является проведение измерений & (7) в диапавоне сверхвысоких частот (СВЧ). При этом, из-за относительно больших собственных времен релаксации, обычно оказываются практически исключенными все неосновные механизмы поляризации. В то же время - в отношении основного механизма поляризации - условия измерения остаются статическими , так нак частота измерительного поля все же значительно ниже значений собственных частот этого механизма. Кроме того, применение СВЧ измерительной техники позволяет вести измерения в широком интервале температур, вплоть до 600+1000°C, ибо эффекти, связанние ростом электропроводности, при этом также оказываются достаточной степени подавленными.

Таким образом, основные задачи при усовершенствовании методики исследования выполнения обобщенного в.КВ для поликристаллических твердых растворов с учетом особенностей РФП сводятся к оптимальному выбору соответствующей СВЧ методики определения $\epsilon(T)$ и способа обработки экспериментальных данных.

Б. Экспериментальное определение зависимости *E(T)*в диапазоне СВЧ

На основании всестороннего изучения СВЧ методов определения зависимости $\mathcal{E}(T)$ для сегнетоэлентриков, т.е. веществ с высоким значением диэлектрической проницаемости, нами была предложена схема классификации известных в настоящее время основных методов измерения и выявлено, что наиболее подходящими для исследования $\mathcal{E}(T)$ в параэлектрической фазе являются ревонансные методы. Среди резонансных методов был выбран метод резонанса короткозамкнутого отрезка передающей линии (РОПЛ-К), систематическое изложение и результаты подробного анализа которого были опубликованы одним из авторов настоящей статьи /15/.

Методы резонанса отрезков передающих линий (методы РОПЛ) разработаны на основе образования СВЧ резонаторов в виде отрезков передающих линий, заполненных исследуемым вешеством. В связи с большими значениями & сегнетоэлектриков, геометрическая длина соответствующих отрезков передающих линий достаточно мала и это позволяет вести измерения на образцах интересующих нас веществ удобно изготовляемой формы и размеров. Теория этих методов может быть развита на базе теории СВЧ линий передачи, а сами методы рассмотрены как специфические варианты общих методов линии передачи.

Метод РОПЛ-К представляет собой резонансный вариант общего метода короткого замыкания отрезка линии. При геометрической длине отрезка линии-образца, кратной нечетному числу четверти длины волны в образце, имеет место так навываемый параллельный резонанс отрезка передающей линии,
характеризующийся минимальным отражением электромагнитных
волн. Расчет & производится на основе соответствующего
резонансного соотношения, а для определения тангенса угла
дивлектрических потерь 190 необходимо измерить также соответствующее резонансное значение модуля комплексного ко-

эффициента отражения или коэффициента стоящей волны напряжения (КСВН).

Блокскема измерительной системы для определения ϵ и $tq\delta$ методом РОПЛ-К приведена на рис. I.



Рис. I. Блокскема измерительной системы для определения в и tgd методом РОПЛ-К

Наиболее целесообразным при ее построении оказывается применение волноводных линий передачи и автоматических панорамных измерителей модуля комплексного коэффициента отражения или КСВН.

Основные точные расчетные соотношения метода РОПЛ-К следующие: $\varepsilon' = \varepsilon = (\beta_{v\varepsilon}^2 - \alpha_{v\varepsilon}^2) \left(\frac{\lambda_o}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_o}{\alpha_{ap}}\right)^2$ $\varepsilon'' = 2\alpha_{v\varepsilon}\beta_{v\varepsilon} \left(\frac{\lambda_o}{2\pi}\right)^2$

образце (отрезке линии передачи); Виз — коэффициент фазы распространения ЭМ волн в образце; Виз — коэффициент фазы распространения ЭМ волн в передающей линии с воздушным заполнением; λ_o — длина волны в вакууме в свободном пространстве; λ_{vo} — длина волны в передающей линии с воздушным заполнением; λ_{co} — критическая длина волны для основной волны в конкретной линии передачи; d_{so} — толщина

образца, т.е. длина заполненного исследуемым веществом отрезка линии; R_{XX}^{pes} - резонансное значение активной компоненты входного нормированного полного сопротивления отрезка линии передачи (образца).

На практике обычно можно в значительной степени упростить приведенные выше расчетные соотношения. В приближении больших & и малых 190, которое почти всегда допустимо при исследованиях веществ в параэлектрической фаве, имеем следующие расчетные соотношения для & и 190:

$$\mathcal{E} = \left(\frac{m\lambda_0}{4d_x}\right)^2; \quad tg\delta = \frac{2}{\pi m} \ln \frac{m\lambda_{vo}^{pes} R_{xx}^{pes} + 4d_x}{m\lambda_{vo}^{pes} R_{xx}^{pes} - 4d_x}$$

В носледнем случае для определения значения tgd очень удобно пользоваться заранее построенными графиками функции $tgd = f(R_{xx}^{pes}\lambda_{vo}^{pes}/d_{x})$ для различных значений параметра m, который представляет собой число четвертьволн, укладивающихся при резонансе по длине образца d_{x} .

Анализ погрешностей метода показывает, что для определения с метод РОПЛ-К обычно является нормально сбалансированным (доминируют экспериментальные погрешности)и общая погрешность измерения с практически определяется лишь экспериментальными погрешностями толщины образца и частоты СВЧ колебаний. В целях применения метода для проверки выполнения обобщенного з.КВ в параэлектрической фазе нетрудно добиться погрешности определения с меньше 1%.

Более подробные сведения о методе РОПЛ-К и его практической градизации можно найти в работе /15/.

В. Обработка экспериментальных результатов

Проверка выполнения обобщенного в.КВ в параэлектрической фазе и последующее определение соответствующих параметров заключается в тщательном анализе возможности аппроксимации экспериментально определенной зависимости $\varepsilon(T)$ аналитическим выражением обобщенного в.КВ (I). При этом следует учесть, что экспериментально определенная вависимость $\mathcal{E}(T)$ веществ, претерпевающих размитий СЭФП, в температурном интервале в и в температури максимума T_{77} в
рощем случае значительно отличается от классической гиперболической зависимости. Эти отклонения, обусловление наличием области размитого СЭФП и вкладом температурно независимой составляющей диэлектрической проницаемости \mathcal{E}_{L} ,
обязательно дслжны быть корректно учтени. Поскольку необкодимость учета эффекта размития СЭФП в основном уже обсуждалась выше, то сейчас несколько подробнее рассмотрим
вопросы, связанные с учетом температурно независимой составляющей диэлектрической проницаемости (\mathcal{E}_{L}).

В литературе очень часто (фактически в подавляющем большинстве случаев) вместо более корректного рассмотрения закона Кюри-Вейсса в его обобщенной форме (I) или (2) рассмотрение $\mathcal{E}(T)$ в неполярной фазе ведется согласно вмражению классического з.КВ:

$$\varepsilon(T) = \frac{C'_W}{T - T_0'} \tag{4}$$

Таким образом, сохраняя в левой части вависимости (1) полную диэлектрическую проницаемость, в правой части отфасывают \mathcal{E}_L . Поэтому $\mathcal{C}_W \neq \mathcal{C}_W$ и $\mathcal{C}_O \neq \mathcal{T}_O$. Вполне очевидно, что классическое представление закона Кюри-Вейсса в форме. (4) допустимо лишь при выполнении условия $\mathcal{E}_L \ll \mathcal{C}_W (7-7_O)^{-1}$. Тогда с определенной точностью $\mathcal{E} = \mathcal{E}_L \mathcal{C}_W = \mathcal{C}_W$ и $\mathcal{T}_O = \mathcal{T}_O$. Если учесть, что $\mathcal{E}_L = 20 + 50$, то указанное приближение допустимо только в области значений $\mathcal{E} \gg (2 + 5) \cdot 10^4$, ибо только тогда соответствующая погрешность приближения становится гораздо меньше экспериментальной погрешности определения $\mathcal{E}_L \ll 10$ раз, если $\Delta \mathcal{E}_L \ll 10$ порядка $\mathcal{E}_L \ll 10$. Такие условия реально могут быть соблюдени только в случае исследовании веществ с четкими фазовыми переходами (ЧФП) и даже тогда только в очень узком интервале температур.

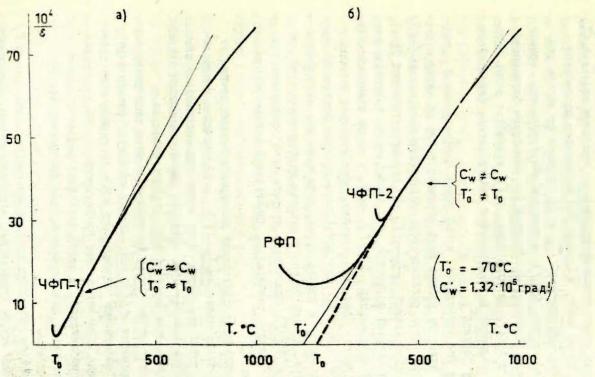
Следовательно, <u>классическое представление закона Кюри-</u> Вейска (4) имеет очень ограниченное применение. Последнее особо следует иметь в виду потому, что на нем базируется распространенный способ обработки экспериментальных данных, так называемый метод "прямой" — для определения соответствующих значений постоянной и температуры Кюри-Вейсса.

Согласно этому способу используется зависимость $\mathscr{E}(T)$, которая в рассматриваемом интервале температур обычно апроксимируется прямой. По пересечению этой прямой с осью абсцисс определяется значение параметра T_0 , а значение параметра C_W находится как котангенс угла наклона прямой к этой же оси. Значение параметра \mathcal{E}_L не определяется. Встественно, что такой метод, так же как и классическое представление закона Кюри-Вейсса, имеет ограниченные возможности практического применения.

Для наглядной демонстрации результатов некорректного применения метода "прямой" и представления закона Кюри-Вейсса в классической форме (4), когда уже не выполняется условие $\mathcal{E}_{L} \ll C_{W}/(7-T_{0})$, на рис.2 схематически отображены некоторые характерные ситуации, встречающиеся при обработке экспериментальных данных непосредственных измерений. Рассматривается гипотетический сегнетоэлектрик, имеющий параметры зависимости Кюри-Вейсса $\mathcal{E}_{L}=30$, $\mathcal{E}_{W}=1,00\cdot10^{5}$ град. $T_{0}=0^{\circ}$ С, в трех вариантах, различающихся по характеру фазового перехода: а) четкий ФП с высоким значением \mathcal{E}_{m} при температуре максимума T_{m} (ЧФП-1); б) четкий ФП с относительно невысоким значением \mathcal{E}_{m} (ЧФП-2) и размитый ФП (РФП).

Очевидно, что применение метода "прямой" допустимо только в случае исследования веществ, для которых в паравлектрической фазе достигаются очень высокие значения дивлектрической проницаемости и при построении зависимости

Ус(Т) использованы данные интервала температур, примыкающие и Т_т. Обычно это реализуется только в случае
ЧФП (рис.2а - случай ЧФП-I). Если в параэлектрической фаве достигаются не очень высокие значения диэлектрической
проницаемости, то применение метода" прямой совершенно недопустимо как в случае четкого, так и размытого СЭФП (рис.26-



15

Рис. 2. Иллюстрация к вопросу о различии полученных методом прямой значений параметров классического з.КВ (C_w , T_o) и обобщенного з.КВ (C_w , T_o)

случаи ЧФП-2 и РФП). При этом видно, что значения C_W и T_O уже весьма существенно отличаются от истинных значений C_W и T_O . Кроме того, в случае РФП появляется неоднозначность, так как значения C_W и T_O' зависят от выбора участка зависимости $\mathscr{V}_{\mathcal{E}}(T)$, в котором конструируется прямая.

Таким образом, на практике при обработке экспериментальных результатов измерения $\mathcal{E}(T)$ требуется очень осторожное отношение к классической записи закона Кюри-Вейсса и методу "прямой".

Как уже отмечалось, кроме учета составляющей \mathcal{E}_L , тщательное внимание должно быть обращено также на наличие размытия СЭФП. Если рассматривать нелинейную вависимость $\mathscr{V}_{\mathcal{E}}(T)$ относительно прямой $\mathcal{E}_{-\mathcal{E}_L}(T)$ (в параэлектрической фазе), то из-за наличия параметра \mathcal{E}_L наблюдается отклонение измеренной вависимости $\mathscr{V}_{\mathcal{E}}(T)$ вниз, в то же время как наличие размытия СЭФП, как правило, обусловливает отклонение вверх (см. рис.2б). Отклонение первого типа фактически имеет место при всех температурах, хотя явно оно наблюдается только при наличии широкого участка экспериментальной зависимости $\mathscr{V}_{\mathcal{E}}(T)$. Отклонение второго типа обнаруживается только в области температур, прилегающей к температуре максимума T_m .

Вакономерное отклонение экспериментальных точек от линейной зависимости $\frac{1}{\epsilon - \epsilon_L}(T)$, наступающее с приближением к точке максимума $\epsilon(T)$, можно рассматривать в качестве экспериментального критерия для установления нижней границы параэлектрической фазы данного вещества.

Можно предложить два способа обработки экспериментальной зависимости $\mathcal{E}(T)$, поэволяющих адекватно решить задачу проверки выполнения обобщенного э.КВ и определения соответствующих параметров. Это графический способ последовательных приближений и метод численной аппроксимации с применением ЭВМ, реализованный нами при выполнении настоящей работы.

Первый из указанных методов анализа зависимости $\varepsilon(T)$ представляет собой графическую обработку экспериментальных

данных. Сначала, следун зависимости 1/2 (Т), оценивается исходное приближенное значение параметра 70. Далее строится зависимость $\varepsilon(\frac{1}{7-76})$, которая путем последовательного подбора нараметра Е максимально выпрямляется. Если ва-.-) представляется прямой, то значение параметра 70 соответствует температуре Кюри-Вейсса, тангенс угла наклона прямой к оси абсцисо определяет постоянную Кюри-Вейсса $\mathcal{C}_{\mathbf{w}}$, а отсеченный примой отрезок на ординат дает значение параметра \mathcal{E}_{L} . Аналогично можно вместо зависимости $\mathcal{E}(\frac{1}{T-T_{o}})$ "выпрямлять" зависимость $\mathcal{Y}\mathcal{E}(T)$. подбирая соответствующее значение 🐔 . Вначения параметров Сы и То тогда определяются по наилону прямой и точке пересечения горизонтальной оси. Следует однако заметить, что эти методы очень трудоемкие, особенно в олучае веществ с широкой областью размытия СЭФП. В последнем случае из-за наличия экспериментальных точек вне области параэлектрической фазы графические зависимости в (7-70 нельзя полностью выпрямить подбором соответствующего чения параметров То или Е, и можно найти лишь наиболее оптимальную аппрокоимацию, одновременно определяя нижнюю границу параэлектрической фазы.

Более эффективным является метод численной аппроксимации с применением ЭВМ. Суть этого метода состоит в определении значений параметров ε_L , C_W , T_O путем решения систем трех уравнений типа $\varepsilon(T)$ - ε_L + $C_W(T$ - $T_O)$ -, составляемых на основе экспериментальных данных зависимости $\varepsilon(T)$. Применение ЭВМ позволяет перебрать достаточно большое число систем уравнений с последующим усреднением полученных состветственно совокупностей значений ε_L , C_W , T_O . При этом для расчета на ЭВМ целесообразно использовать не непосредственные данные экспериментальных точек, а данные из графически сглаженной экспериментальной кривой $\frac{1}{\varepsilon(T)}$, что значительно упрощает математическую обработку.

В настоящей работе, применяя метод численной аппроисимации с использованием ЭВМ, вся подлежащая аппроисимации аналитическим выражением обобщенного в.КВ область зависи-

BIBLIOTE / 131-1-14

мости є(Т) делилась на 3 равных участка. В каждом из них по сглаженной кривой 1/2 (Т) бралось 5 точек и на ЭВМ решались соответствующие системы уравнений с перебором всех комбинаций точек, при чем каждая тройка точек всегда охватывала все 3 участка (точки распределяются в интервале аппроксимации равномерно, всего решаются 125 систем уравнений). Последующее усреднение и определение среднего квадратичного отклонения от средних значений дает искомые значения параметров Е. . С. . То и позволяет провести оценку качества аппроксимации данного участка экспериментальной вависимости $\varepsilon(T)$, т.е. дает возможность судить о степени выполнения обобщенного в.КВ. О качестве аппроисимации можно убедиться также путем непосредственного построения (согласно определенным значениям ϵ_{ι} , \mathcal{C}_{ν} , \mathcal{T}_{o}) прокримирующей зависимости 1/2 (Т) и сравнивая ее с экспериментальной зависимостью.

Некоторые трудности обычно бывают связаны с анализом Уг (7) для веществ с широкой областью размытия СЭФП, так как заранее не известна нижняя граница области параэлентрической фазы и при первоначальной обработке данных среди выбранных экспериментальных точек могут оказаться также точки вне этой области. В этом случае соответствующая граница определяется путем последовательных приближений, постепенно исключая экспериментальные точки при более низких температурах в выбранном для аппроксимации интервале вависимости %(Т) и добиваясь оптимальной аппроксимации в наиболее широком интервале этой зависимости. значения параметров С, , С, , То , при которых это достигается, рассматриваются в качестве параметров закона Кюри-Вейсса данного материала.

В ваключение следует указать на необходимость коррекции полученных значений параметров Е, и С, в случае, когда исследуемые вещества представляют собой поликристаллы (керамину). Дело в том, что реальные поликристаллы обычно характеризуются наличием в них газовых включений или пор*! Практически беспористые поликристаллы могут быть получены методом горичего прессования.

Это несколько снижает величину непосредственно измеренных значений є по сравнению с "идеальным" поликристаллом, не обладающим порами. Коррекция на пористость требует экспериментального определения величины последней, после чего корректированные значения є и С определяются в соответствии с выражениями /16/

$$\varepsilon_L = \frac{\varepsilon_L - \varepsilon_W}{1 - 15 \pi \rho}$$
 $\varepsilon_W = \frac{\varepsilon_W - \varepsilon_W}{1 - 15 \pi \rho}$

где η_{ρ} - величина пористости поликристалла (определение η_{ρ} см. ниже).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

А. Некоторые исходные характеристики исследуемых объектов и замечания к технике эксперимента

Исследовались образцы веществ в поликристаллической форме, изготовленные в нашей лаборатории в соответствии с обычной двухстадийной сегнетонерамической технологией. Исходные образцы изготовлялись в виде дисков с диаметром 30 мм и толщиной около 5 мм, после чего из них вырезались пластины размеров, соответствующих поперечному сечению волноводного тракта СВЧ измерительной системы. В настоящей работе все пластины имели сечение 22х10 мм, а толщина их менялась в пределах от I до 4 мм в зависимости от конкретных требований, возникающих при измерениях. Электроды наносились методом вжигания серебра.

Для контроля качества изготовленных образцов (пластин) последовательно проводились следующие операции: проверка открытой пористости и влагопоглощения, определение плотности методом гидростатического взвешивания, определение величины пористости керамики, измерение температурных зависимостей e(T) и $tg \delta$ в диапазоне частот $10^2 + 10^4$ гц. В отдельных случаях проводились также рентгеновский

фазовый анализ и исследование макроструктуры керамики (зернистость, соотношение кристаллической, аморфной и газовой фаз). Совокупность этих данных, дополненная в некоторых случаях результатами других физических исследований, проведенных параллельно на этих же образцах (например, снятие реверсивных характеристик диэлектрической проницаемости, дилатометрические измерения), позволяла отобрать для наших измерений образцы достаточно высокого качества.

Определение величины пористости Пр керамических образцов проводилось на основе данных о рентгенографической плотности и плотности, определяемой гидростатическим методом, производя соответствующий расчет по формуле пр = 1где ρ_{τ} - рентгенографическая плотность, ρ ческая плотность. Плотность рт определялась путем пользования имеющихся рентгеноструктурных данных о значениях параметров элементарных ячеек (ее объема) при комнатной темперетуре. Для всех твердых растворов, за исключением растворов системы (Bi_{2/3},Sr)TiO₃, плотность Р₇ определялась путем линейной интерполяции между соответствующими значениями Рт исходных компонент. Использовались дующие значения плотности 🎤 веществ (с указанием источника рентгенографических данных): ВаТіО3 - 6102 г/см3/17/, BazrO3 - 6,25 r/cm3 /18/, BasnO3 - 7,30 r/cm3 /19/, $Pb_3MgNb_2O_9 - 8,18 г/см^3 /17/, <math>Pb_3NiNb_2O_3 - 8,56 г/см^3/17/.$ Для ($Bi_2/3$, Sr) $TiO_3V_9л.яч. = 59,32 · <math>10^{-24}$ см³ и не зависит от концентрации /20/. Дальнейшему исследованию не подвергались образцы со значениями Пр больше 0, 1.

Определение зависимостей $\varepsilon(T)$ и $tg\sigma(T)$ в диапазоне низких частот проводилось параллельно при трех значениях частот (10^2 , 10^3 и 10^4 гц) и служило в основном для оценки качества образцов по уровню $tg\sigma$. Нас интересовали также характеристики зависимости $\varepsilon(T)$ в области ее максимума (максимальное значение ε_m , размытие максимума, диспер-

ж Следует отметить, что примененный способ определения пористости по нашему мнению все же не является совершенным и обуславливает завышенные значения последней.

сия с). Дальнейшему исследованию не подвергались образци, если их значение с оказывалось значительно ниже значений, приведенных в литературе различными авторами, использовавших керамику достаточно высокого качества /1,2,21-24/. Для отобранных таким образом качественных образцов результаты контрольных измерений на низких частотах были далее использованы также для общего рассмотрения особенностей поведения зависимости с (Т) в области размытого СЭФП.

Основные измерения зависимости г/7 проводились в 3-см диапазоне СВЧ. В начале исследований была собрана измерительная система на базе следующих узлов блокскемы: СВЧ генератор ГЗ-25, рефлектометр из комплекта импедометра Р2-6, измерительный усилитель типа 28-ИМ и самописец КСП-4. Измерения методом РОПЛ-К при этом велись способом дискретной перестройки частоты /15/. Позже измерительная система была реализована на основе автоматического панорамного измерителя коэффициента стоящей волны Р2-27Б, вследствие чего обеспечивались наиболее оптимальные условия измерений в параэлектрической фазе веществ. Погрешность определения диэлектрической проницаемости в параэлектрической фазе порядка 1%, а в области СЭФП (из-за необходимости применения тонких образцов) порядка 3+5%.

Температурный диалазон измерений распространялся от азотных температур вплоть до 600°С. Расширение его выше 600°С ограничивается из-за чрезмерного при этом окисления волноводного тракта измерительной ячейки и вгорания измерение температуры проводилось ручным потенциометрическим методом с применением термопар типа кромель-алюмель, хромель-коппель, а также медь-константан.

Из-за возможного случайного характера влияния различных технологических факторов изготовления на физические свойства интересующих нас образцов, для получения достоверной информации о соответствующих значениях их количественных характеристик использовался статистический набор полученных экспериментальных данных с последующим усреднением. Это значительно увеличивает продолжительность работы, но зато позволяет гораздо увереннее судить о наличии

определенных закономерностей при изменениях физических свойств внутри систем сегнетовлектрических твердых растворов (СТР). В этой связи для каждого состава СТР были исследованы как минимум 3+5 качественных образцов различных технологических партий изготовления. Приведенные ниже результаты представляют собой усредненные значения параметров обобщенного з.КВ, а зависимости $\mathcal{E}(T)$, $//\mathcal{E}(T)$, $//\mathcal{E}(T$

Б. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости

На рис. 4+6 приведены зависимости $\sqrt{\varepsilon(T)}$ для исследованных систем твердых растворов. Поскольку вид зависимостей $\varepsilon(T)$, определенных на низких частотах, для исследованных сегнетоэлектрических растворов в общем не отличается от ранее опубликованных /I,2,2I+24/, они нами не приводятся. Из приведенных рисунков следует, что зависимость $\sqrt{\varepsilon(T)}$ очень наглядно отражает интересующие нас закономерности.

Приведенные зависимости представляют собой совмещенные данные низкочастотных и СВЧ измерений. В этой связи
внимание заслуживают приведенные на рис. З зависимости для
одного из твердых растворов системы (Ві2/3, Sr)ТіО3, наглядно демонстрирующие преимущества и необходимость применения
СВЧ методики. Из рассмотрения этого рисунка следует, что
таким образом действительно удается надежно выделить вклад
в дивлентрическую проницаемость основного, единого для
всех перовскитовых дивлектриков, квазиупругого ионно-электронного механизма поляривации, в то время как соответствующие низкочастотные измерения включают значительный вклад
различных неосновных механизмов. Это особенно характерно

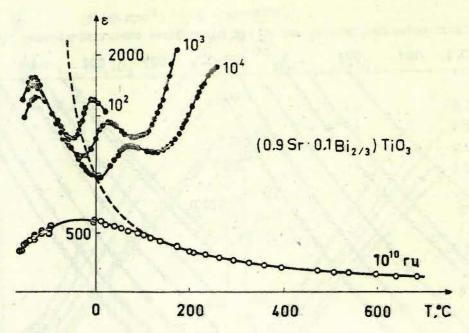
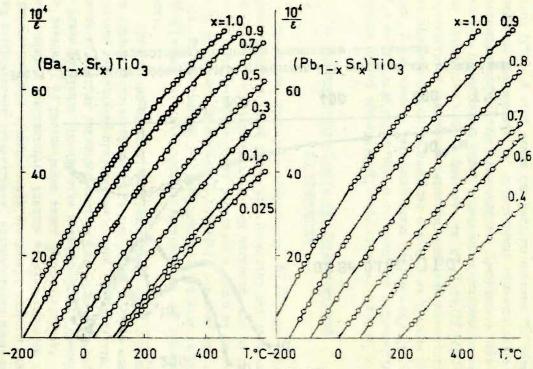
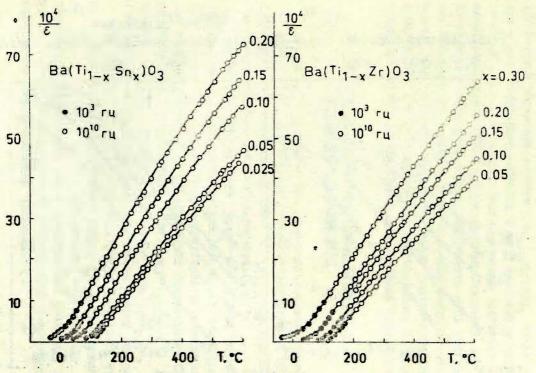


Рис.3. Иллюстрация эффективности применения СВЧ методики для определения е(7), обусловленной основным механизмом поляризации



. Рис.4. Экспериментальные зависимости $\frac{1}{\epsilon}(T)$ для твердых растворов систем (Ва,Sr)TiO $_3$ и (Pb,Sr)TiO $_3$



25

Рис.5. Экспериментальные зависимости $\frac{1}{2}(T)$ для твердых растворов систем Ва(Ti,Sn)03 и Ва(Ti,Zr)03

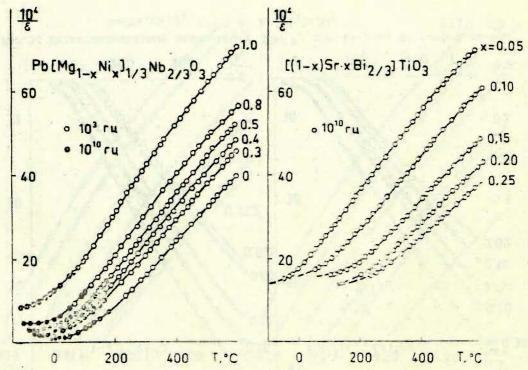


Рис.6. Экспериментальные зависимости %(T) для твердых растворов систем $\text{Pb}(\text{Mg},\text{Ni})_{1/3}\text{Nb}_{1/3}^{0}_3$ и (Gr. Bi $_{2/3}$) TiO

для твердых растворов системы (Bi_{2/3},Sr)тіо₃ из-за наличия у них структурных дефектов в виде вакансий в подрешет-ке Bi-Sr. В случае других систем твердых растворов различие результатов СВЧ и низкочастотных измерений $\varepsilon(T)$ в параэлектрической фазе обычно наблюдается лишь при высоких температурах, когда в связи с ростом концентрации свободных носителей электрического заряда значительный вклад в низкочастотную диэлектрическую проницаемость поликристаллов начинает вносить механизм межслойной поляризации.

В. Выполнение обобщенного закона Кюри-Вейсса в параэлектрической фазе

На рис.7+9 приведены экспериментальные зависимости $\frac{1}{\mathcal{E}-\mathcal{E}_L}(T)$, построенные после соответствующей обработки исходных зависимостей $\frac{1}{2}(T)$, т.е. после определе-

ния соответствующих вначений параметра 🐔

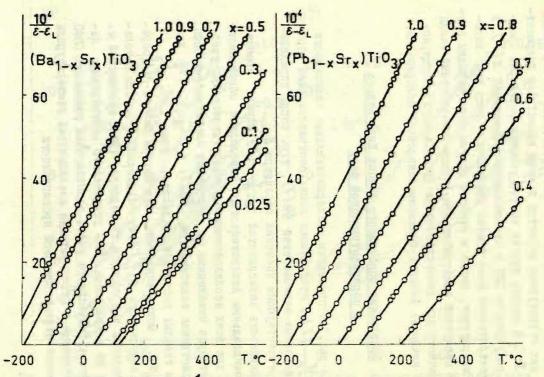
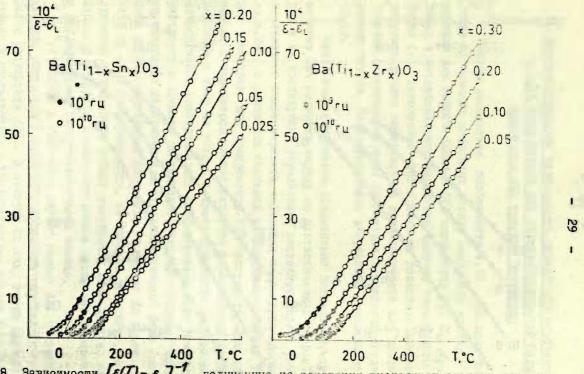


Рис.7. Зависимости $[\mathcal{E}(T) - \mathcal{E}_L]^{-1}$, полученные на основании экспериментальных зависимостей $\mathscr{V}_{\mathcal{E}}(T)$, для твердых растворов систем $(\mathcal{B}\alpha, \mathcal{S}r)\pi\mathcal{O}_3$ и $(\mathcal{P}b, \mathcal{S}r)\pi\mathcal{O}_3$



0 200 400 Т.°С 0 200 400 Т.°С
Рис.8. Зависимости [ε(Т)-е,]⁻¹, полученные на основании экспериментальных зависимостей ∜ε (Т), для твердых растворов Ва(Ті,Sn)О3 и Ва(Ті,Zr)О3

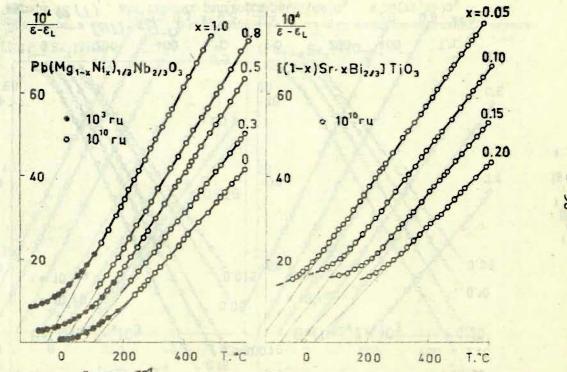


Рис.9. Зависимости $[\varepsilon(T)-\varepsilon_i]^{-1}$, полученные на основании экспериментальных зависимостей $\frac{1}{\varepsilon}(T)$, для твердых растворов $\text{Pb}(\text{Mg,Ni})_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$ и $(\text{Sr,Bi}_{2/3})\text{TiO}_3$

Г. Концентрационная зависимость параметров обобщенного закона Кюри-Вейсса для паравлектрической фазы исследованных твердых растворов

Четкое выполнение обобщенного в.КВ для всех исследованных веществ позволяет решить следующую задачу — определение для любого данного СТР параметров T_0 , C_{w} , \mathcal{E}_{L} , входящих в математическое выражение закона, записанного в форме (1). Выполнение этой программы позволило впервые обнаружить вполне определенные закономерности для концентрационных зависимостей этих параметров в пределах исследованных систем. Соответствующие результаты отражены на рис. 10+12.

Полученные результаты убедительно показывают, что применение СВЧ методики наряду со статистическим сбором данных и их последующим усреднением позволяет вполне уверенно исследовать закономерности поведения параметров обобщенного в.КВ в различных системах сегнетоэлектрических твердых растворов. Для конкретного СТР соответствующие значения этих параметров закона являются характерными величинами. Если к тому же учесть большие трудности изготовления качественных монокристаллов рассмотренных нами твердых растворов и принять во внимание, что исследование основного механизма поляризации в параэлентрической фазе быть вполне достоверно проведено не только на монокристаллах, но и на поликристаллах, то следует заключить, что полученные в настоящей работе результаты дают ценную мацию об основном ионно-электронном механизме поляризации в перовскитовых сегнетоэлектриках вообще.

Приводимые в настоящей работе данные для системы твердых растворов (Ba,Sr)TiO3 дополняют сообщенные нами ранее результаты /25/. В отличие от них, новые данные получены в соответствии с представлением закона Кюри-Вейсса в обобщенной форме (с учетем параметра ϵ_{ℓ}), а также содержат коррекцию на пористость керамики. Однако ввиду четкого характера ФП этих твердых растворов и примерно

одинакового качества исследуемых образцов /их пористости //о /, эти уточнения лишь немного изменяют приведенные ранее абсолютные значения постоянной Кюри-Вейсса С_и, не меняя качественный ход соответствующей концентрационной зависимости.

При исследованиях твердых растворов системы (Pb,Sr)т103 некоторые трудности доставила известная проблема изготовления качественных образцов с высокой концентрацией титаната свинца. Поэтому в настоящей работе отсутствуют надежные данные в этой области концентраций. Весьма характерно, что наблюдается линейное уменьшение значений С с ростом концентрации титаната стронция. Если предпринять вистраполяцию на основании определенной нами концентрационной зависимости постоянной Кюри-Вейсса С в область относительно больших концентраций титаната свинца, то нет никаких противоречий с данными, известными для монокристаллов чистого РоТ О 2 /26/.

Концентрационные зависимости параметров обобщенного в.КВ для твердых растворов Ве(Ti,Sn)O₃ и Ве(Ti,Zr)O₃ определены только в интервале предполагаемого существовения твердых растворов. Концентрационная зависимость постоянной Кюри-Вейсса С_м при этом в пределах погрешностей соответствует нелинейному монотонному закону изменения, где С_м уменьшается при постепенном замещении иснов Ті иснами Zr или Sn . Нелинейна также концентрационная зависимость температуры Кюри-Вейсса.

Для системы Ва(Т1, Sn)О3 полученные в настоящей работе данные о концентрационной зависимости Сw не согласуются с результатам работы /I/, в которой заключение об увеличении значений Сw с ростом концентрации ВазиО3 явилось следствием определения зависимости с (Т) только в пределах области РФП, а не в параэлектрической фазе твердых растворов.

Особый интерес представляет определение постоянной См для чистого ВаТ103, учитывая то, что литературные данные дают весьма сильный равброс вначений этой величины. Час-

тично это объясняется довольно плохой воспроизводимостью свойств чистого титаната бария как в монокристаллическом, так и в поликристаллическом виде. Поэтому чистый ВаТі Оз нами в настоящей работе не исследовался, а соответствующие значения параметров обобщенного в.КВ определялись путем экстраполяции концентрационных зависимостей для твердых растворов, содержащих титанат бария в качестве одной из компонент. Определенное таким образом значение постоянной Кюри-Вейсса См = I, I5·10⁵ град в пределах погрешностей корошо совпадает при экстраполяции для всех трех систем твердых растворов, содержащих титанат бария. Найденное значение хорошо согласуется также с результатами исследования поликристаллического титаната бария другими авторами, тоже использующих СВЧ методику определения зависимости в (Т): См = (I, 20+1, 28)·10⁵ град /4,5,27/.

В связи с имеющимся в литературе весьма значительном разбросе значений постоянной Кюри-Вейсса следует иметь виду, что приводимые различными авторами абсолютные значения С могут отличаться из-за сильного влияния различных технологических факторов при изготовлении образцов. Принимая во внимание кроме того немалую роль метода определения зависимости є (Т) и способа обработки экспериментальных данных, наблюдаемый разброс результатов находит вполне естественное объяснение. По-видимому, в этой связи следует указать на некоторое достоинство настоящей работы, которое заключается в обеспечении высокой точности определения именно относительных значений соответствующих параметров, позволившее обнаружить приводимые концентрационные вависимости. Очевидно, что при этом значительную роль имело соблюдение одних и тех же основных технологических условий при изготовлении исследуемых образцов, а также единство метода определения зависимости & (Т) и способа обработки экспериментальных данных.

Проверка выполнения обобщенного з.КВ и определение соответствующих его параметров для систем твердых растворов ((Bi_{2/3}, Sr)TiO₃ и Pb(Mg,Ni)_{1/3}Nb_{2/3}O₃ проведено

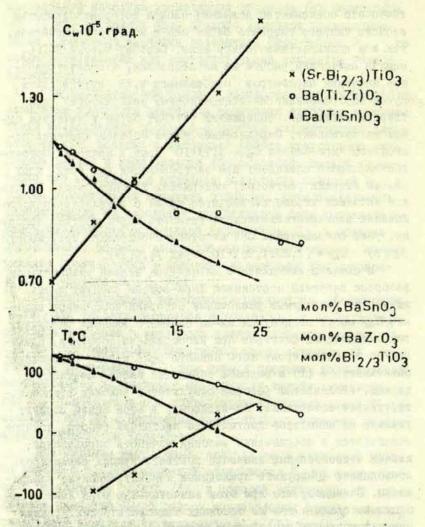


Рис.II. Концентрационные зависимости постоянной (C_W) и температуры (7_0) Кюри-Вейсса для систем Вв $(\text{Ti}, \text{Sn})0_3$, Вв $(\text{Ti}, \text{Zr})0_3$ и $(\text{Sr}, \text{Bi}_{2/3})\text{Ti}0_3$

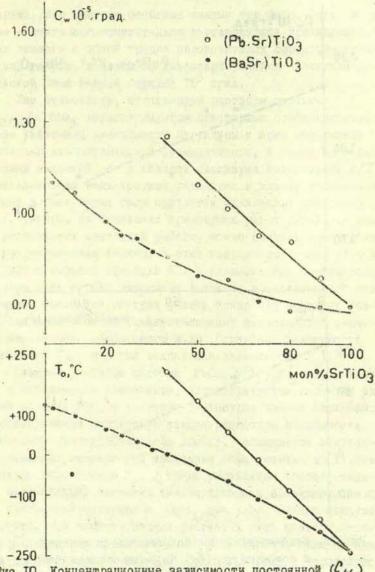


Рис. IO. Концентрационные зависимости постоянной (\mathcal{C}_{W}) и температуры (\mathcal{T}_{0}) Крри-Вейсса для систем (Ва,Sr)ТіО 3 (Рь,Sr)ТіО 3

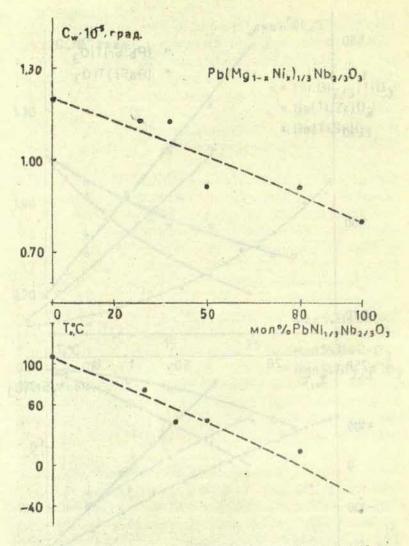


Рис. I2. Концентрационные зависимости постоянной (C_W) и температуры (T_0) Кюри-Вейсса для системы $Pb(Mg,Ni)_{1/3}Nb_{2/3}O_3$

впервые. Нам кажется особенно важным тот факт, что и в этом аспекте экспериментально подтвердилась принадлежность этих веществ к общей группе перовскитовых сегнетоэлектри-ческих твердых растворов, характеризующейся значением постоянной Кюри-Вейсса порядка 10⁵ град.

Уже отмечалось, что твердые растворы системы (Bi2/3, Sr)ті03 характеризуются некоторыми особенностями. Из-за указанной дефектности структуры и ярко выраженной дисперсии диэлектрической проницаемости, а также не очень высоких значений є в области максимума зависимости є (Т). принадлежность этих твердых растворов к классу сегнетоэлектриков в свое время была предметом оживленных дискуссий /28/. Теперь, на основании предыдущих работ /29+3I/, а также результатов настоящей работы, можно считать экспериментально доказанным наличие в этих твердых растворах размытого СЭФП с широкой областью ФП. В размытии ФП. по-видимому. немалую роль играют имеющиеся вакансии в подрешетке Ст этих веществ. Последние следует учесть также при попытках объяснения особенностей концентрационных зависимостей значений параметров обобщенного з.КВ (линейная зависимость постоянной С и резко нелинейная зависимость Т.).

Твердые растворы системы Рь(Mg,Ni)_{1/3}Nb_{2/3}O₃, также как и исходные ее компоненты, характеризуются наличием широкой области РФП, а значения параметров закона Кюри-Вейсса обнаруживают монотонную концентрационную зависимость. С изменением концентрации, как обычно, наблюдается монотонное смещение температуры максимума зависимости & (Т), температуры Кюры-Вейсса То, а также уменьшение соответствующих максимальных значений диэлектрической проницаемости емпри увеличении содержания Рымі_{1/3}Nb_{2/3}O₃. Однако следует отметить, что синтев твердых растворов этой системы отличается некоторой сложностью, ибо очень часто, если не принять соответствующие меры, в образцах наряду с перовскитом вой фазой наблюдается также фаза со структурой пирохлора. В этой связи при исследовании данной системы для всех образцов был проведен рентгеновский фазовый анализ и стобра-

ны лишь те, которые имели одинаковое минимальное содержание "посторонней" фазы (порядка 7+8%).

Пока еще ничего не говорилось о значениях и концентрационной зависимости параметра \mathfrak{E}_L , представляющего собой температурно независимую часть полной диэлектрической проницаемости. В этой связи следует отметить, что соответствующие вначения для различных образцов одного и того же состава характеризуются весьма сильным разбросом в пределах от 25 до 45, а на основе рассмотрения их усредненных значений можно полагать, что этот параметр имеет примерно одинаковое значение $\mathfrak{E}_L = 35$ для всех исследованных систем твердых растворов и не зависит от их состава и концентрации. Этот результат также находится в хорошем согласии с работами /4,5/.

Д. <u>Особенности поведения зависимости є (Т)</u> в области размытых СЭФП

Отклонение зависимости (7) от примой в области более низких температур исследованного интервала можно рассматривать как вступление в область размитого СЭФП, в пределах которой поведение физической системы уже существенно отличается от поведения в параэлектрической фазе вещества (рис.7+9). При этом следует ожидать, что обобщенный з.КВ в этой области не выполняется, что действительно и наблюдается на опите.

Мэ рассмотрения рис.7+9 следует, что ширина области размытия СЭФП в аспекте диэлектрических измерений для различных систем исследованных твердых растворов различается и по-разному вависит от их концентрации. Весьма четко выделяются системы с относительно узкой ((Ba,Sr)TiO₃, (Fb,Sr)TiO₃) и широкой ((Bi_{2/3},Sr)TiO₃, Pb(Mg,Ni)_{1/3}No₃) областью ФП. В третью группу можно выделить системы с переменной шириной области (Ba(Ti,Zr)O₃, Ba(Ti,Sn)O₃). Повидимому, вамещение ионов в подрешетке В более сущест-

венно сказывается на ширину области размытия ФП, чем соответствующие замещения в подрешетке А (при общей формуле кислородных перовскитов АВО3). Наличие широкой области размытого СЭФП у твердых растворов системы (Ві2/3, Sr)тіО3 имеет более сложную природу, ибо, как уже отмечалось, последние из-за гетеровалентного замещения в подрешетке А обладают также некоторой концентрацией вакансий в этой же подрешетке. Переменную ширину области размытия ФП в случае твердых растворов систем Вв(Ті, Zr)О3 и Вв(Ті, Sr)О3 можно связать с тем, что в этом случае исходное вещество ватіО3 обладает малой шириной этой области, в то время как ваго3 и вазло3 вовсе не являются сегнетоэлектриками.

В связи с обнаруженной в работе /6/ квадратичной зависимостью типа $V_{\mathcal{E}(T)} = A + B(T - T_m)^2$ у перовекитов сложного состава типа рьм $g_{1/3}$ мь $_{2/3}$ о $_3$ в пределах области РФП нами было более подробно исследовано выполнение этой закономерности в ряде других систем СТР. Некоторые результаты этого исследования иллюстрируются на рис. I3, где по построенным графикам $V_{\mathcal{E}(T-T_m)}$ и $V_{\mathcal{E}(T-T_m)^2}$ можно судить о выполнении той или иной зависимости. Следует отметить, что при этом, как и прежде, использовались не непосредственные экспериментальные точки зависимостей $V_{\mathcal{E}(T)}$, а точки из графически сглаженной экспериментальной кривой.

Наши результаты полностью подтверждают выполнение указанной выше квадратичной зависимости поведения 1/ε(Т) для соединений Ръмба 1/3 Nb 2/3 в отдельности (рис. 13), а также в пределах системы твердых растверов этих соединений. Однако в то же время оно не имеет места для твердых растворов остальных систем. Системы твердых растворов остальных систем. Системы твердых растворов с узкой областью РФП в этом аспекте не рассматривались.

Область размытых СЭФП карактеризуется также дисперсией диалектрической проницаемости в широком диапазоне частот. Эта проблема нами подробно не исследовалась, если не считать сравнения данных контрольных измерений в диа-

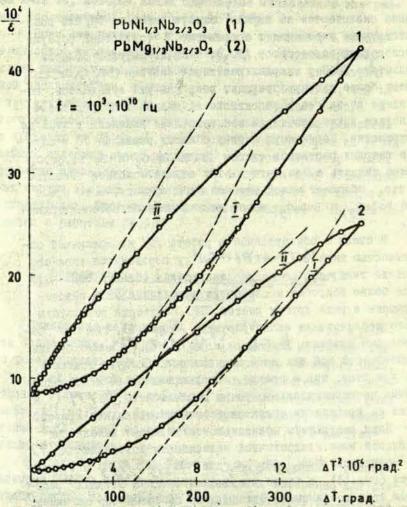
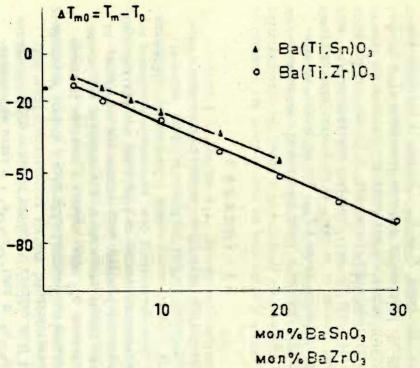


Рис. 13. Вависимости (с/аТ) (I) и (с/аТ) (II), где аТ-Тт, демонстрирующие, соответственно, выполнение квалратичной зависимости в области РФП и обобщенного з.КВ в парафазе для соединений РФМд (3 Nb2/3 O3 и РБN1-/3 Nb2/3 O3. (Пунктиром показаны экстраполяции, соответственно, квадратичной и квазилинейной зависимостей вне области их экспериментального подтверждения)



пазоне частот $10^2 + 10^4$ гц с результатами основных измерений, проводимых на СВЧ.

Наконец, определенное внимание привлекает наблюдаемое обращение знака разности температур Кюри-Вейсса T_0 и
температур максимума T_m в зависимости $\varepsilon(7)$. Для всех исследованных систем твердых растворов с широкой областью
размытого СЭФП имеем $T_0 > T_m$. На рис. 14 приведена концентрационная зависимость разности температур $\Delta T_{mo} = T_m - T_0$ для некоторых систем твердых растворов (температура T_m соответствует максимуму зависимости $\varepsilon(T)$ при частоте измерительного поля 10^5 гц). Поскольку температура T_m в
случае РФП зависит от частоты, то от частоты зависит также эффект обращения знака ΔT_{mo} . Это обращение, по-видимому, следует отнести к числу характерных особенностей
размытых СЭФП.

SAK J W 4 E H M E

Резимируя вышеизложенные результаты проведенного исследования, можно сделать следующие основные выводы:

- для є(Т)воех исследованных перовскитовых сегнетоэлектриков в паравлектрической фазе выполняется обобщенный закон Кюри-Вейсов независимо от конкретных особенностей СЭФП;
- 2) в области размития СЭФП наблюдается отклонение от обобщенного закона Кюри-Вейсса, а температура наступления этого отклонения Т_{гр} может служить в качестве указателя нижней границы паравлектрической фазы в аспекте дивлектрическом фазы в аспекте дивлектрическом исследований;
- 3) в ряде случаев в области размытия СЭФП (соединения $PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O_3$ и $PbNi_{1/3}Nb_{2/3}O_3$, а также их взаимные твердые растворы) вависимость $\frac{1}{2}(T)$ описывается квадратичным выражением типа $\frac{1}{2}(T) = A + B(T T_m)^2$, однако оно не является универсальным для всех исследованных систем твердых растворов;

⁴⁾ для всех исследованных систем СТР установлена но-

нотонная концентрационная зависимость значений характерных параметров обобщенного закона Кюри-Вейсса C_w и T_0 , а значение параметра \mathcal{E}_L в пределах погрешностей работы оценивается величиной \mathcal{E}_L = 35, независимо от состава и концентрации твердых растворов;

5) применение описанной методики исследований поэволяет успёшно вести изучение основных диэлектрических
свойств поликристаллических сегнетоэлектриков и вполне
надежно определить их количественные характеристики,
обеспечивая этим получение важной информации для совокупного комплексного рассмотрения физических свойств поликристаллических сегнетоэлектриков.

Принимая во внимание, что исследованные вещества являются типичными представителями неровскитного класса сегнетовлектриков, можно с достаточной уверенностью распространять эти внводы также на весь класс в целом.

JUTE PATYPA

- Смоленский Г.А., Исупов В.А. Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов станната бария в титанате бария. - "Журнал технической физики", 1954, т.24, вып.8, с. 1375-1386 с илл.
- 2. Смоленский Г.А., Розгачев К.И. Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов в системе титанат бариятитанат стронция.— "Журнал технической физики", 1954, т.24, вып. 10, с. 1751-1760 с илл.
- Кізака S., Ікедаті І., Sазакі Н. Диэлектрические свойства монокристаллических твердых растворов (Ва, Sr)ТіО₃. - J. Phys. Soc. Japan., 1959. v. 14, No. 12, p. 1680-1685.
- 4. Rupprecht G., Bell R.O. Диэлектрическая проницаемость параэлектриков перовскитого типа. Phys. Rev., 1964, v#135, Na.3A, p#748-752.

- 5. Ветье К. О поведение нелинейных диэлектриков в диалавоне СВЧ. - Philips Res. Repts. Suppl., 1970, № 2.
- 6. Кириллов В.В., Исупов В.А. Исследование диэлектрической поляризации Ръмв_{1/3}Nъ_{2/3}O₃ в диапазоне частот 10⁻²+10⁵ гц. "Известия АН СССР. Сер.физ." 1969, т.33. № 2. с.313 с илл.

7. Исупов В.А. К вопросу о причинах образования области Кори в некоторых сегнетовлектрических твердых растворах.-"Журнал технической физики", 1956, т. 26, вып. 9, с. 1912-1916 с илл.

- Фрицберг В.Я., Ролов Б.Н. О некоторых факторах, определяющих карактер сегнетовлектрического факсиого перехода. "Известия АН СССР. Сер.физ." 1964, т.28, № 4, с.649-652.
- 9. Исупов В.А. К объяснению некоторых свойств сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом. - "Известия АН СССР. Сер. физ." 1964, т.28, № 4, с.653-657 с илл.
- 10. Фрицберг В.Я. Роль фазовых флуктуаций при сегнетовлектрических фазовых переходах в твердых растворах со структурой типа перовскита.—"Физика твердого тела", 1968, т.10, № 2, с. 385-390.
- II. Вакс В.Г. Корреляционные эффекты при фазовых переходах типа смещения в сегнетовлектриках. Препринт Ин-та Атомной энергии-1877, М., 1969, 22с. с илл.
- 12. Рез А.И. Исследование термодинамических функций методом самосогласованного поля. Автореферат канд. диссертации. Московский физ.-техн.ин-т. 1972.
- 13. Ролов Б.Н. Размитме фазовые переходы. Рига, "Зинатне", 1972, 311 с. с илл.
- 14. Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнетовлектринов типа титаната бария. Рига, "Зинатне", 1971, 225 с. с илл.

- 15. Брок А.Я. Метод резонанса короткозамкнутого отрезка линии передачи для СВЧ исследований сегнетоэлектриков. Рига, Изд. ЛГУ им.П.Стучки, 1972, 147 с. с илл.
- 16. Шубников А.В., Желудев И.С., Константинова В.Л., Сильвестрова И.М. Исследование пьезовлектрических текстур. М.-Л., Изд. АН СССР, 1955, с. 132.
- Смоленский Г.А., Боков В.А., Исупов В.А. и др. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Л., "Наука", 1971, 475 с. с илл.
- 18. Вербицкан Т.Н., Жданов Г.С., Веневцев Ю.Н., Соловьев С.П. Электрические и рентгенографические исследования системы ватто Ваггоз "Кристаллография", 1958, т.3, вып.2, с. 186-196.
- Вербициан Т.Н., Александрова Л.М., Синицина Л.С.
 Влияние окислов хрома на электрические свойства
 титаната бария. В кн.: Физика диалектриков.
 Изд. АН СССР, М., 1960.
- 20. Сканави Г.И., Ксендзов Я.М., Тригубенко В.А., Прохватилов В.Г. Релаксационная полиризация и потери в несегнетовлектрических дивлектриках с высокой дивлектрической проницаемостью. "Журнал экспериментальной и теоретической физики", 1957, т. 33, вып. 2(8), с. 320-333.
- 21. Смоленский Г.А., Тарутин Н.П., Трудцин Н.П. Сегнето-; лектрические свойства твердых растворов цирконата бария в титанате бария. — "Журнал технической физики", т.24, вып.9, с 1584-1593.
- 22. Новосильцев Н.С., Ходаков А.Л. Диелентрические свойства некоторых твердых растворов, содержащих титанат барин. "Журнал технической физики", 1956, т. 26, вып. 2.
- 23. Боков В.А. К вопросу о природе высокой диэлектрической проницаемости некоторых твердых растворов, обладающих сегнетоэлектрическими свойствами. - "Турнал т технической физики", 1957, т.27, вып.8, с.1784-1793.

- 24. Смоленский Г.А., Аграновская А.И. Диэлектрическая поляризация ряда соединений сложного состава. "Физика твердого тела", 1959, т. 1, выр. 10, с. 1562-1572.
- 25. Брок А.Я., Вецсиле З.А. Концентрационная зависимость постоянной Кюри-Вейсса в поликристаллических твердых растворах системы (Ва, Sr)ТіО 3. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971, с. 109-115.
- 26. Фесенко Е.Г., Гавриляченко В.Г., Зароченцев Е.В. Сегнетоэлектрические свойства монокристаллов титаната свинца. "Известия АН СССР.Сер.физ.", 1970, т.34, № 12, с.2541-2549.
- Поплавко Ю.М., Цыкалов В.Г. Исследование антисетнетовлектриков на миллиметровых волнах. - "Физика твердого тела", 1967, т.9, вып.11, с.3305-3310.
- 28. Вогданов С.В., Киселева К.В. О природе диэлектрических свойств твердых растворов srTiO₃·Bi₂O₃·3TiO₃. -"Известия АН СССР. Сер.физ.", 1964, т. 28, № 4, с 636-642.
- Смоленский Г.А., Исупов В.А., Аграновская А.И., Попов С.Н. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом. - "физика твердого тела", 1960, т. 2, вып. 11. с. 2906.
- 30. Фрицберг В.Я. Природа диэлектрической поляризации и особенности сегнетоэлектрических фазовых переходов в твердых растворах систем "Рьт103-Бт2/3т103" Автореферат канд. диссертации. Ленинградский ПИИ им.А.И.Герцена, 1961.
- 31. Круминь А.Э. Исследование динамики поляризации сегнетоэлектрических твердых растворов типа перовскита в широкой области температур, напряженностей и времен действин электрического поля. – В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971, с. 155-204.

Фрицберг В.Я., Гринвалд Г.Ж., Гаевский А.П.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ ТИПА ТИТАНАТА БАРИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВЫШЕ ТОЧКИ КЮРИ

ВВЕДЕНИЕ

Настонщая работа посвящена исследованию диэлектрической нелинейности выше точки Кюри в двух системах сегнетоэлектрических твердых растворов (СТР) на базе титаната барин — $(\mathcal{B}\alpha, Sr) \pi O_3$ и $\mathcal{B}\alpha/\pi, Sn)O_3$. Постановка проблемы проводится однако в более широком плане и экспериментальные данные сопоставляются с рядом теоретических выводов. Как будет показано ниже, в свете результатов, полученных на твердых растворах, под новым углом врения могут быть рассмотрены проблемы, актуальные для сегнето-электриков типа титаната бария вообще.

Отметим, что под диэлектрической нелинейностью обучно погимается отклонение от линейности зависимости Р(Е), существующей между поляризацией Р и напряженностью электрического поля Е. Другими словами, имеется в виду зависимость от поля диэлектрической восприимчивости ж (Е) или, соответственно, проницаемости & (Е).

В последнее время изучение нелинейности в неполярной фазе привлекает все большее внимание. С точки зрения физики сегнетоэлектриков это обусловлено тем, что явление поляризации во внешнем поле здесь происходит, как бы, в более простых условиях (отсутствуют домены) и его легче изучать. С практической точки врения важно то, что ввиду

отсутствия доменной структуры вдесь малы электрические потери на переполяризацию в переменном поле, но в то же время сохраняется возможность в некоторых пределах управлять диэлектрической проницаемостью с, которая в связи с нелинейностью поляризации оказывается зависящей от внешнего поля.

Анализ явлений нелинейности в неполярной фазе перовскитов проведен в ряде работ (см. Обвор литературы) однако подход к проблеме в большинстве работ носит эпизодический жарактер. В качестве теоретической основы используется феноменологическая теория Девоншира-Гинзбурга (Д.-Г.) /1,2/, но в последнее время делаются попытки включить в рассмотрение и микроскопические аспекты проблемы /29,30/.

В исследуемых нами СТР, принадлежащих к структурному типу перовскита, как известно, имеет место фазовый перекод (ФП) І рода из тетрагональной фазы в кубическую. В
центре внимания работы находилось поведение диэлектрической восприимчивости (проницаемости) под действием поля в
области температур неполярной (кубической) фазы. Учитывая
инваистатические условия проведения опыта, мы считали
возможным в качестве теоретической базы использовать разложение термодинамического потенциала по степеням поляривации в обычной форме теории Д.-Г.

С точки врения классической теории ФП в своеобразном свете возникает проблема о характере фазового перехода. Действительно, выше определенных значений параметров Т * Тир и Е * Екр исчезает скачок спонтанной поляризации, являющийся признаком ФП I рода. Критерий ФП II рода вообще отпадает, так как при Е # О отсутствует температурная точка, в которой скачкообразно могла бы измениться симметрии (поле индуцирует полярную симметрию также в кубической фазе). В то же время вещество в широком интервате температур несомненно пребывает в некотором особом состоянии, так как обладает значительной нелинейностью при полном отсутствии доменного строения.

§I. Обзор литературы. Постановка задачи.

Диалектрическая нелинейность — отклонение от диней—
ности связи, существующей между поляризацией Р и напря—
женности внешнего электрического поля Е — является фунда—
ментальным свойством сегнетовлентриков. Возникновение
спонтанной поляризации при достижении определенной темпе—
ратуры Т_С — оледствие нелинейности, которая в сильной
степени проявляется уже в неполярной фазе вещества (Т>
Т_С), задолго до сегнетовлектрического фазового перехода
(СЭФП). Характер СЭФП, таким образом, оказывается тесно
связанным с особенностями нелинейности в неполярной фазе.

Принципы описания нелинейности поляризации содержатся в основоположных работах по феноменологической теории сегнетовлектриков Девоншира-Гинзбурга /I,2/. Достаточно подробному изучению нелинейности в неполярной фазе у перовскитовых сегнетовлектриков посвящено сравнительно мало работ; в основном они относятся к монокристаллам титаната бария /3-9/. Эпизодически этот вопрос рассмотрен в монографиях, см., например, /II-I5/.

Накопленний опыт показывает, что исследование нелинейности в неполярной фазе у веществ типа титаната бария,
несмотря на намущуюся простоту постановки задачи, является достаточно сложной проблемой. Наиболее важным параметром для количественной оценки нелинейности является коэффициент В (при учете анизотропии нелицейности следует
различать два коэффициента: В, и В,), стоящий наряду
с некоторым числовым коэффициентом перед Р в разложения
термодинамического потенциала на перед Р в разложения
обратной восприимчивости в по степеням поляризации при
т > Т_с (см. §1). Оназывается, что корректное измерение
этого параметра (так называемого коэффициента нелинейности) наталкивается на некоторые трудности, котя предложен

^{*)} В записи Девоншира, которой мы последовательно придерживаемся, этот коэффициент равен 1/4.

ряд методов для его определения (см., например, обзор в /II/). В результате для монокристаллов ВаТі О3 наблюдается разброс полученных значений порядка 25% (см. /9, IO/).
Последнее говорит о том, что исследуемое явление, очевидно, сильно зависит от условий проведения эксперимента с
одной стороны, и от особенностей конкретного изучаемого
объекта — с другой. При сопоставлении результатов теоретических исследований с экспериментом для монокристаллов
ВаТі О3 часто используются данные о коэффициентах нелинейности, приведенные в /II/ для "свободного" кристалла
(ед. СГСЭ):

$$\beta_1 = 1.8 \cdot 10^{-14} \text{ (T - T_2)}; \quad T_0 = 119^{\circ}\text{C}; \quad \beta_1(T_0) = -1.0 \cdot 10^{-12}$$

$$\beta_2 = 1.2 \cdot 10^{-12}; \quad T_2 = 175^{\circ}\text{C};$$

При уточнении условий измерения весьма важно, является ли образец "овободным" или "зажатым" по отношению к измерительному и смещающему полю. Так для монокристаллов титаната бария "свободных" в отношении обеих полей оказывается $\beta_4 < 0$, а "зажатых" по отношению к измерительному полю - $\beta_4 > 0$ /8/. Поправка на "зажатие" в монокристалле Ватi03, воливи T_0 при полном подавлении электрострикционных деформаций, как показано в работе /6/, достигает величины $3 \cdot 10^{-12}$, что, как мы видим, сравнимо с абсолютной величиной коэффициента нелинейности у "свободного" кристалла.

Большое влияние может оказать электропроводность образца, если она больше некоторого допустимого предела, так как смещающее поле оказывается экранированным /7/.

В принципе следует учитывать также адиабатичность условий измерения в переменных полях, однако оценка покавывает, что поправка на адиабатичность составляет величину порядка 10⁻¹⁴ CPC9 /4/ и может быть опущена.

Значительно больший разброс данных о величине β набигдается у сегнетокерамики. В работе /16/ для титаната

ж) Вследствии макроскопической изотропии для описания нелинейности в данном случае достаточно одного коэффициента В.

бария получено $\beta = +(4+5) \cdot 10^{-12}$ огоз; в работе /17/ на основании измерений в стационарном режиме $\beta = +(5+10)$ х х 10^{-12} , в импульсном режиме $\beta = -2,2\cdot 10^{-12}$ /18/, а в работе /19/, где применялось НЧ смещающее поле $\beta = +(0,2+2)\cdot 10^{-12}$. Естественно возникает вопрос о причинах столь вначительного разброса данных.

Во-первых, отметим, что у монокристаллов ВаТ \cdot О $_3$ установлена положительная линейная температурная зависимость коэффициента $\beta_i/5$,8/. В приведенных выше работах по керамике ВаТ \cdot О $_3$ /16+19/ измерения проводились при различных температурах Т > Т $_{\rm C}$, однако это различие (пределы интервала Т - Т $_{\rm C} \approx 5 \div 20^{\circ}$) не должно приводить к такому большому разбросу данных.

Далее заметим, что феноменологическая теория Д.-Г. (в соответствии с которой рассчитывается коэффициент В,) в ее обычной форме пригодна для подстановки экспериментальных данных, полученных только в стационарном (квазистационарном) режиме измерений. Такин образом, оценка непинейности, которая, например, изучается в режиме кратковременных импульсов внешнего поля, в общем случае, требует дополнительного учета временных зависимостей, характерных для переходных процессов. Эта оговорка может быть существенной при анализе результатов работы /18/.

Потенциальным источником разброса данных в керамике могут оказаться также эффекты захатия отдельных кристаллитов, котя, как правило, измерения в работах /16-19/, для образца как целого проводились в условиях "свободного" кристалла. Такое локальное зажатие, которое следует рассматривать как физическую неоднородность, может возникать уже в процессе синтеза образца. Заслуживает внимания также высказанное в работе /18/ предположение о возможном понижении вначения с на границах кристаллитов и возникновении межслойной поляризации.

В большой мере на разброс результатов измерений должна сказываться неоднородность фазового состава в температурной области СЭФП. Опыт показывает, что, например, в системе СТР системы (Ва, \$\mathbb{S}^{2}\) Тооз при определенных условиях синтеза получаются образцы, у которых сохраняются
крупные островки полярной фазы (порядка нескольких мкм)
при температуре 20 и больше градусов выше температуры Т_м,
соответствующей максимуму проницаемости и отождествляемой
с температурой СЭФП /20/. В таких образцах остатки полярной фазы могут вызвать эффект прохождения через максимум
вависимости & (E) ^М) при некоторой Т > Т_м, в результате
чего возможен недостаточно обоснованный вывод о знаке коэффициента В. Поэтому контроль керамических образцов на
фазовую однородность при температурах выше Т_м приобретает
первостепенную важность для получения одновначных данных
о нелинейности. Попутно отметим, что такой контроль однородности о достаточной уверенностью может быть проведен
методом, описанным в /20/, или предложенным нами в /22/.

Наконец, отметим еще одно немаловажное обстоятельство, которое следует учитывать при сравнении данных о нединейности для монокристаллов и поликристаллов в неполярной фазе вблизи СЭФП. Мы имеем в виду эффекты корреляции, которые для он типа смещения в теоретическом плана были исследованы Ваксом и др. /23+25/. В этих работах подробно анализируется взаимосьязь эффектов корреляции с характером ФП в сегиетовлектриках со структурой перовскита и, в частности, определены так называемые корреляционные поправки для коэффициентов классического разложения термодинамического потенциала типа Д.-Г. (включая коэффициенты нелинейности). Из результатов указанных работ следует вывод, что карактерные признаки ФП I рода (в том числе отрицательное значение коэффициента 🔏) непосредственно связаны с корреляционными эффектами, которые в сегнетоэлектриках типа титаната бария не малы.

Следует обратить внимание на то, что эффекты корреляции и вместе с тем особенности характера ФП в большой

^{. *)} В полярной фаве такое явление корошо известно, (см., например, /21/).

мере определяются микроструктурой объектов при идентичности их химического состава. Об этом, в частности, свидетельствует различие в степени размытия СЭФП, при сравнении хороших монокристаллов ВаТ(О3 с керамикой, а также при сравнении между собой образцов керамики, которые значительно отличаются в отношении их кристаллитной структуры /26/. В последней работе содержатся убедительные доказательства того, что подавление эффектов корреляции ведет к увеличению размытия СЭФП и утрате характерных признаков ФП Т рода.

Необходимо подчеркнуть, что в цитированных выше расотах по монокристаллам ВаТ (0_3) измерение \mathcal{B} , проводилось в небольших смещающих полях (E < 5 кв·см $^{-1}$) и вблизи СЭФП ($T - T_c$ порядка 10^0), где корреляционные эффекты по-видимому и обуславливают картину, характерную для ФП I рода. К особенностям такой картины относится индуцирование внешним полем фазового перехода и скачка спонтанной поляривации при некоторой температуре T, где $T_c < T < T_{\rm KP}$ (появление "двойных" петель гистеревиса в достаточно сильном переменном поле). Если температура T в указанном интервале задана, то при достижении определенной напряженности E, где $0 < E < E_{\rm KP}$ весь кристалл практически одновременно испытывает индуцированный ФП /28/. Детали этого явления определяются ориентацией поля E по отношению к кристаллографическим направлениям /5/.

В керамике, как правило, наблюдается другая картина, даже если образцы максимально однородны (к чему следует стремиться при синтезе) и имеют оптимальную кристаллитную структуру, обеспечивающую минимальное искажение эффектов корреляции по сравнению с монокристаллом. Действительно, в керамике, ввиду того, что вектор внешнего поля Е оказывается хаотически ориентирован в отношении кристаллографических направлений отдельных упорядоченных комплексов элементарных ячеек, скачки спонтанной поляризации в этих микроучастках при данной температуре Т > Т_С происходят при различных по величине Е. Поэтому индуцированный ФП — для

образца в целом - размывается и макроскопическое проявление этого эффекта в виде скачка, как правило, отсутствует.

Нет необходимости доказывать, что аналитическое описание температурного поведения нелинейности в поликристалле с одновременным учетом её микроскопической анизотропии (см. §2) и корреляционных эффектов, крайне затруднительно. Ограничимся констатацией, что интервал значений параметров, где $T < T_{KD}$ и $E < E_{KD}$ является своеобразным интервалом "неопределенности", поэтому проводя измерения на керамических образцах в слабых полях смещения и при малых значениях $T - T_C > 0$ нельзя рассчитывать на получение данных о коэффициенте \mathcal{S} , представляющих фундаментальные свойства вещества. Очевидно, преследуя цель выявления именно таких свойств — концентрационной зависимости $\mathcal{S}(x)$ для системы твердых растворов или температурной зависимости $\mathcal{S}(T)$ для данного состава — следует по возможности выйти из области СЭФП и проводить измерения при значениях параметров $T > T_{KD}$ и $E > E_{KD}$, где, в частности, возникновение индуцированных СЭФП невозможно.

Наконец, весьма существенно, что при такой постановке опыта исключаются характерные черты ФП I рода и это обстоятельство позволяет выдвинуть предположение, что для описания явлений нелинейности в указанной области достаточно математического аппарата, используемого в феноменологической теории ФП II рода. Действительно, отсутствие скачка спонтанной поляризации приводит и тому, что В>0, и по сути дела отпадает необходимость в разложении потенциала сохранять член, содержащий Рб. Экспериментальная проверка правильности такого предположения составляла одну из главных задач настоящей работы. Решение ее позволяет сформулировать теоретическую базу для правильной интерпретации наблюдаемых явлений нелинейности. Наряду с этим пре следовалась цель выявить основные закономерности, которым подчиняются явления диэлектрической нелинейности в СТР со структурой перовскита в неполярной фазе при достаточном удалении от области СЭФП.

Объекты исследования и методина измерений были выбраны, руководствуясь принципами, следующими из приведенвого выше рассмотрения.

- I. Для исследования были отобраны поликриоталлические (керамические) образцы, имеющие достаточно четкий ФП и максимальную однородность, которая контролировалась по методу /22/.
- 2. Измерения проводились в изавистатическом режиме: смещарыее поле В было постоянным; измерительное поле Е_и слабым, с частотой, значительно ниже частоты "зажатия" образца.
- 3. Ширина области температур, при которых велось измерение, как минимум на 30:40° превышала Тир. В то же время температурная область измерений в основном находилась в пределах, где проводимость не могла существенно повляять на результаты (&<10°10° см°1.см°1).
- 4. Далные измерений были получены при различных величинах смещающего поля, достигающего 40+50 кв см $^{-1}$. В
 расчет принимались данные, полученные при $E > E_{\rm Kp}$, где $E_{\rm Kp} \sim 10$ кв см $^{-1}$. Во избежание частичного зажатий криоталлитов в сильном поле опыт проводился на твердых растворях с относительно малой объемной влектрострикцией

 $Q_{\nu} = Q_{TT} + 2Q_{TS}$ (no opazienno o nozozimum nomnomentos Bat $(O_{\pi})/3I/$.

Указанным требованиям в достаточной мере соответствуют СТР системы (Ва,Уг)Т(О3 (концентрационный интервал 30 + 80 мол. Я Уг Т(О3) и системы Ва(Т(,Уп)О3 (концентрационный интервал 10 + 15 мол. Я ВаЗиО3), которые и были основными объектами исследований настоящей работы.

\$2. Анализ явлений нелинейности на основании феноменологической теории Девоншира-Гинабурга

В предыдужем разделе было поназано, что для четкой постановки опытов предварительно необходимо определить параметры Т_{КР} и Е_{КР}. Решить эту задачу о достаточной строгостью можно на основании феноменологической теории ФП I рода для монодоменных кристаллов титаната бария, для которых известны коэффициенты разложения потенциала в форме Д.-Г. По-видимому, в некстором приближении (во всяком случае по порядку величины) полученные данные Т_{КР}. Е_{КР} сохраняют свои значения также для СТР на основе титаната бария.

Если поле Е приложено вдоль оси — Z, совпадающей с направлением [OOI], и рассматривается температурная область неполярной фазы, то разложение термодинамического потенциала для ФП I рода в ваписи Девеншира принимает вид (учитивая $E_X = E_Y = 0$; $E_Z = E \neq 0$; $P_X = P_Y = 0$; $P_Z = P \neq 0$):

$$\phi(P,T) = \phi_0 + \frac{\alpha}{2}P^2 + \frac{\beta_1}{4}P^4 + \frac{\beta_1}{6}P^6 = EP$$
 (I)

где коэффициенты $\alpha > 0$, $\beta < 0$ и $\beta > 0$ все зависят от температуры (см., например, /13/, где эта зависимость дана в наглядной графической форме).

Из условий минимальности термодинамического потенциала /I/ $\left(\frac{\partial \phi}{\partial P_T}\right)_T = 0$; $\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial P^2}\right)_T > 0$ следует связь между полиризацией к полем

$$E = \propto P + \beta_4 P^3 + \gamma_4 P^5$$
 (2)

а также выражение для обратной восприимчивости под полем при T = const.

$$\frac{1}{z_{\tau}} = \left(\frac{\partial E}{\partial P}\right)_{\tau} = \alpha + 3\beta_{\tau} P^2 + 5\gamma_{\tau} P^4 \tag{3}$$

Коэффициент обратной восприимчивости при нулевом поле и в рамках справедливости классического закона Кюри-Вейсса является линейной функцией температуры

$$\alpha = \frac{1}{2C_0} = A_W (T - T_0) = \frac{1}{C_W} (T - T_0),$$
 (4)

где С_№ - постоянная Кюри-Вейсса, определенная по эс (Т) при E = 0; Т_о - температура Кюри-Вейсса.

Постепенное убывание скачков спонтанной поляризации при возрастании смещающего поля Е показано на рис. 1, 2.

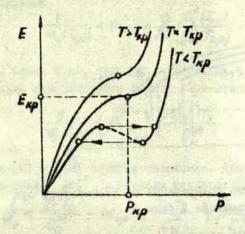


Рис. I. Связь поляривации и поля при фавовом переходе I рода.

Из рис. I видно, что скачок поляризации, вызывающий ноявление так называемых двойных петель гистеревиса, полностью исчезает при некоторой температуре T_{KP} . Экстремумы на кривой E(P) вырождаются в точку перегиба, которой соответствуют значения P_{KP} , E_{KP} . Условие этой точки перегиба, согласно (3) может быть записано

$$\left(\frac{\partial x^{-1}}{\partial P}\right)_{TMD} = 6\beta_1 P_{Np} + 20\gamma_1 P_{Np}^3 = 0$$
, (5)

отнуда для определения Р_{ир} имеем выражение

$$P_{np}^{2} = -\frac{3}{10} \frac{\beta_{1}(T_{np})}{\gamma_{1}(T_{np})}.$$
 (6)

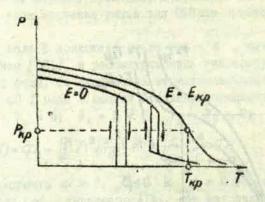


Рис. 2. Зависимость подяривации от температуры при фазовом переходе I рода.

Из рис. I легко заметить, что при любой $T > T_{KP}$ обратная восприимчивость $A^{-1}(E) = \begin{pmatrix} \partial E \\ \partial P \end{pmatrix}_T$ имеет экстремум (минимум), общее условие которого может быть задано в форме

$$\left(\frac{\partial x^{-1}}{\partial P}\right)_{T} = 0 \tag{7}$$

Последнее приводит к выражению типа (6), но в более общем виде, где вместо $P_{\rm kp}$ стоит $P_{\rm g}$, соответствующие экстремуму $\approx_{\rm g}$ зависимости $\approx_{\rm g}(E)$ при некоторой температуре $T > T_{\rm kp}$. Подставляя это выражение в (3), которое, таким

образом, должно давать 🤏 в функции температуры, и учитывая (4), получаем

$$\frac{1}{2c_3} = \frac{1}{2c_0(T)} - \frac{g}{20} \frac{\beta_1^2(T)}{\gamma_1(T)} . \tag{9}$$

Известно, что коэффициенты β_4 и β_4 от температуры зависят слабо, ξ поэтому в небольшом интервале температур второй член практически нвляется константой, которую мы обозначим через θ (следует отметить, что $\theta > 0$).

При $T = T_{KP}$, как легко ваметить на рис. I, величина e^{-1} , соответствующая E_{KP} , обращается в нуль, поэтому из (9) следует

$$\frac{1}{2c_0(T_{KP})} = \propto \kappa_P = \frac{9}{20} \frac{\beta_s^2(T_{KP})}{\gamma_1(T_{KP})}. \tag{10}$$

Если, кроме того, принять во внимание, что вследствии выполнения классического вакона Кюри-Вейсса

$$\frac{1}{\partial c_0(T_{np})} = \propto \kappa p = \frac{T_{\kappa p} - T_0}{C_{N}^{2c}}, \qquad (11)$$

то из (9) и (IO) следует выражение, дающее геометрическое место точек 🎉 в функции температуры

$$\frac{1}{2C_0} \approx \frac{T - T_0}{C_W^2} - \alpha c_{ND} = \frac{T - T_0}{C_W^2} - \frac{T_{ND} - T_0}{C_W^2} = \frac{T - T_{ND}}{C_W^2} (12)$$

Попутно отметим, что выражение (I2) имеет интересную геометрическую интерпретацию (см. рис.3): если выполняется классический закон Кюри-Вейсса по отношению к обосточки обостветствующие различным температурам). лежат на примой, которан практически парадлельна обосточки обоставления приводит к выводу, что при любой температуре обосточки обосточк

^{*}) При повышении температуры β_i^2 и γ_i одновременно уменьшаются.

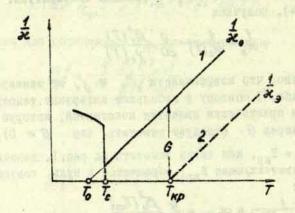


Рис.3. Температурная зависимость обратной восприимчивости при E = 0 (I) и экстремальных значений эс (E), полученных при различных T = conf (2) при фазовом переходе I рода

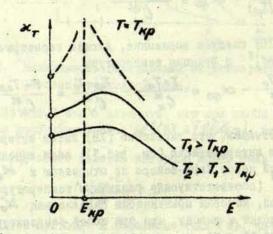


Рис. 4. Полевая зависимость реверсивной восприимчивости при различных Т = const в случае фазового перехода І рода-

при $E = const > E_{KD}$ должна хотя бы частично проходить над кривой \mathcal{X}_0 (T). Кроме того (что легко обнаружить также по рис. I, исследуя вависимость $\mathcal{X}^{-1}(E) = (\frac{\partial E}{\partial P})_T$), на кривой $\mathcal{X}(E)$ при T = const должен наблюдаться максимум (см. рис. 4).

. Искомый параметр Т_{кр} легко определить из выражений (IO) и (II):

$$T_{NP} - T_0 = \frac{9}{20} C_N^{ac} \frac{\mathcal{B}_t(T_{NP})}{\chi(T_{NP})}. \tag{13}$$

Проведем расчет для ВаТ(O_3 , приближенно принимая постоянство \mathcal{O}_4 и \mathcal{O}_4 в интервале T_c + $T_{\rm KP}$ и подставляя их зна-чения для $T=T_c$ (используя данные /13/) в выражение(13). Далее, заимствуя из /33/ $C_{\rm M}=0,92\cdot10^4$ $^{\rm O}$ K, получаем $T_{\rm KP}-T_0=19^0$. Известно, что для ВаТ(O_3 разность $T_0-T_c=9+10^0$ /II/и, следовательно, $T_{\rm KP}-T_c\approx10^0$ (последний результат согласуется с шириной интервала, в котором наблюдаетются двойные петли гистерезиса /28/).

Величину $E_{\rm kp}$ легко получить, подставляя в вырежение (2) $P_{\rm kp}$ из (6) и $\propto_{\rm kp}$ из (10):

Учитыван, что все члены имеют общие множители и /3, 4 0, следует

 $E_{\rm Kp} = 0,132 \sqrt{\frac{|A_{\rm f}|^5}{J_{\rm f}^3}}$ (15)

Подставляя для β_1 и β_4 при $T = T_{\rm RD}$ данные из /I3/. получаем $E_{\rm RD} = 37$ ед. СГСВ = II кв. см $^{-1}$, что приблизительно согласуется с данными, полученными другим путем /IO/.

Ваметим, что отношение (T_{кр} - T_с) и Е_{кр} приблизительно равно I град-кв⁻¹-см, что находится в согласии с экспериментальными данными о сдвиге температуры Т_с под действием поля $E < E_{Kp}$ /28/. Из результатов термодинамической теории /II/ следует, что этот сдвиг точки СЭФП I рода должен линейно зависеть от смещающего поля E, так как в виражение для $\frac{A}{E}$ входят только коэффициенти разложения потенциала A.— Γ .

Ниже перечислим ряд признаков, которые вблизи СЭФП при $T > T_C$ (где T_C — температура перехода в нулевом поле) могут свидетельствовать о том, что исследуемый СЭФП является ФП I рода (коэффициент β_1 имеет отрицательный внак):

- наблюдаются скачки спонтанной поляризации (рис. I), связанные с индуцированным СЭФП (двойные петли гистерезиса в переменном поле);
- 2) вависимость $\mathcal{H}_{\bullet}(T)$ при E = const > 0 частично проходит над кривой $\mathcal{H}_{\bullet}(T)$ при E = 0 (рис. 3);
- 3) вависимость $\mathcal{H}_{r}(E)$ при T = const проходит черев максимум, который смещается при повышении температуры $T > T_{KD}$ (рис. 4);
- 4) температурный сдвиг СЭФП $\Delta T_C = T_C$ (E > 0) $-T_C$ (E = 0) линейно зависит от E.

В монокристаллах ВаТіО₃ двойные петли гистерезиса впервые наблюдались Мерцем /28/; прохождение & (Е) через максимум было установлено Трибвассером /7/, линейная зависимость $\Delta T_{c}(E)$ следует из данных Мейерхофера /5/. Данных о выполнении закономерности, показанной на рис.3, в литературе нет; надеяться на ее подтверждение можно лишь в очень хороших монокристаллах при условии устранения побочных эффектов, которые, например, в значительной мере сказывались на результатах работы /7/.

В отношении керамики ВаТі О отметим, что в большинстве известных работ /9,16,17,19/ указывается на отсутствие признаков ФЛ І рода и положительность коэффициента В . Исключением является работа /18/, где наблюдалось прохождение через небольшой максимум зависимости & (Е), и работа /32/, где сообщается о появлении двойных петель гис-

терезиса при Т > T_C. В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что при оценке данных, полученных на керамических образцах, но имеющих принципиальное значение (в нашем случае дискурсионным является характер СЭФП) совершенно необходимы дополнительные сведения о фазовой однородности образцов в исследуемом интервале температур, так как остатки полярной фазы могут "симулировать" эффекты, нетипичные для основной — неполярной фазы. В частности, заметим, что в полярной фазе эффект прохождения ε (Е) черев максимум выражен достаточно сильно /21/.

Рассмотрии более подробно вопрос о принципиальной возможности наблюдения эффектов, карактерных для СЭФП I рода на образцах сегнетокерамики типа титаната бария. Если поле Е по отношению к кристаллографическим осям, оказывается направленным произвольно (что карактерно для помикристалла), то необходимо в качестве отправной точки для анализа явлений в неполярной фазе воспользоваться разложением термодинамического потенциала в более общем виде /I/:

$$\phi(RT) = \phi_0 + \frac{2}{2}(R^2 + R^2 + R^2) + \frac{A_1}{4}(R^4 + R^4 + R^4) + \frac{A_2}{2}(R^2 R^2 + R^2 R^2) + \frac{A_1}{6}(R^4 + R^4 + R^4) - EF$$
 (16)

В работе /34/ показано, что связь между поляризацией и полем для монодоменного кристалла, которая может быть получена на основании разложения типа (16) после перехода к оферическим координатам (поле Е ориентировано вдоль оси - 5):

$$P_x = P \cos y \sin \psi$$
 $P_y = P \sin y \sin \psi$ (18)

 $P_z = P \cos y$

можно получить в общем виде,

$$E = \alpha P + \beta P^3 + \beta P^5,$$
 (17)

где ковффициент β является линейной комбинацией ковффициентов β_1 и β_2 , вид которой зависит от ориентации \tilde{E} по отношению к кристаллографическим направлениям. *

Усреднение, по углам (полярному φ и азимутальному φ) в случае ВаТ 1 О $_{3}$ при подстановке β_{4} и β_{2} из /II/ по нашим подочетам дает для $T = T_{c} = 120^{\circ}$ С величину $\bar{\beta} = -7 \cdot 10^{-14}$. Отметим, что аналогичный подход, примененный в работе /I9/, дал для $T = 135^{\circ}$ С величину $\bar{\beta} = +4 \cdot 10^{-14}$. Это понятно, так как абсолютное значение β_{4} , при повымении температуры уменьшается и усредненное значение $\bar{\beta}$ должно увелиться.

Следует подчеркнуть, что указанные результаты усреднения для керамики титаната бария получаются при подстановке данных, взятых для монокристалла, где, как известно,
эффекты корреляции проявляются иначе, чем в поликристалле.
Очевидно, что для монокристаллических участков, из которых состоит керамика, коэффициент В, котя и имеет отрицательный
внак, но его абсолютное значение меньше чем в массивном
монокристалле и, следовательно, В для всего поликристалла в целом нуждается в положительной коррекции, величина
которой нам неизвестна. Во всяком случае следует признать,
что эффекты, характерные для СЭФП I рода в однородных керамических образцах, если и наблюдаемы, то только в непосредственной близости от СЭФП и выражены они очень слабо.

Приведенные выше соображения позволяют предположить, что для описания диэлектрической нелинейности в перовокитной сегнетокерамике при $T > T_{\rm KP}$ и $E > E_{\rm KP}$ можно использовать более простое выражение чем (2) и (17), а именно:

$$E = \propto P + \beta P^3, \qquad (19)$$

где $\infty > 0$ и зависит от температуры в соответствии с (4); $\beta > 0$ является изотропным параметром и зависимость по-

ж) Коэффициент у , соответственно, является линейной комбинацией коэффициентов у , у и у , которые в самом общем случае фигурируют в разложении (16).

следнего от температуры должна быть определена в экспери-

С формальной точки эрения (I9) соответствует связи Е(Р), которая следует из феноменологической теории ФП II рода. Подтверждение правильности указанного предположения и уточнение границ его применимости может быть получено только экспериментальным путем. Повтому ниже мы попытаемся сформулировать ряд закономерностей, которые вытекают из (I9) и могут быть с достаточной достоверностью проверены путем измерения ряда характерных параметров.

Следуя намеченному пути в первую очередь из (I9) определим реверсивную восприимчивость для случая, когда смещающее поле и, следовательно, и индуцированная поляризация отличны от нуля (при этом будем иметь ввиду, что поляризация и восприимчивость зависят от температуры):

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x_0} + 3\beta P^2 \tag{20}$$

На основании (20) можно сразу указать на два важных следствия:

для ж_€ (Т), измеренной при смещающем поле в =
 const ≠ 0, классический закон Кюри-Вейсса нарушается;

2) $\mathcal{H}_{E}^{-} \to \mathcal{H}_{0}^{-} \to 0$ или $\mathcal{H}_{E}^{-} \in \mathcal{H}_{0}^{-}$ при добой $T \to T_{0}^{-}$ таким образом, кривая $\mathcal{H}_{E}^{-}(T)$ имеет более пологий вид чем кривая $\mathcal{H}_{0}^{-}(T)$ и проходит ниже последней.

Последнее следствие иногда более удобно представить,

переписав (20) в форме

$$\varkappa_{\varepsilon}(T) = \frac{\varkappa_{o}(T)}{1+3\varkappa_{o}(T)\beta P^{2}(T)} , \qquad (21)$$

Попытаемся установить поведение кривых \varkappa_{ε} (Т) при различных значениях $\xi = const \neq 0$, Для этого продиффереццируем выражение (19) по температуре, учитывая связь (4) и считая β пока независимым от температуры

$$A_{W}P + A_{W}(T-T_{0})(\frac{\partial P}{\partial T})_{E} + 3\beta P^{2}(\frac{\partial P}{\partial T})_{E} = 0$$
 (22)

Отсюда следует

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{E} = -\frac{A_{W}P(T)}{A_{W}(T-T_{0}) + 3\beta P^{2}(T)} \tag{23}$$

Последнее выражение имеет наглядную геометрическую интерпретацию, если принять - согласно опыту - что при Т > Ткр
зависимость Р(Т) монотонно убывает с ростом температуры
(см. рис.2). Действительно, при Е ≠ 0, как видно из (23),
в процессе роста температуры величина (Р/дТ) проходит
через экстремум, что соответствует наличию точки перегиба
на кривой Р(Т). Условие Т — со приводит к(Р/дТ) 0, что
свидетельствует об асимптотическом убывании Р(Т).

Для анализа вависимости » (Т) представим (20) в форме

$$e_{\epsilon}(T) = \frac{1}{A_{W}(T-T_{0}) + 3\beta P^{2}(T)}$$
 (24)

из которой отчетливо видно, что с ростом температуры $(T > T_0)$ в знаменателе первый член растет, а второй убывает, вследствие чего $\mathscr{A}_{\mathfrak{g}}(T)$ проходит через максимум при температуре $T_{\mathfrak{g}} > T_0$ (см. рис.5). **)

Найдем далее поляризацию P_{20} м, соответствующую температуре T_{M} при $E \neq 0$. Для этого определим температурный экстремум эквисимости (20) из условия $\left(\frac{\partial 2e^{-}}{\partial T}\right)_{E} = 0$, которое дает

$$A_W + 6\beta P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right) = 0$$

на основании замечаний, приведенных выше, следует подчеркнуть, что Т_м не имеет ничего общего с точкой СЭФП.

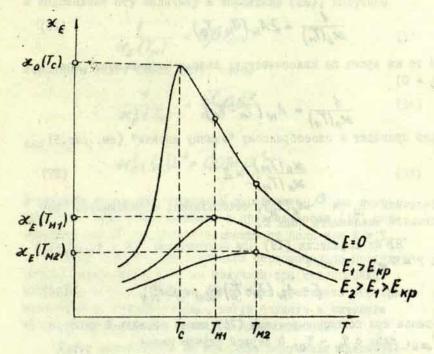


Рис.5. Температурная зависимость реверсивной восприимчивости при различных смещающих полях E = const

После подстановки в это уравнение $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_E$ из (23) при температуре $T = T_M$ получаем искомое выражение для $P_{\infty M}$:

$$P_{xM}^2 = \frac{A_W}{3B} (T_M - T_0).$$
 (25)

При помощи последнего выражения удается установить ряд вакономерностей, которым должны подчиняться эффекты нелинейности в неполярной фазе.

I. Подставляя в выражение (20) $P^2 = P_{\mathcal{X}_M}^2$ из (25) и $\mathcal{X}_0^{-1}(T_M) = A_W(T_M - T_0)$ из (4), получаем для температур-

ного максимума кривой ж (Т)

$$\frac{1}{\varkappa_{E}(T_{m})} = 2A_{w}(T_{m} - T_{o}). \tag{26}$$

В то же время по классическому закону Кюри-Вейсса (при E = 0)

Это приводит и своеобразному "занону двойки" (см. рис.5)

$$\frac{\varkappa_o(T_M)}{\varkappa_E(T_M)} = 2. \tag{27}$$

Величины T_M и $\mathscr{A}_{\epsilon}(T_M)$, естественно, определяются величиной смещающего поля ϵ .

2. Из выражения (I9) при подстановке $\alpha = A_W(T_M - T_0)$ и $P = P_{A_M}$ следует

Отсюда при помощи выражения (25) можно связать Е либо с $P_{\mathbf{x}\,\mathbf{u}}$, либо с $T_{\mathbf{u}}$ - $T_{\mathbf{o}}$. В первом случае имеем

$$E=4\beta P_{2H}^3, \qquad (29)$$

BO BTOPOM -

$$E^{2} = \frac{16}{27} \frac{A_{N}^{3}}{B} (T_{N} - T_{0})^{3}$$
 (30)

Последнее выражение можно переписать в виде (смотрите также /37/) $T_{w}-T_{o}=12\beta^{\frac{2}{3}}C_{w}^{2}E^{\frac{2}{3}}$ (31)

3. Можьо свявать с величиной Е также высоту максимума $\mathcal{X}_{L}(T_{M})$. Действительно, из (28) и (29) следует

$$A_W(T_N - T_0) = 3\beta P_{WM}^2$$
 (32)

и подставляя эту величину в выражение (26), получаем

$$\frac{1}{ae_{\sigma}(T_m)} = 6\beta P_{aem}^2 . \tag{33}$$

Используя далее связь (29), имеем

$$\frac{1}{\varkappa_{\varepsilon}^{3}(T_{m})} = \frac{27}{2}\beta E^{2} \tag{34}$$

или

$$\partial \epsilon_E^3(T_H)E^2 = QO24 \beta^{-1}$$
 (35)

Последнее выражение позволяет определить β из опыта; при этом, если предположение о правомерности (19) справедливо, то β не должно зависеть от поля при $E > E_{KD}$.

Таким образом, на основании первоначально постулированной зависимости (19) мы получили три соотношения — (27), (31) и (35), которые могут быть проверены экспериментально и, следовательно, могут служить в качестве критерия правильности исходных предположений.

Далее остановимся на проблеме получения аналитической зависимости \mathcal{X} (E) при T = rowst, которая представляет самостоятельный интерес (напомним, что восприимчивость измеряется в слабом переменном поле под действием постоянного смещающего поля). Исходным может служить ранее полученное нами выражение /20/ в следующей записи

$$\varkappa_{\tau}(E) = \frac{\varkappa_{o}}{1 + 3\varkappa_{o}\beta P^{2}(E)} \tag{36}$$

Для дальнейшего необходимо введение аналитической зависимости Р(Е), что связано с большими осложнениями. Можно, конечно, воспользоваться некоторым линейным приближением, но следует иметь в виду, что такое приближение быстро становится непригодным по мере возрастания Е. Наиболее простым приемом является подстановка в (36) $P \approx P_T = \infty_0 E$, приводящей и выражению

$$\varkappa_r(E) = \frac{\varkappa_o}{1+3\beta \varkappa_o^3 E^2} \tag{37}$$

Поскольку $P_I = P$ (см. ниже (40)) формула (37) будет давать заниженные значения $\mathscr{A}_r(E)$ и пригодна только в области слабых полей (E < 10 ед. СГС9 = 3 кв·см $^{-1}$).

Если известна экспериментальная зависимость $\mathcal{X}_{\tau}(E)$, то теоретическому анализу может способствовать подстановка в (36) $P \approx P_2 = \mathcal{X}_{\tau}(E)E$, приводящая к выражению

$$\varkappa_{\tau}(E) = \frac{\varkappa_{o}}{1.3 \beta \varkappa_{o} \varkappa_{\tau}^{2}(E) E^{2}},$$
 (38)

которое для сильных полей (E > 100 ед. СГС θ = 30 кв·см $^{-1}$) переходит в

 $2e_{r}(E)=(3\beta E^{2})^{-\frac{1}{3}}$ (39)

Следует однако отметить, что поскольку $P_2 \le P$ (см. ниже (4I)), то формуле (38) будет давать завышенные значения \mathscr{X}_* (E) по мере возрастания E.

и Вербицкой /36/:

x = 20 (1+ x/E/)-1

Эти формулы, также как и (37) и (38), качественно правильно отражают основные черты поведения зависимости ЖДЕ): Ж сомый при слабых полях; существование точки перегиба, и асимптотическое стремление к нулю при высоких полях.

^{*)} В этом свете некоторым компромиссным решением вопроса являются эмпирические формулы, предложенные Джонсоном /35/ $x = x_0 (1+3\beta x_0^3 E^2)^{-\frac{1}{2}}$

Представление о величине погрешности в наждом из рассмотренных нами случаев (37) и (38) дает поправочный множитель, который следует ввести для сохранения корректности формулы (36) при подстановке P_T или P₂ эчевидно:

"истинная" поляризация $P = \kappa_1 P_1 = \kappa_2 P_2$, где

$$\kappa_{t} = \frac{3\varkappa_{\tau}(E)}{\varkappa_{0} + 2\varkappa_{\tau}(E)} \tag{40}$$

И

$$\kappa_2 = \frac{3 \varkappa_0}{\varkappa_0 + 2 \varkappa_r(E)} \tag{41}$$

Как видно, для определения поправочных иножителей к₁ и к₂ необходимо предварительное экспериментальное определение зависимости «, (Е), что можно осуществить по методу измерения реверсивной диэлектрической проницаемости.

Выражения для поправочных множителей (40) и (41) можно получить из следующих рассуждений. На основании исходного выражения (19) можно формально записать

$$\rho = \frac{x_0 E}{1 + \beta x_0 P^2} \tag{42}$$

Далее, из формулы (36) легко выразить

$$\varkappa_0 \beta P^2 = \frac{\varkappa_0 - \varkappa_T(E)}{3 \varkappa_T(E)} \tag{43}$$

и после подстановки в (42) получить

$$P = \frac{3\varkappa_0\varkappa_+(E)}{\varkappa_0 + 2\varkappa_+(E)} \cdot E \tag{44}$$

Выражение (44) удобно тем, что позволяет определить зависимость P(E), если известна зависимость $\mathcal{X}_{\tau}(E)$, которая экспериментально определяется относительно проще. Которое

получается после подстановки (44) в (43):

$$\beta = \frac{(\varkappa_0 - \varkappa_E)(\varkappa_0 + 2\varkappa_E)^2}{27\varkappa_0^3 \varkappa_E^3 E^2} \qquad \text{(45)}$$

Общий вид кривой $\varkappa_r(E)$ согласно выражению (36) определяется монотонной зависимостью P(E). Можно учесть также влияние температуры, принимая, что $\varkappa_o(T)$ плавно изменяется гогласно классическому закону Кюри-Вейсса.

Анализ производной

$$\left(\begin{array}{c} \partial \varkappa(E) \\ \partial E \end{array}\right)_{\tau} = -\frac{6\beta \varkappa_o^2 \varkappa_{\tau} P}{(1+3\beta \varkappa_o P^2)^2} , \qquad (46)$$

полученной дифференцированием (36) и с учетом $\left(\frac{\partial P}{\partial E}\right)_{\tau} = \varkappa_{\tau}$ показывает, что кривая $\varkappa_{\tau}(E)$ должна иметь точку перегиба. Действительно, если ввести фактор изотермической нелинейности (T = const) согласно определению

$$N_r(E) = -\frac{1}{\alpha_r} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial E} \right)_r , \qquad (47)$$

то на основании (46), использун последовательно (36) и (44), можно записать четыре эквивалентных вырежения, в которые входят коэффициент /3:

$$N_{r}(E) = \frac{6\beta a c_{o}^{2} P}{(4+3\beta a c_{o}^{2})^{2}} ; \qquad (48)$$

$$N_{r}(E) = \frac{6\beta \varkappa_{o} \varkappa_{r} P}{1 + 3\beta \varkappa_{o} P^{2}} \tag{49}$$

ж) Аналогичное выражение было получено в работе /8/, однако использовано без достаточного обоснования для определения /3, в монокристалле Ват. 0, вблизи ФП.

$$N_r(E) = 6\beta a \epsilon_r^2 P \tag{50}$$

$$N_{\tau}(E) = 6\beta \varkappa_{\tau}^{2} P$$

$$N_{\tau}(E) = \frac{18\beta \varkappa_{0} \varkappa_{\tau}^{3}}{\varkappa_{0} + 2\varkappa_{\tau}}$$
(51)

Легко показать, что кривая / (Е) имеет экстремум (что соответствует точке перегиба на ж,(Е)), величину которого определяют обычным путем из условия

Дифференцирование (49) и поиск экстремального значения нелинейности *) дает при данной T = const :

$$N_m = \frac{\partial \mathcal{L}_{Nm}}{2P_{Nm}} \tag{52}$$

где жим и Рим соответствуют напряженности поля Е котором фактор нелинейности имеет максимум (типичные кри-N_T (E) показаны на рис. 12).

Подстановка Рм согласно (44) в выражение (52) да-

$$N_{m} = \frac{\partial \ell_{0} + 2\partial \ell_{Nm}}{6\partial \ell_{0} E_{Nm}}, \qquad (53)$$

откуда следует, что

$$N_m E_{Nm} \angle \frac{1}{2}$$
 (54)

Близость произведения (54) к величине 1/2 определяется близостью величин жим и жо, как это следует (53). Этот вывод также может быть использован для проверки

ж) Это выражение наиболее удобно для поиска дифференциала по Е; принимается также во внимание, что орде = 2.

теории, так как определение N_m и E_{Nm} не представляет сложности.

В заилючение отметим, что большой интерес представляет нахождение зависимости фактора нелинейности. N от температуры, выше мы рассмотрели поведение N (E) при T = CONST; очевидно, для получения зависимости N (T) необходимо фиксировать величину поля E. Целесообразно для этой цели выбрать точку, где $\mathbf{x}_{T}(E) = \frac{\mathbf{x}_{O}(T)}{2}$ (то есть,

берется поле Е, при котором реверсивная восприимчивость вдвое меньше, чем начальная восприимчивость при той же температуре), так как на кривой $\boldsymbol{x}_{\epsilon}(T)$ этой точке соответствует температурный максимум $\boldsymbol{x}_{\epsilon}(T_{\mathrm{M}})$. Итак, для каждой температуры $T > T_{\mathrm{KD}}$ можно подыскать Е, при котором данная температура соответствует T_{M} , и для этой пары параметров из зависимости $\boldsymbol{x}(T,E)$ найти нелинейность, которую назовем "характерной" (N_{MM}). Последнюю легко найти, комбинируя выражения (50), (32) и (33):

$$N_{\text{DEM}}(T) = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{3A}{A_W^2 (T-T_0)^3}}$$
 (55)

Как видно, карактерная нелинейность, кроме коэффициента β , в значительной степени определяется постоянной Кюри-Вейсса $C_{w} = A_{w}^{-1}$; температурная зависимость подчиняется степенному вакону $N_{wn} \sim (T - T_0)^{-3/2}$.

§3. Методика измерений

Для исследования реверсивной нелинейности использовалась установка, блок-схема которой показана на рис. 6. Емкость образца измерялась при помощи измерительного моста
полных проводимостей типа SW M-2. Источником измерительного напряжения служил генератор Г4-18А. Измерительное поле на образце составляло несколько в см-1. В качестве индикатора равновесия измерительного моста использовался селективный вольтметр В6-1.

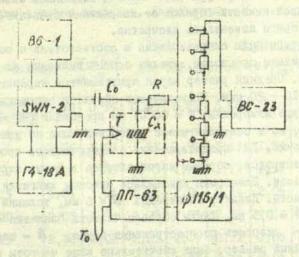


Рис. 6. Блок-схема измерительной установки

Смещающее напряжение от стабилизированного выпрямителя ВС-23 на образец подается через ступенчатый делитель напряжения и отделяющее сопротивление ? В І Мом. Сопротивление отделяет измерительную цепь от выпрямителя и предотвращает короткое замыкание в случае электрического пробоя образца. Максимальное смещающее напряжение достигало 3,5 кв, что на образце создавало поле смещения 70 квсм-1. Образец подключается к измерительному мосту через блокирующий конденсатор Со = 5.105 пф, который служит для отделения цепи смещающего напряжения от измерительной цепи. Так как емкость образцов не превышала 5·10³ пф, то влияние блокирующего конденсатора на величину измеряемой емкости можно не учитывать.

Температура образцов в диапазоне температур -160° + $*80^{\circ}$ С поддерживалась в заданной точке с точностью $\pm 1^{\circ}$ С и измерялась термопарой медь-константан.

Термо-ЭДС термопары измерялась потенциометром III-63 и микровольтиетром Ф-II6/I.

Измерения велись в режиме охлаждения. При достижении необходимой температуры (T = const) снималась зависимость реверсивной емкости образца от напряжения смещения, величина которого изменялась дискретно.

Образцы были синтезированы в соответствии с обычным двухстадийным процессом, уделяя особое внимание их однородности. Средний размер зерен кристаллитов керамики был порядка 10 + 20 мкм. Проводимость образцов при наивысшей температуре измерений (T = 80°C) не превышала $G = 10^{-8}$ см⁻¹, но в основной части измерений была на два-три порядка ниже. Для предотвращения электрического пробоя по краям электродов, образцы изготовлялись в форме цилиндрических чашек. Электроды наносились методом вжигания серебрянной пасты. Диаметр электродов G = 6 мм, толщина дна чашки G = 0.5 мм. Таким образом частота "зажетия" G = 0.5 мм. Таким образом частота "зажетия G = 0.5 мм. Таким образом частота "зажетия G = 0

Перед измерением образцы проходили тренировку, которая заключалась в циклическом наложении сильного поля $(E = 70 \text{ кв} \cdot \text{см}^{-1}$ в максимуме). Это позволяло ликвидировать явление гистерезиса на кривых $x_r(E)$, отмеченное в работе /17/.

§4. Экспериментальные данные. Сравнение с выводами теории

В настоящем разделе будет проведено последовательное сопоставление экспериментальных данных с результатами, полученными в §2. Особое внимание уделяется вопросу о том, в какой мере эксперимент подтверждает предположение о возможности описать основные эффекты диэлектрической нелинейности в неполярной фазе при помощи математического аппарата, базирующегося на выражении (19) и формально совпадающим с рядом выкладок, характерных для теории ФП II рода.

Отношение $\frac{\varkappa_o(T_m)}{\varkappa_E(T_m)}$ для СТР системы ($\mathtt{Ba}_{1-x},\mathtt{Sr}_x$) Тіо $_3$.

кв.см трация	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
5.	1,66	1,69	1,63	1,91	I,67	1,72	1,79	1,66
10	2,00	I,88	1,90	1,97	1,77	1,96	1,98	1,94
15	2,01	1,94	2,02	2,04	2,14	2,05	I,95	2,02
20	2,03	1,98	2,07	2,09	2,18	2,16	1,86	2,12
25	2,12	2,02	2,05	2,14	2,11	2,08	1,92	2,11
30	2,08	2,12	2,04	2,06	2,15	2,08	1,93	2,06
35	2,06	2,17	2,05	2,05	2,05	2,08	1,96	2,04
. 40	2,06	2,19	2,00	2,00	1,96	2,04	1,96	2,00
Среднее для Е>Е _{кр} ≥ІОка́•си	2,05	2,05	2,02	2,05	2,05	2,05	1,95	2,04

В первую очередь остановимся на температурных зависимостях восприимчивости (проницаемости), снятых в слабом переменном поле при различных постоянных смещающих полях.

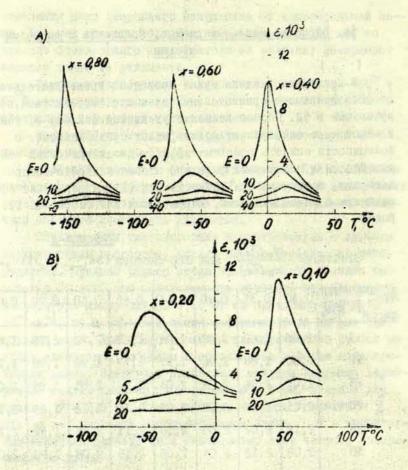


Рис.7. Температурные зависимости реверсивной проницаемости $\mathscr{E}_{\mathbf{z}}(\mathbf{T})$ при различных смещающих полях (Е указано в кв·см $^{-1}$) для твердых растворов систем ($\mathbf{Ba_{1-x}}, \mathbf{Sa_x}$) $\mathbf{TiO_3}$ (A) и $\mathbf{Ba(Ti_{1-x}}, \mathbf{Sa_x})\mathbf{O_3}$ (B)

Из общего вида кривых на рис.7 следует, что в соответствии с выражениями (21) и (31) полностью подтверждается вывод о возрастании пологости температурных характеристик и сдвига максимума по мере увеличения смещающего поля Е. Количественная сводка наблюдаемых эффектов содержится в таблицах I и 2 и рис.8.

Отношение $\frac{\mathcal{Z}_o(T_M)}{\mathcal{Z}_E(T_M)}$ для СТР системы Ва $(\text{Ti}_{1-x}, \text{Sn}_x)$ 03.

Е, ция вазпо ₃	0,10	0,12	0,15	0,20
2,5	I,27	1,35+	1,45	1,27
5,0	1,65	1,76	1,94	1,74
7,5	1,87	1,88	2,14	2,02
10	2,00	2,05	2,05	2,09
12,5	2,03	2,03	2,06	2,11
15	2,12	2,09	2,10	2,14
20	2,14	2,11	2,16	2,27
25	2,19	2,15	2,20	2,32
Среднее для S>E _{кр} ≥ IO кв•см-I	2,09	2,10	2,10	2,19

Данные таблицы I показывают, что для СТР системы (Ba, sr)тіо $_3$ (в дальнейшем система A) отношение $\mathscr{Z}_o(T_M)/\mathscr{Z}_E(T_M)=2$, следующее из выражений (26), (27) выполняется хорошо — с точностью до 3+5%. Для СТР системы $Ba(Ti, sn)o_3$ (в дальнейшни система B), как это видно из таблицы 2, наблюдается тенденция к некоторому превишению этого отношения — в среднем приблизительно на 9+10%. Из данных таблиц можно заметить, что для относительно слабых полей ($E < E_{KD} < 10$ кв.см $^{-1}$) "закон двойки"

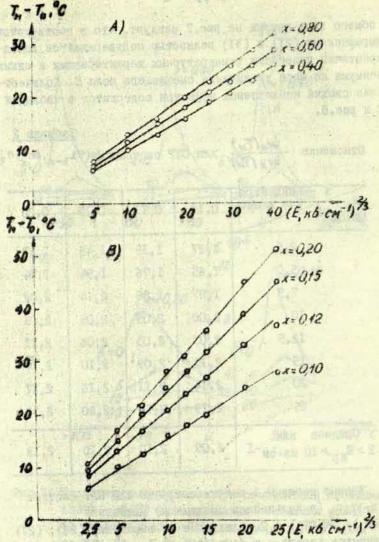


Рис.8. Сдвиг температурных максимумов кривых \mathcal{E}_{E} (Т) под действием смещающего поля È для твердых растворов систем (Ве $_{1-x}$, Sr $_{x}$) Т10 $_{3}$ (A) и Ва(Т1 $_{1-x}$, Sn $_{x}$) О $_{3}$ (В).

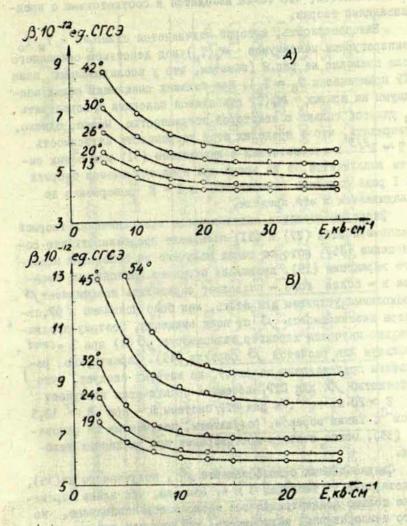


Рис. 9. Зависимость коэффициента β от смещающего поля при различных $T-T_0=const$ для СТР (Ва $_{0.40}^{\rm Sr}$ 0,60) $^{\rm T10}$ 3 (A) и Ва($^{\rm T1}$ 0,85 $^{\rm Sn}$ 0,15) $^{\rm 10}$ 3 (B)

не выполняется, что также находится в соответствии с предсказаниями теории.

Закономерность, которой подчиняется сдвиг $\Delta T = T_M - T_O$ температурных максимумов $\mathcal{X}_{\epsilon}(T_M)$ под действием смещающего поля показано на рис.8 (заметим, что у исследованных нами СТР практически $T_O \simeq T_O$). При больших смещающих полях максимумы на кривых $\mathcal{X}_{\epsilon}(T)$ отановятся пологими и определить T_M удается только с некоторой погрешностью. Можно, однако, утверждать, что в пределах этой погрешности зависимость $\Delta T \sim E^{2/3}$ в соответствии с выражением (31) для обеих систем выполняется, в то время как предсказываемая теорией оп 1 рода линейная зависимость $\Delta T \sim E$ совершенно не укладывается в эти пределы.

Экспериментальное подтверждение предсказанных теорией закономерностей (27) и (31) позволяет предполагать, что соотношение (35), которое также получено на основании исходного выражения (19), правильно отражает наблюдаемые свойства и - более того - позволяет определить коэффициент В.
Необходимым условием для этого, как было показано в §2, является независимость В от поля омещения. Поэтому предварительно изучался характер зависимости. В (Е) при Т = семт,
используя для расчетов В формулу (45). Характерные результати представлены на рис. 9, из которых следует, что
постоянство В для СТР оистемы А практически наступает
при Е > 20 кв см 1, а для СТР системы В - при Е > 12,5
кв см 1. Таким образом, результаты, полученные на основаних (35), можно считать достоверными при указанных условиях.

Сводка денных о коэффициенте \mathcal{S} , полученного из(35), представлена на таблицах 3 и 4. Заметим, что здесь отражена не только концентрационная зависимость последнего, но и его температурная зависимость, так как под действием увеличивающегося поля Е точка $T_{\rm M}$, соответствующая максимуму на кривой $\mathcal{H}_{\rm K}(T)$, смещается в область более высоких температур.

Коэффициент β , рассчитанный из выражения $\varkappa_E^3(T_M) \cdot E^2 = 0.074 \beta^{-1}$ при различных $E > E_{\rm KP}$ и $T > T_{\rm KP}$ для СТР системы (Ba_{1-x}, Sr_x)TiO₃.

E, KB-CM-I	B, I)-12 crcs p	ля различн в скобнах	тых концент $T_{M} - T_{O}$,		SrTiO ₃		
	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
10	2,5(II°)	2,6(90)	3,2(10°)	3,2(9°)	3, I(14°)	3,5(I3°)	4,6(I3°)	6,9(130)
15	2,5(15°)	2,8(120)	3,3(130)	3,4(120)	3,4(18°)	3,9(170)	5,0(17°)	7,1(170)
20	2,6(180)	2,9(15°)	3,4(160)	3,8(16°)	3,6(210)	4,4(200)	5,3(200)	7,2(200)
25	2,9(210)	3,0(18°)	3,6(190)	3,9(190)	3,8(24 ⁰)	4,6(220)	5,6(220)	7,3(230)
30	3,2(240)	3,I(20°)	3,8(210)	4,2(220)	4,2(270)	4,7(250)	6,0(250)	7,4(260
35	3,3(270)	3,2(220)	3,9(230)	4,4(25°)	4,4(290)	4,8(270)	6,I(28°)	7,5(290)
40	3,4(29°)	3,3(240)	4,I(25°)	4,7(280)	4,8(320)	5,0(290)	6,2(300)	7,6(320

Из данных таблицы 3, в частности, следует, что В для наждого из данных составов увеличивается с температурой, а в концентрационном ряду растет по мере возрастания концентрации втто 3. Отметим, что именно такие закономерности предсказываются микроскопической теорией нелинейности на основании модели ангармонического осциллятора /29/. Таким образом, данные таблицы 3, а следовательно, и правомерность выражения (35) получают дополнительное подтверждение. Аналогичные закономерности для СТР системы В следуют из данных таблицы 4.

Таблица 4

Коэффициент β , рассчитанный из выражения $\mathbf{E}^{3}(\mathbf{T}_{\mathbf{M}}) \cdot \mathbf{E}^{2} = \mathbf{0},074 \beta^{-3}$ при различных $\mathbf{E} > \mathbf{E}_{\mathbf{K}\mathbf{p}}$ и $\mathbf{T} > \mathbf{T}_{\mathbf{K}\mathbf{p}}$ для СТР системы $\mathbf{B}_{\mathbf{a}}(\mathbf{T}\mathbf{1}_{1-\mathbf{x}},\mathbf{S}\mathbf{n}_{\mathbf{x}})\mathbf{0}_{3}$.

E, KB·CM-I	В, 10° траций х	Easno ₃ (в с	различных Т _м -Т	
THE PROPERTY OF	0,10	0,12	0,15	0,20
. 10	3,5 (16°)	4,8 (20°)	6,0 (25°)	8,0(280)
12,5	3,5 (18°)	5,0 (240)	6,I (28°)	8,0(320)
15	3,5 (20°)	5,1 (27°)	6,1 (320)	8,1(360)
50	3,6 (240)	5,1 (33°)		8,2(440)
25	3,6 (28°)	5,2 (370)	6,3 (450)	The second secon

Если на основании приведенных выше данных считать, что имеются достаточно веские доказательства о возможности использования аналитических зависимостей, полученных на основании выражения (19) для описания и анализа явлений нелинейности в неполярной фазе при $T > T_{KP}$ и $E > E_{KP}$, то можно приступить и дальнейшему, последовательному изучению температурных и концентрационных зависимостей коэффициента β и других характеристик нелинейности, используя для

Таблица 5.

Концентрация SrTiO3	В, 10 ⁻¹² ед. СГСЭ при Т-Т ₀ = 30 ⁰ С	dB ,10-12en cros.00-1
0,30	4,0	0,10
0,35	3,5	0,05
0,40	4,2	0,04
0,45	4,7	0,06
0,50	4,5	0,07
0,60	5,0	0,05
0,70	5,7	0,05
0,80	8,0	0,09

Среднее
$$\frac{dS}{dT} = 0,06$$

Таблица 6

df crcs.0c	В, 10 ⁻¹² ед, сгсэ при т-т _о = 30°С	онцентрация Ва Sn O ₃
0,13	5,0	0,10
0,11	6,1	0,12
0,11	6,6	0,15
0,10	8,5	0,20

этой цели экспериментадьные данные о реверсивной восприимчивости (проницаемости). Эти данные при дальнейшем испольвовании выражений (45), а также(54) и (55), как будет показано ниже, позволяют провести исчерпывающий анализ, интересующих нас явлений.

Типичные характеристики реверсивной восприимчивости \mathcal{X}_{7} (E) при различных $T > T_{\mathrm{KP}}$ показаны на рис. 10. Хорошо видно, как с повышением температуры уменьшается перепад между величиной \mathcal{X}_{7} при E = 0 и \mathcal{X}_{7} (E) при сильном поле, когда наблюдается насыщение.

формула (45) позволяет по данным реверсивных характеристик определить В для любого СТР в достаточно широком интервале температур Т — То. Характеристики В (Т) для различных составов обеих систем А и В показаны на рис. II (характеристики, естественно, сняты в области, где В не вависит от Е). Хорошо видно, что температурные зависимости В (Т) для составов системы А близки к линейным, в то время как для составов системы В наблюдается некоторое отступление от линейности. Данные о концентрационной зависимости В (х) и состветствующего среднего температурного коэффициента В таблицах 5 и 6. В отношении зависимости В (х) для обетих систем подтверждаются результаты, полученные ранее на соновании расчетов В из формулы (35): с ростом концентрации второго компонента В монотонно увеличивается.

Теоретический и практический интерес представляют не только концентрационные и температурные зависимости коэффициента \mathcal{A} , но и фактора нелинейности \mathcal{N} . Данные об изотермической нелинейности $\mathcal{N}_{\tau}(E)$ могут быть получены путем дифференцирования реверсивных характеристик $\mathcal{X}_{\tau}(E)$ и дальнейшего использования выражения (47) (в нашей работе это осуществлялось при помощи ЭВМ). На рис.12 отчетливо видно, что $\mathcal{N}_{\tau}(E)$ проходит через максимум \mathcal{N}_{m} , который ваметно понижается и сдвигается в сторону сильных полей при повышении температуры. На достаточном удалении от температуры ФП выполняется предсказываемое теорией соотноше-

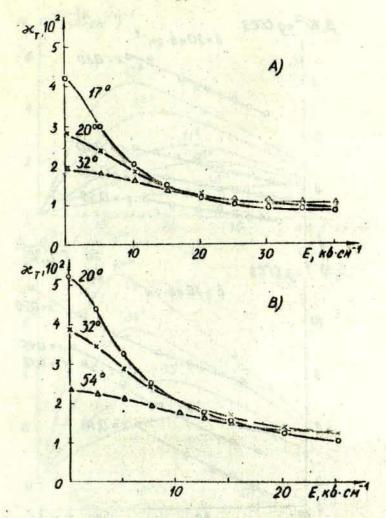


Рис. IO. Зависимости реверсивной восприимчивости от смещающего поля при различных $T - T_0 = const$ для СТР ($Ba_{0,40} Sr_{0,60})TiO_3$ (A) и $Ba(Ti_{0,85} Sn_{0,15})O_3$ (B)

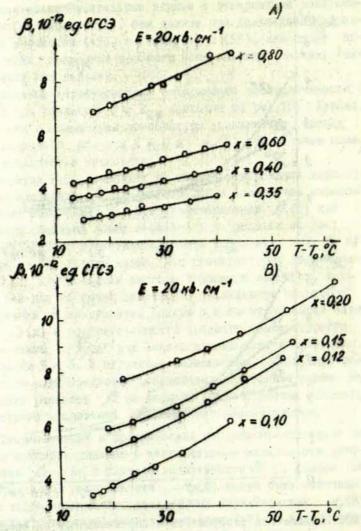


Рис. II. Температурные зависимости коэффициента β при $T > T_{\rm RP}$ и $B = const > E_{\rm RP}$ для различных концентраций компонентов в системах $(Be_{1-x}, sr_x) Tio_3$ (A) и $Be(Ti_{1-x}, sn_x) o_3$ (B)

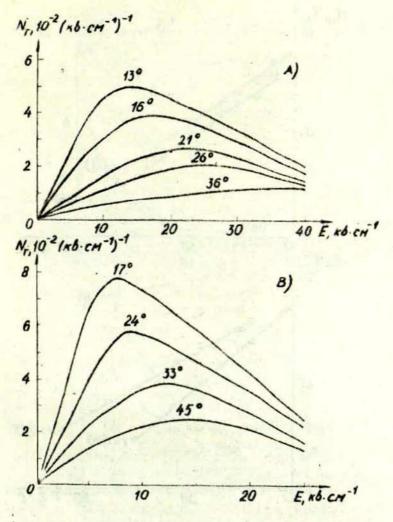


Рис. I2. Зависимости фактора изотермической нелинейности от смещающего поля при различных $T-T_0=const$, полученные путем обработки данных $\varkappa_r(E)$ для СТР ($Ba_{0,60}$, $sr_{0,40}$) 110 (A) и $Ba(Ti_{0,88}, sn_{0,12})^{0}$ (B)

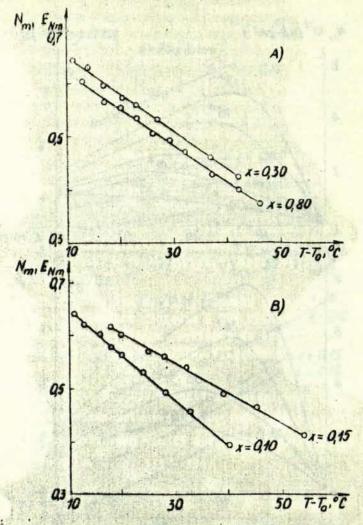


Рис. 13. Зависимости произведения N_m : E_{Nm} от температуры (по данным кривых типа рис. 12) для систем (Ba_{1-x}, Sa_x) $T10_3$ (A) и $Ba(T1_{1-x}, Sa_x)0_3$ (B)

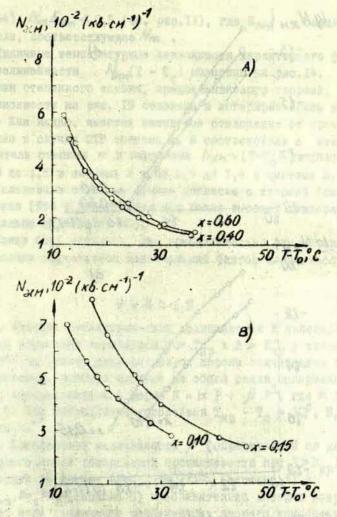


Рис. I4. Температурные зависимости характерного фактора нелинейности при $T > T_{\rm kp}$ и различных концентрациях компонентов для систем (Ba_{1-x}, Sr_x)TiO₃ (A) и Ba(Ti_{1-x}, Sn_x)O₃ (B)

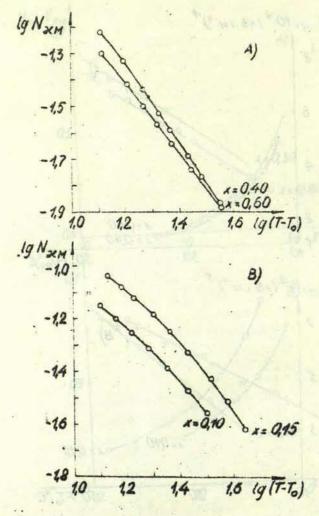


Рис.15. Температурные зависимости характерного фактора нелинейности (показанные на рис.14), отложенные в логарифыическом масштабе

ние (54): $N_m E_{Nm} < 0.5$ (см. рис.13), где E_{Nm} - смещаю-

Типичные температурные зависимости характерного фактора нелинейности $N_{\rm col}$ Т - $T_{\rm o}$) показани на рис. 14. Для проверки степенного закона, предсказываемого теорией, те же вависимости на рис. 15 отложени в логарифмическом масштабе. Как видно, имеется некоторое отклонение от примой, особенно в случае СТР системы В. В соответствии с этим показатель степени n в выражении $N_{\rm col}$ (T- $T_{\rm o}$) варьирует от 1,0 до 1,5 в системе А и от 0,9 до 1,4 в системе В. Как и следовало ожидать, лучшее согласие с теорией (см. выражение (55)) наблюдается при более высоких температурах (дальше от области Φ П).

Может быть показано, что прибливительно тем же закономерностям подчиняется максимальный фактор нелинейности None.

выводы

- I. Явдения диэлектрической нелинейности в неполирной фазе при значениях параметров $T > T_{RP}$ и $E > E_{RP}$ у твердых растворов на основе титаната бария хорошо подчиняются закономерностям, которые следуют из общей связи поляризации и поля, представленной в форме $E = \alpha P + \beta P^3$, где $\alpha > 0$ и $\beta > 0$. Для исследованных составов $T_{RP} T_C > 10^0$, $E_{RP} > 10$ кв см⁻¹.
- 2. Коэффициент нелинейности β (определений по данним характеристик реверсивной проницаемости при $E > E_{\rm RP}$) для твердых растворов (${\rm Ba}_{1-x}, {\rm Sr}_x)^{\rm T10}$ 3 (система A) и ${\rm Ba}({\rm Ta}_{1-x}, {\rm Sn}_x)^{\rm O}_3$ (система B) приолизительно линейно возрастает по мере увеличения концентрации второго компонента (x) и его значение, определенное при $T = T_{\rm c} + 30^{\rm O}{\rm C}$ измениется в пределах (4 + 8) \cdot 10 $^{-12}$ ед. СГСВ для системи A (x = 0,3 + 0,8) и в пределах (5 + 8,5) \cdot 10 $^{-12}$ ед. СГСВ для системи B (x = 0,1 + 0,2).

- 3. Установлено, что величина β для каждого из твердых растворов в отдельности практически не зависит от смещающего поля, если $E > E_{\rm kp}$. При выполнении последнего условия β приблизительно линейно зависит от температуры, если $T > T_{\rm kp}$. Среднее значение температурного ковфициента $\frac{\partial \beta}{\partial T} = 0.06 \cdot 10^{-12}$ ед. СГСЭ- $^{\circ}$ С- $^{\circ}$ для системы A и 0.11·10 $^{-12}$ ед. СГСЭ- $^{\circ}$ С- $^{\circ}$ для системы В.
- 4. Получение однозначных данных для коэффициента в возможно только при условиях, сформулированных в §I (отр. 55).
- 5. Установлено, что характерный фактор нелинейности N_{MM} (близкий к максимальному N_{m}) в зависимости от температуры изменяется приблизительно по степенному закону $N_{MM} \sim (T-T_0)^{-n}$, где n=1,0+1,5 в системе A и n=0.9+1.4 в системе B.

ЛИТЕРАТУРА

- L. Devonshire A.F. Theory of bariums titanate. Part.1. "Philos.Mag.", 1949, v.40, N.309; p. 1040-1063.
 Theory of barium titanate. Part.2. "Philos.Mag.",
 1951, v.42, N. 333, p. 1065-1079.
 Theory of ferroelectrics. "Advances Phys.", 1954,
 v.3, N 10, p. 85-130.
- 2. Гинабург В.Л. Теория оегнетовлектрических явлений. -"Успехи физических наук", 1949, т. 38, вып. 4, с 499 - 525 о ил.
- 3. Känzig W., Maikoff N. Der Einfluss elektrischer Felder auf das dielektrische Verhalten von Bariumtitanet Einkristallen. "Helv.Phys.Acta", 1951, v.24, fasc. 4, p.329.
- 4. Drougard M.B., Landauer R., Young D.R. Dielectric Behavior of Barium Titanate in the Paraelectric State. - 2Phys.Rev., 1955, v.98, N 4, p.1010-1014.

9.0 0 L.D w 13 H market

- 5. Meyerhofer D. Transition in the Ferroelectric State in Barium Titanate. - "Phys.Rev.", 1958, v.112, N 2, p. 413-423.
- 6. Triebwasser S. Tree energy, internal fields and ionic polarizabilities in BaTiO₃. "Phys. and Chem. Solids", 1957, v.3, N 1, p. 53-62.
- Triebwasser S. Space Charge Fields in BaTiO₃. "Phys. Rev.", 1960, v.118, N 1, p. 100-105.
- Stern E., Lurio A. Dielectric Properties of BaTiO₃ single Crystals in the Paraelectric State from 1 kc/sec to 2000 Mc/sec. "Phys.Rev.", v.123, N 1, p. 117-125.
- Caczmarek F., Pietrzak I. Electric Permittivity of AC Biased mono- and polycrystalline BaTiO₃ above the Curie Point. - "Acta Physica Polonica", 1965, v.27, fasc. 2, p. 335-342.
- 10. Kulwicki B.M. Critical Electric Field in BaTiO₃. -"J.Appl. Phys.", 1969, v. 40, N 8, p. 3118-3120.
- Иона Φ., Ширане Д. Сегиетоэлектрические кристаллы.
 Μ., "Мир", 1965, 555 с. с ил.
- Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков.
 М., "Наука", 1968.
- Смоленский Г.А., Бонов В.А., Исупов В.А. и др. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Л., "Наука", 1971, с. 32.
- 14. Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнетоэлектриков типа титаната бария. Рига, "Зинатне", 1971.
- 15. Сонин А.С., Струков Б.А. Въедение в сегнетоэлектричество. М., "Высшая школа", 1970, 272 с. с ил.
- 16. Вул Б.М. О нелинейных свойствах сегнетовлектриков. "Известия АН СССР. Сер.физ.", 1957, т.21, № 3, с. 379-381 с ил.

- 17. Кириллов В.В., Исупов В.А. Исследование зависимости реверсивной диалектрической проницаемости от напряжения поля в поликристаллическом ВаТіО₃ и твердых растворах (Ba,sr)тіО₃ выше температуры Кюри. "Известия АН СССР. Сер.физ.", 1967, т.31, № II, с. 1835—1838 с ил.
- 18. Кириллов В.В., Головщикова Г.И., Исупов В.А. Исследование диэлектрической поляризации Ватіо₃ и (Ва_х, Sr_{1-x})тіо₃ в импульсных полях в параэлектрической фазе. "Известия АН СССР. Сер.фив.", 1969, т. 33, № 7, с. II70-II72 с ил.
- 19. Турик А.В., Конаров В.Д., Чернышев К.Р. Исследование диэлектрических свойств некоторых типов химически чистой керамики ВаТіО3. "Электронная техника. Материалы", 1969, сер.14, вып.4(20), с.12-20 с ил.
- 20. Вербицкая Т.Н., Федотова В.Т., Черкудинов А.С. и др. Исследование дивлентрической проницаемости и потерь сегнетокерамики в параэлентрической фазе. — "Известия АН СССР. Сер.фив.", 1969, т.33, № 7, с.1176-1179 с ил.
- 21. Турик А.В., Сидоренко Е.Н., Жестков В.Ф. и др. Влияние постоянного электрического поля на диэлектрические свойства поликристаллического ВаТіО. "Известия вноших учебных заведений. Физика", 1972, № 10, с. 122-124 с ил.
- Звиргад Ю.А., Фрицберг В.Я. Микроскопическое исследование неоднородности сегнетокерамики методом индикации фазового перехода в поликристаллах. - "Физика и химия твердого тела", т.3, М., Изд-во НИИТЭХИМ, 1973.
- Вакс В.Г. О фазовых переходах типа смещения в сегнетоэлектриках. - "Хурвал экспериментальной и теоретической физики", 1968, т.54, вып. 3, с. 910-926 с ил.

- 24. Вакс В.Г., Галицкий В.М., Ларкин А.И. Тепловые колебания и эффект Мессбауара в области фазового перехода в сегнетоэлектриках. - "Журнал экспериментальной и теоретической физики", 1968, т.54, вып.4, с. 1172-1182 с ил.
- 25. Вакс В.Г. Корреляционные эффекты при фазовых переходах типа смещения в сегнетоэлектриках. - "Курнал экспериментальной и теоретической физики", 1970, т.58, вып.1, с. 296-308 с ил.
- 26. Graham H.C., Tallan N.M., Mozdiyashi K.S. Electrical Properties of High-Purity Polycrystalline Barium Titanate. "Journal of American Ceramic Society, 1971, v.54, N 11, c. 548-553.
- Фрицберт В.Я., Борман К.Я. Исследование спонтанной деформации и поляризации при фазовых переходах в сегнетоэлентрических твердых растворов со структурой перовскита. (См. настоящий сборник).
- 28. Mers W.J. Double hysteresis loop of BaTiO, at the Gurie point.-"Phys.Rev.", 1953, v.91, N 3, p. 513-517.
- 29. Фрицберг В.Я. Исследование нелинейности полиризации вблизи фавового перехода у перовскитовых сегнетовлектриков на модели ангармонического осциллитора. В кн.: Фазовие переходы в сегнетовлектриках. Рига, "Зиватне", 1971. с. 7-21.
- 30. Балагуров Б.Я., Гейликман М.Б. Дисперсия диэлектрической нелинейности в сегиетоэлектриках типа смещения. — "Физика твердого тела", 1972, т.14, № 8, с 2362-1368 с ил.
- 31. Пуриньм Э.Х., Фрицберг В.Я. Исследование электрострикции в неполярной фазе у сегнетовлектрических твердых растворов со структурой перомскита. (См. настоящий сборенк).

- 32. Синяков Е.В., Флёрова С.Л., Гаврилишина А.И., Астренина Е.А. Влияние одномерных механических напряжений на индупирование фазового перехода в керамике ВаТ.О.3. "Физика твердого тела", 1973, т.15, вып.4, с.1239.
- 33. Брок А.Я., Фрицберг В.Я., Такере З.А. и др. Экопериментальная проверка выполнения обобщенного закона Къри-Вейсса в системе твердых растворов со структурой перовскита. (См. настоящий сборник).
- 34. Кириллов В.В., Исупов В.А. Анизотропия диэлектрической поляризации кубической параэлектрической фазы перовскитовых сегнетоэлектриков. "Физика твердого тела", 1973, т.15, вып.8, с. 2502-2504.
- 35. Johnon K.M. Variation of Dielectric constant with Voltage in Perroelectrics and its Application to Parametric Devices. - "J.Appl.Phys.", 1962, v.33, N 9, p. 2826-2831.
- 36. Бербицкая Т.Н., Иванов И.В., Морозов Н.А. Диэлектрические и нелинейные свойства в СВЧ диапазоне поликристаллических твердых растворов на основе ВаТ.О3. -"Физика твердого тела", 1970, т.12, вып.5, с. 1578- 1580 с ил.
- 37. Von Hegenbarth E. Die Feldstärkeabhängigkeit der Dielektrizitätskonstenten von SrTiO₃ - Einkristallen im Temperaturbereich von I5 bis 80°K. - "Phys. stat. sol", 1964, v. 6. p. 333 - 336.

В.Я. Фрицберг, К.Я. Борман

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОНТАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА

BBEZEHNE

В течение первых лет исследований перовскитовых сегнетоэлектриков было установлено, что фазовые переходы (ФП) этих веществ сопровождаются значительной спонтанной деформацией, которая сравнительно легко фиксируется дилатометром средней чувствительности /I,2/. Таким образом, в руках исследователей оказалось эффективное средство для изучения кинетики сегнетоэлектрических ФП.

Особенное вначение дилатометрические измерерния приобретают при исследовании последовательностей (систем)сегнетоэлектрических твердых растворов (СТР), где обычно даже небольшое изменение концентрации компонентов влечет за собой сильное изменение параметров ФП.

В настонщей работе проводились исследования характера сегнетовлектрических фазовых переходов (СЭФП) в следующих системах твердых растворов: $I - (Ba, Sr)TiO_3$; $2-(Pb, Sr)TiO_3$; $3-(Ba, Pb)TiO_3$; $4-Ba(Ti, Zr)O_3$; $5-Ba(Ti, Sn)O_3$; $6-Pb(Mg, Ni)_{1/3}Nb_{2/3}O_3$; $7-Pb[(Mg, Zn)_{1/3}Nb_{2/3}]O_3$. Все исследованные образцы СТР - поликристаллические.

Если воспользоваться общей формулой ABO3, принятой для окисных перовскитов, то легко заметить, что в системах I-3 вамещение ионов проводится в подрешетке A, а в системах 4-7, соответственно, в подрешетке B.

Многие свойства систем I-6 были открыты и впервые исследованы в период 1950-1960 г.г. Смоленским и сотрудниками /3-7/.*) Тогда же была показана большая информативная ценность дилатометрических измерений.

На основанки предыдущих исследований была создана некоторая условная классификация СТР по характеру их СЭФП: системы I-3 обычно принято относить к СТР с четким ФП, системы 4-5 - к средне размытым и систему 6 - к СТР с очень размытым ФП. В основа такого подразделения лежит общий вид кривых диалектрической проницаемости & (Т). Более строгие количественные критерии степени размытия были сформулированы в работах /14,25/.

Дальнейшее развитие идей, изложенных в указанных работах (см. §2), позволяет прийти к выводу, что для ряда
систем СТР достаточно уверенная оценка степени размытия ФП
может быть проведена на основании дилатометрических измерений. Это побудило авторов провести настоящую работу, в
которой используется более совершенная измерительная техника в освокупности с вычислениями на ВВМ, необходимыми для
нелинейной экстраполяции экспериментальных кривых. Интерпретация результатов проводится на основе теории размытых
ФП /14,25/.

В коде работы для систем I-5 на основании дилатометрических измерений были установлены концентрационные зависимости следующих величин, характеризующих переход из тетрагональной фазы в кубическую:

- I) температуры перехода T.;
- 2) приведенного (путем экстраполяции) к температуре $T = T_{c}$ скачка линейной спонтанной деформации $\frac{\Delta l_{c}}{l}$
- приведенного (путем экстраполяции) к Т = Т_С скачка коэффициента линейного термического расширения
 ДС;
- 4) "аномальной" части экстремума коэффициента линей-

^{*)} Более полную библиографию по указанным СТР можно найти, например, в /9/.

ного термического расширения - $\alpha_{\rm ah}^{\prime}(T_{\rm c})$.

Наличие данных, указанных в 2) и 4), позволило путем расчета определить концентрационную зависимость величины размытия \mathcal{L} и впервые составить четкое представление о влинии замены ионов в подрешетках \mathbf{A} и \mathbf{B} на кинетику $\mathbf{\Phi}\mathbf{H}$. Данее, с привлечением некоторых дополнительных данных, удалось определить концентрационную зависимость объема элементарной области $\mathbf{\Phi}\mathbf{H}$ и величины приведенного к $\mathbf{T} = \mathbf{T}_{\mathbf{C}}$ скачка спонтанной поляризации $\mathbf{P}_{\mathbf{SC}}$.

Полученные данные легли в основу для некоторых выводов о влиянии замещения катионов на характер ФП в системах СТР.

Отметим, что указанную программу для систем I-5 удалось осуществить почти полностью за исключением составов с большой концентрацией PbTiO₃. В системах 6-7 эффекты спонтанной деформации оказались слишком малы и сам ФП слишком размыт для получения уверенных результатов.

В работе /13/ нами уже приводились некоторые данные дилатометрического исследования системы (Ва, Sr)Т103. В настоящей работе сообщаются дополнительные результаты.

§I. Связь термического расширения образца с температурной зависимостыр параметров элементарной ячейки

Для уточнения информативной ценности дилатометрических измерений первоначально целесообразно сравнить информацию, получаемую методом дилатометрии и методом рентгеноструктурного анализа.

На рис. I дана температурная зависимость параметров элементарной ячейки ВаТ103, полученная Квем и Вусденом /8/. Наше обращение к этой работе связано не только с ее высоким (для того времени) уровнем, а прежде всего с тем, что работы подобного рода в литературе крайне малочислении.По- этому несмотря на то, что работа /8/ была опубликована в

1949 году, указанный рисунок можно встретить во всех монографиях, посвященных сегнетоэлектричеству.

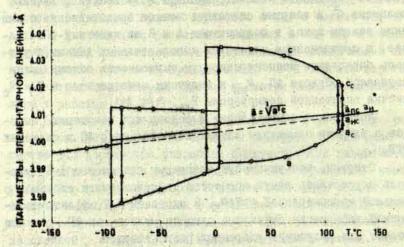


Рис. I. Температурная вависимость параметров элементарной ячейки ВаТіО, (по Квю и Вусдену /8/)

Необходимо иметь в виду, что для исследования температурной зависимости нараметров ячейки при ФП в перовскитах рентгеновским методом необходима специальная высокоточная аппаратура, обеспечивающая не только надлежащее экспонирование образда, но и длительное поддерживание заданной температуры в широком интервале с точностью не менее форособез ваметного градиента на образце. Кроме того, вблизи ФП наблюдаются своеобразные критические явления, указывающие на сложность механизма реального ФП. Эти эффекти не нашли отражения в работе /8/ и впервые более подробно были исследованы Кенцигом /II/.

В СТР на пути рентгенографического исследования ФП возникают дополнительные трудности — значительно снижается интенсивность рефлексов более высоких порядков, при малой тетраговальности ичении происходит перекрытие диффракционных максимумов, по моторым определяются значения парамет-

ров ячейки, область критических явлений вблизи ФП, где температурный ход параметров **а и с** сильно вуалируется, заметно возрастает. Все это ограничивает возможности применения редитеноструктурного анализа для исследования характера ФП в СТР.

Возвращаясь и рис.І отметии, что и приведенным данным следует отнестись критически. Во-первых, результаты, последующих дилатометрических измерений, например, работы /2/, а также настоящей работы, не подтверждают наличие положительных скачков деформации при ФП, имеющих место при температуре +5°C и -90°C, а свидетельствуют об их отрицательном знаке. Во-вторых, иохо /10/, проводивший исследование высокотемпературного ФП в Ватьоз (Тс = 120°C) усовершенствованным рентгеноструктурным методом в 1964 г. установил величину скачка объемной деформации

— 0,039 = 6,1°10-4, что почти в два раза отличается от данных работы /8/.

Следует подчеркнуть важную закономерность, хорошо видимую на рис. I и подтверждаемую рентгеновскими исследованиями ряда других перовскитов /I2/. Это плавное, монотонное изменение параметров ячейки в пределах данной фазы, которое, в частности, распространяется и на усредненный параметр ячейки в полярной фазе

$$\bar{a}_{n} = \sqrt{v_{ny}} = \sqrt{a^{2}c} \tag{1}$$

Экстраполяция зависимости $a_n(\mathbf{T})$ к температуре $\mathbf{T}_{\mathbf{C}}$ позволяет определить скачок усредненной спонтанной деформации $\Delta \bar{\alpha} = \bar{\alpha}_{\mathrm{RC}} - \alpha_{\mathrm{HC}}$. Так, например, для $\mathrm{BaTi}\,\mathbf{0}_3$, где такая экстраполяция может быть проведена вполне уверенно, используя данные /10/, имеем $\Delta \bar{\alpha} = 8.1 \cdot 10^{-4}$ Å.

Для наших целей важно установить, каким образом скачок усредненного параметра ячейки связан со скачком спонтанной деформации макроскопического образца. Относительная объемная деформация домена, состоящего из N ячеек. должна по величине совпадать с объемной деформацией отдельной ячейки

$$\left(\frac{AV_c}{V}\right)_{QQM} = \left(\frac{AV_c}{V}\right)_{QQ} = \frac{\alpha_c^2 c_c - \alpha_{HC}^3}{\alpha_{Hc}^3}$$
 (2)

Далее, если принять, что изменение объема отдельных доменов в кристалле происходит беспрепятственно и оно не свизано с изменением "междоменного" пространства (в поли-кристаллах, кроме того, с изменением "межкристаллитного" пространства), то выражение (2) должно быть пригодно для описания относительной объемной деформации всего образца*) В поликристаллических образцах, лишенных текстуры, каотическое распределение полярных осей доменов должно привести к одинаковой линейной относительной деформации

Дес образца в любом направленим.

Имея эвиду относительную объемную деформацию всего образца, выражение (2) можно переписать в форме

$$\frac{aV_{e}}{V} = 2 \frac{\alpha_{e} - \alpha_{He}}{\alpha_{He}} + \frac{c_{o} - \alpha_{He}}{\alpha_{He}}$$
 (3)

$$\frac{4V_{c}}{V} = 3 \frac{2\alpha_{0} + c_{0}}{3} - \alpha_{HB}$$
 (4)

Далве, учитывая, что $c-a \ll a$, преобразуем выражение (I)

$$\tilde{a}_n = \frac{3\sqrt{1+\frac{c-\alpha}{\alpha}}}{2} \approx \alpha(1+\frac{1}{3}\frac{c-\alpha}{\alpha}) = \frac{2\alpha+c}{3}$$
 (5)

Принимая во внимание малость относительной деформации, оправедиво состношение

Такое допущение, очевидно, справедливо для всех СТР исследованных в настоящей работе, кроме составов с большой концентрацией Рьт10-(х > 80 мол.%), где тетрагональность ячейки превышает некоторую критическую величину. Образцы таких СТР после нескольких циклов нагрева с прохождением через Т_с механически разрушались.

4/c = 3 4/a (6)

и поэтому вместо (4) с учетом (5), для температуры Т_с име-

 $\frac{\bar{\alpha}_{RC} - \alpha_{HC}}{\alpha_{HC}} \approx \frac{Alc}{l}$ (7)

Последнее выражение показывает искомую связь между изменением параметров ячейки и полной спонтанной деформацией макроскопического образца.

Для правильной интерпретации выражения (7) следует иметь в виду, что измеряемый в опыте температурный код деформации макроскопического образца отличается от спонтанной деформации отдельной ячейки, образующей вместе с группой других ячеек элементарную область перехода. представлениям теории размитых фазовых переходов /14,25/ в сегнетоэлектриках типа ВаТіОz, испытывающих ФП І рода, этот ФП происходит скачком, то есть, имеет точечный характер, только в микроскопических областях - элементарных областях перехода, - имеющих объем порядка 10-19 + 10-18 см3. же время макроскопические характеристики, какими, например, являются кривые термического расширения 4 (Т), снятые в области ФП, отражают накроскопический процесс растинутый в интервале температур в связи с эффектом, как динамического, так и статистического сосуществования Таким образом, ФП макроскопического образца He скачкообразным: на кривой 44 (Т) вместо скачка наблюдается более или менее крутой участок с точкой перегиба (рис. 2). Температурная область, занимаемая этимучастком, условно может быть названа "областью перехода". Точку перегиба тественно отождествить с температурой Т.

Следует отметить, что плавный монотонный характер кривой $\frac{4t}{t}$ (Т) вне области ФП, отражающий, согласно (5),соответствующий температурный ход усредненного параметра ячейки $\bar{\alpha}_{\Pi}$ (Т), позволяет при выполнении определенных условий (см. §3) провести нелинейную экстраполяцию кривой

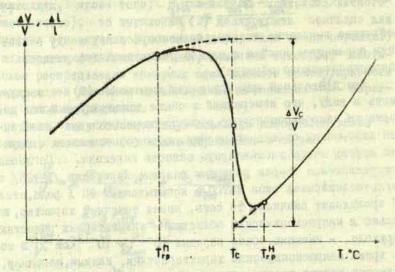


Рис. 2. Общий вид температурной зависимости относительного объемного (или линейного) термического расширения;
ти и ти - исходные точки экстраполяции из области полярной и неполярной фазы, соответственно

Правомерность указанной операции и её практическое вначение могут легко быть показаны на примере титаната бария. Действительно, на короших поликристаллических образцах методом экстраполяции дилатометрических измерений нами получено /I6/ $\frac{\Delta C_0}{V}$ = 2,08·10 или согласно (6), $\frac{\Delta C_0}{V}$ = 6,24·10 , что в пределах погрешности хорошо совпадает с регитеноструктурными данными работы /I0/ $\frac{\Delta C_0}{V}$ = 6,1·10 4.

Ниже будет показано (см. §2), что сопоставление макроскопического параметра перехода — аномальной части коэффициента линейного термического расширения (КЛТР)

— с величиной приведенного скачка спонтанной деформации
дает возможность на основании теории размытых ФП количественно оценить степень размытия исследуемого ФП, и таким образом решить важную задачу о нахождении зависимости характера ФП от состава в системах СТР.

Принимая во внимание (5) легко получить выражение, связывающее коэффициенты линейного термического расширения (КЛТР) параметров ячейки.

Действительно, КЛТР усредненного параметра элементариной нчейки **ā** имеет общий вид

$$\bar{\alpha}(T) = \frac{1}{\bar{a}} \cdot \frac{d\bar{a}}{d\bar{T}} = \frac{1}{2a+c} \left(2 \frac{da}{d\bar{T}} + \frac{dc}{d\bar{T}} \right) \tag{8}$$

и с учетом того, что $\alpha \approx c \approx \bar{\alpha}$, получаем для ячейки в полярной (тетрагональной) фазе

$$\vec{\alpha}_n = \frac{1}{3}(2\alpha_a + \alpha_c) \tag{9}$$

и в неполярной (кубической) фазе

$$\vec{\alpha}_{\mu} = \alpha_{\mu}$$
 (10)

Ввиду приведенных выше соображений относительно связи изменения усредненного параметра ячейки Δ (Т) с макроскопической карактеристикой Δ (Т), частный случай которой отражен в выражении (7), КЛТР усредненного параметра ячейки (8) в хорошем приближении должен быть равен КЛТР поликристаллического образца

$$\bar{\alpha}(T) = \alpha'(T) = \frac{1}{l} \cdot \frac{dl(T)}{dT} \tag{II}$$

Коэффициенты линейного и объемного расширения связаны обычным образом, где ≪ - объемный КТР:

$$\alpha = 3\alpha^{\ell}$$
 (12)

Комментируя выражения (9) и (10), следует отметить, что коэффициенты α_{2} , α_{c} и α_{H} , относящиеся к параметрам элементарной ячейки для исследуемых нами веществ имеют одинаковый порядок величины, однако $\alpha_{c} < 0$. Поэтому на кривых "макроокопических" α (T) всегда ветвь α_{Π} (T) проходит ниже чем α_{H} (T) (см. §4).

В заключении раздела, резюмируя сказанное, отметим, что зависимость 4 (Т), определяемая при помощи дилатометра на поликристаллическом образце в хорошем приближении отражает поведение усредненного параметра ячейки α (Т) и повволяет определить:

- I) температуру T_{c} по точке перегиба на кривой $\frac{4l}{l}$ (Т) или по точке экстремума на кривой \propto^{l} (Т), получае-мой из первой путем дифференцирования;
- 2) внак линейной или объемной деформации;
- 3) величину скачка $\frac{\Delta \ell_c}{\ell}$, если выполняются условия необходимые для уверенной экстраполяции кривой $\frac{\Delta \ell}{\ell}$ (Т) к точке $T = T_c$ со стороны тетрагональной фазы и кубической фазы соответственно;
- 4) величину скачка $\Delta \propto l = \propto l \propto l$ при выпол-

Таким образом, дилатометрические измерения, хотя и не заменяют рентгеноструктурные измерения в области ФП, но в некотором отношении могут дать равноценную и даже более полную информацию при использовании значительно более простых и дешевых средств.

§2. Теоретическое описание эффектол размытия сегнетоэлектрического фазового перехода в макроскопическом образце

Экспериментально полученная температурная зависимость относительного линейного расширения $\frac{A}{A}$ (Т) обычно весьма четко отражает температурный ход ФП, происходящего в реальном макроскопическом образце. Такой ФП всегда в некоторой степени размыт. Поэтому, в частности, КЛТР не стремится к бесконечности при $T = T_C$, как это предсказывает теория точечного ФП. Вследствии этого зависимость ∞ (Т) проходит через конечный экстремум, амплитуда которого зависит от степени размытия далного ФП.

Для достаточно полного изучения последовательностей (систем) СТР важно установить закономерности, которым подчиняется степень размытия ФП при постепенном изменении концентрации компонентов раствора. Ниже мы попытаемся теоретически обосновать возможность решения этой задачи и ввести понятие меры размытия ФП.

Теория размытых ФП дает следующее выражение для температурной зависимости коэффициента объемного термического расширения в области ФП /15,25/

$$\alpha(T) = \alpha_n(T) - 4\alpha(T)L(T) - \frac{4V(T)}{V} \cdot \frac{dl}{dT}$$
 (13)

где L(Т), так называемая, "функция включения",

$$\Delta V(T) = V_n(T) - V_n(T)$$
 If $\Delta \propto (T) = \alpha_n(T) - \alpha_n(T)$

(индексы"п" и "н" относятся к полярной и неполярной фазе, соответственно).

Функция включения L(T) имеет следующий вид /25/

$$L(T) = (1 + \exp y)^{-1}$$
 (14)

где

$$y = \frac{\overline{\xi} - \overline{\Gamma}}{\overline{\xi}} \tag{15}$$

Согласно /25/ множитель **≰** можно выразить через основные параметры ФП

 $\xi = \frac{\kappa T_c^2}{V_{50} Q_c} \tag{16}$

где T_0 - температура ФП, V_{30} - объем элементарной области ФП, Q_e - скрытая теплота ФП, к - постоянная Больцмана.

Производная функции вилючения следует из (14)

$$\frac{dL}{dT} = \frac{1}{2\xi} (1 + ch y)^{-1} \tag{17}$$

Легко заметить, что при температуре ФП

$$L(\mathcal{T}_{\epsilon}) = \frac{1}{2} \tag{18}$$

$$\frac{dL}{dT}(T_0) = \frac{1}{4E} \tag{19}$$

Из выражений (I4), (I5), (I7) и (I9) ясно, что величина ξ^{-1} является мерой крутивны функции L(T) при $T=T_{C}$ и характеризует степень "четкости" ФП. Поэтому вполне естественно обратную величину — ξ рассматривать в качестве меры размытия ФП. ξ

Подставляя (18) и (19) в (13), имеем для $T = T_C$

$$\alpha(T_c) = \alpha_n(T_c) - \frac{1}{2} \alpha \alpha_c - \frac{1}{4\xi} \cdot \frac{aV_c}{V}$$
 (20)

^{*)} Напомним, что ξ связан с "полушириной" Δ Тан кривых $C_{aH}(T)$ и $\propto_{aH}(T)$, введенной в работе /25/, следую- шим образом: Δ Тан = 1,76 ξ .

Физический смысл величин $\frac{4V_c}{V}$ и $4\alpha_c$, получаемых путем экстраполяции, понятен из рисунков 2 и 3. Теория размытых ФП, таким образом, при помощи функции L (T) связывает измеряемую в опыте величину α (T_c) с приведенными путем экстраполяции к $T = T_c$ характеристиками ФП $-\frac{4V_c}{V}$ и $4\alpha_c$. Последний член в выражении (20) представляет собой "аномальную" часть коэффициента термического расширения при $T = T_c$

 $\alpha_{au}(T_c) = \frac{1}{4\xi} \cdot \frac{AV_c}{V} \tag{21}$

Из (21) следует, что знание величин $\alpha_{\rm ah}(T_{\rm c})$ и $\frac{\Delta V_{\rm c}}{V}$ позволяет определить меру размытия ξ данного $\Phi\Pi$. Существенно, что для этого достаточно наличие одних только дилатометрических данных.

Для нахождения \propto aн(T_c) можно использовать выражение (20), переписав его в форме

$$\alpha_{an}(T_c) = \alpha_n(T_c) - \alpha(T_c) - \frac{1}{2} \Delta \alpha_c \qquad (22)$$

На практике удобно определить $\alpha_{\rm ah}(T_{\rm c})$ непосредственно из графического построения, проведенного в соответствии c(22) (см. рис. 3), где предварительно находятся величины $\alpha_{\rm n}(T_{\rm c})$ и $\Delta \alpha_{\rm c}$ по данным экспериментальной кривой α (Т) (на рис. 3 изображен типичный для наших образцов случай отрицательной спонтанной деформации Δc об, когда измеряемые α ($T_{\rm c}$) и $\Delta \alpha_{\rm c}$ оба имеют отрицательные знаки). Естественно, что нахождение $\Delta \alpha_{\rm c}$ возможно, если выполняются условия экстраполяции, о которых более подробно пойдет речь в следующем разделе. Переход от величин α к α происходит в соответствии с соотношением (12).

Выражения (16) и (21) позволяют дальше связать определенную вышеуказанным способом величину С с объемом элементарной области перехода V₃₀. Полутно желательно заменить трудно определяемую величину С на другие - более доступные, что можно сделать используя формулу Клапейрона-Клаузиуса для слвира температуры ФП под действием гидроотатического давления (р)

$$\frac{\partial T_c}{\partial \rho} = \frac{\Delta V_c}{V} \cdot \frac{T_c}{Q_c} \tag{23}$$

Тогда с учетом выражений (16), (21) и (23) получаем

$$\propto an(T_c) = \frac{v_{20}}{4\pi T_c} \left(\frac{\Delta V_c}{V}\right)^2 \left(\frac{\partial T_c}{\partial p}\right)^{-1}$$
 (24)

Последнее выражение позволнет по известным из опыта данным определить объем V_{30} . Концентрационная зависимость V_{30} , также как и зависимость ξ , представляет значительный интерес при исоледовании систем СТР.

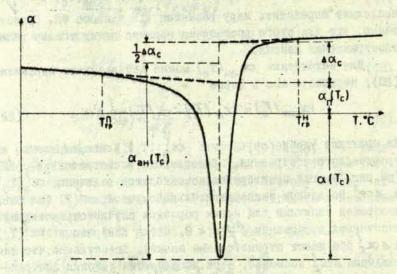


Рис. 3. Общий вид температурной зависимости коэффициента термического расширения; T_{rp}^{n} и T_{rp}^{H} — исходные точки экстраполяции из полярной и неполярной фазы, соответственно

Следует также отметить (см. работу /16/), что знание величин $\frac{\partial T_G}{\partial p}$, $\frac{\Delta V_C}{V}$, а также постоянной Кюри-Вейсса C_W , позволяет определить приведенный скачок спонтанной поляри-

зации P_{SC} при $T = T_C$, в то время как определение скачка P_{SC} прямымы методами /17/ в поликристаллах практически невовможно. Для получения соответствующей формулы расчета следует в (23) заменить Q_C хорошо известным выражением, следующим из термодинамической теории ФП /18/,

$$Q_{c} = \frac{1}{2} \frac{T_{c}}{C_{W}} P_{sc}^{2}$$
 (25)

Тогда на основании (23) получаем формулу для расчета Р_{эс}, данную впервые в работе /29/,

$$P_{SC}^{2} = 2C_{W} \frac{\Delta V_{C}}{V} \left(\frac{\partial T_{C}}{\partial \rho}\right)^{-1} \tag{26}$$

В заключение сделаем несколько замечаний в отношении величин $\frac{\partial T_c}{\partial P}$ и C_W , входящих в выражения (24) и (26).

Первая величина известна не для всех исследованных нами твердых растворов. Наиболее детально концентрационные зависимости $\frac{\partial T_c}{\partial \rho}$ исследовались для системы (Ba,Sr)TiO₃ /I9/; некоторые данные имеются для системы Ba(Ti,Zr)O₃ /20/ и Ba(Ti,Sn)O₃ /2I/. Известно значение $\frac{\partial T_c}{\partial \rho}$ для поликристаллического PbTiO₃ /22/.

Изучение доступных в настоящее время данных позволяет сделать вывод, что $\frac{\partial T_C}{\partial p}$ в последовательностях интересующих нас СТР меняется в пределах не более 60%. Учтем, что в то же время величина $\frac{\partial C}{V}$ меняется в десятки раз, а $\propto_{\rm ah}(T_C)$ — на несколько порядков. Это позволяет, при необходимости определения величины $\frac{\partial T_C}{\partial p}$ отдельных СТР для дальнейшей подстановки её в формулы (24) и (26), воспользоваться методом линейной интерполяции, когда известны ее значения для отдельных составов. Соответствующие литературные данные для поликристаллических образцов приведены в таблице:

Состав	$\frac{\partial T_c}{\partial p} \cdot 10^3$, °C·arm ⁻¹	Литература
BaTiO,	and paragraph, 2 annumber	/19/
Ba(Tio,90Zro,10)03	-3,8	/20/
Ba(Tio,908no,10)03	-2,5	/21/
PhTiO,	-6,7	/22/
(Ba _{0,05} Br _{0,95})T10 ₃	-7,3	/23/

Необходимые данные о постоянной С_м нами брались из концентрационных зависимостей этой величины, определенных в работе /24/, публикуемой в настоящем сборнике.

§3. Методика эксперимента и обработки данных

Кривые удлинения 4 (Т) снимались на уникальном механическом дилатометре, где удлинение образца передается посредством кварцевых трубок на механический микрокатор, имеющий чувствительность 0,005 мм/дел. Используя оптическое приспособление, чувствительность установки была доведена до I,2·10-5 см/дел. и имела точность отсчета ± 0,1. •10-5 см. Такая точность отсчета была достигнута, благодаря: а) устранению механических вибраций дилатометра. б) термостатированию механической и оптической измерительных частей дилатометра (стабилизация температуры в пределах +0,020с), в) линейному росту средней температуры разца во времени, учитывая, что нелинейность нагрева приводит и неравномерному нагреву кварцевих трубок, который, в свою очередь, вынуждает вводит поправочные ковффициенты (на расмирение кварца) при данной температуре и данном ускорении роста температуры.

Изменение температуры образца осуществлялось в пределах от 80 до 880°К, с помощью двух нагревателей - основного и стабилизирующего. Внимание заслуживают меры по устранению температурных градиентов в образце:

- корпус основного нагревателя изготовлен из длинного, массивного, латунного цилиндра, который уменьшает продольные градиенты температуры;
- для уменьшения радиальных градиентов в образце, последний помещался в толстостенное кольцо из пенокерамики (термоизоляция), длина которого была почти равна длине образца;

для устранения конвекции газа, применялись пенокерамические прослойки.

Кривые удлинения снимались исключительно в режиме нагрева, который в основном велся методом "ступеней" с интервалом от 3 до 0,05°С, в зависимости от близости к температуре ФП. На каждой "ступени" образец автоматически термостатировался с точностью ±0,01°С и при этой температуре выдерживался; от 5-10 минут вдали от фазового перехода и до 10-30 минут в области фазового перехода. Вне области фазового перехода медленный непрерывный нагрев дает результаты вполне совпадающие с результатами ступенчатого нагрева.

Образцы изготовлялись по обычной керамической технологии и имели размеры 4 х 5 х 23 мм. Отбор образцов для
измерения проводился по следующим параметрам: внешний вид
- отсутствие трещин, макроскопических пор, цвет - однородный по всей поверхности; плотность - отличие гидростатической плотности образца от рентгенографической не должна
превышать 6%; величина зерен - в пределах от 5 до 20 микрон.

Термическое расширение измерялось вдоль длины образца. Боковые поверхности (5 х 23 мм) образца посеребрены, что дает возможность, одновременно с удлинением, измерять диэлектрическую проницаемость. Исходной характеристикой исследуемого явления являетоя температурная зависимость относительного линейного удлинения $\frac{\mathcal{A}(T)}{T}$, дальнейшая математическая обработка которой (дифференцирование по температуре) приводит к температурной зависимости КЛТР - ∞ (Т). Объемные эффекты с достаточной степенью точности могут быть выражены формулами (6) и (12).

Первоначальная стадия математической обработки данных ваключается в дифференцировании зависимости $\frac{\Delta \ell}{\ell}$ (Т) при помощи ЗВМ. Это осуществляется по стандартному алгоритму: на исходном (достаточно малом) участке берутся 5 точек кривой и проводится аппроксимация полиномом 2-ой степени (контрольная аппроксимация — полиномом 3-ей степени) по методу наименьших квадратов. Производная определяется для средней точки участка. Далее опять берутся 5 точек, из которых 4 принадлежат предыдущему участку, а I — следующему; проводится аппроксимация и опять находится производная для средней точки, и т.д. Каждая следующая точка подключается через интервал 0,01 + 30, в зависимости от характера дифференцируемой кривой.

Для определения приведенных скачков $\frac{\Delta l_c}{\ell}$ применялся метод нелинейной экстраполяции из точки $T_{\Gamma p}^H$ к T_c в полярной фазе и из точки $T_{\Gamma p}^H$ к T_c в неполярной фазе (см. рис. 2). Как известно /25/, в случае достаточно малого размытия $\Phi \Pi$ нелинейная экстраполяция с успехом может быть проведена при помощи SBM (в нашем случае использовалась электронновичислительная машина GE-415).

Условия возможности экстраполяции сводятся к следующему:

- Т) температурная вависимость экстраполируемого параметра должна быть непрерывной, монотонной и гладкой в каждой из фаз (полярной и неполярной) вплоть до $T = T_C$;
- 2) каждый кусок подлежащий экстраполяции (опорной) кривой соответственно, в интервалах $T \leqslant T_{\mathbf{rp}}^{\Pi}$ и $T \geqslant T_{\mathbf{rp}}^{H}$, должен быть значительно (примерно, на порядок) больше, чем экстраполяционный участок (соответственно, $T_{\mathbf{rp}}^{\Pi} + T_{\mathbf{c}}$ и $T_{\mathbf{c}} + T_{\mathbf{rp}}^{H}$).

В СТР на основе $\mathrm{BaTiO_3}$ первые условие обычно выполняется (см.рис.І), в то же время вполне естественно, что при очень размытом ФП (в соответствии с /25/ Δ $\mathrm{T}_{\Phi\Pi}$ > 6 ξ > 60°) второе условие становится практически невыполнимым.

Приведем порядок осуществления экстраполяции и нахождения приведенного скачка спонтанной деформации:

- а) дифференцирование исходной кривой $\frac{2l}{l}$ (Т) и определение вида зависимости α' (Т);
- б) установление местоположения точки T_c по минимуму кривой $\infty'(T)$;
- в) установление полуширин пика $\infty_{AH}^{\ell}(T)$: ΔT_{AH}^{Π} и ΔT_{AH}^{H} но данным кривой $\infty^{\ell}(T)$;
- г) определение граничных точек $T^\Pi_{{f r}\, p}$ и $T^H_{{f r}\, p}$, иоходя из соотношений, полученных в работе /25/

$$T_{Pp}^{H} = T_{C} + \frac{b}{3,52} \Delta T_{AH}^{H}$$

$$T_{Pp}^{II} = T_{C} - \frac{b}{3.52} \Delta T_{AH}^{II},$$
(27)

где при определении границ $\Phi\Pi$ с точностью 5% - b = 5,9 и при точности 1% - b = 9,2;

- д) точки $T_{\mathbf{r}p}^{\Pi}$, $T_{\mathbf{r}p}^{H}$ отмечаются на кривой $\frac{\Delta \ell}{\ell}$ (Т) и участки I) от первой точки до $T_{\mathbf{r}p}^{\Pi}$ и 2) от $T_{\mathbf{r}p}^{H}$ до последней точки аппроксимируются полиномом 2-ой степени (для контроля проводится аппроксимация полиномом 3-ей степени);
- е) проводится экстраноляция I-го участка к $T = T_C$ и определяется точка ℓ_{CH} ; проводится экстраноляция 2-го участка на $T = T_C$ и определяется точка ℓ_{CH} ;
 - ж) находится искомый приведенный скачок Alc= lcn-lcн-

Отметим, что такая методика должна давать величину Δl_{c} , практически не зависящую от эффектов размития.Последнее гарантирует, что ξ , получаемое в соответствии с фор-

мулой (21), которую преобразуем к виду
$$\frac{\Delta l_c}{V}$$
 (28)

будет определено достаточно "чисто", то есть, с минимальным виладом других механизмов размытия дополнительно к тому, который описывается моделью элементарных областей ФП /25/. Единственным потенциальным источником такого дополнительного вилада остается величина $\alpha_{\rm ah}(T_{\rm c})$, которая определяется в самой области ФП. Дополнительные механизмы размытия занижают $\alpha_{\rm ah}(T_{\rm c})$ и увеличивают ξ . Величину вклада дополнительных механизмов можно приближенно оценить, оравнивая ξ из /28/ с ξ , полученным по формуле $O=352\xi^{\rm c}$, где ширина O непосредственно измеряется на полувысоте пика $\alpha_{\rm ah}(T)$ (см. §4).

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Приступая и анализу экспериментальных результатов исследованных систем, прежде всего отметим, что концентрационные зависимости температуры тетрагонально-кубического ФП $T_c(x)$ близки и линейным и вдесь не обнаружены существенные отличия от ранее полученных данных /3,4,5,6/.*) Поэтому графический вид этих вависимостей мы приводить не будем. Далее рассмотрим по порядку концентрационные зависимости параметров ∞ , Δc , Δc , Δc , Δc

^{*)} Некоторое отличие ваключается в том, что в более ранних работах T_{c} определялось по максимуму кривой ε (T), в то время как в настоящей работе T_{c} устанавливается по точке перегиба кривой Δ (T). Отметим, что $T_{c} > T_{c}$ с разностью нескольких градусов.

I. Начнем с рассмотрения общего характера кривых $\infty^{\ell}(T)$ для систем СТР, где замена ионов производится в подрешетке A (тип $A_{T} \to A_{2}$).

На рис. 4^8 и 4^6 отчетливо видно, что по мере возрастания концентрации \mathbf{srtio}_3 глубина пиков постепенно уменьшается. Однако, не следует полагать, что одновременно монотонно должно возрастать размытие $\Phi\Pi$. Последнее, как следует из рис. \mathbf{II}^8 и \mathbf{II}^6 , проходит через максимум в середине интервала концентраций. Интересно отметить, что $\mathbf{x}(\mathbf{T_0}) = \mathbf{0}$ в системе (\mathbf{Ba},\mathbf{sr}) \mathbf{Tio}_3 при 65 мол. \mathbf{x} \mathbf{srtio}_3 и в системе (\mathbf{sr},\mathbf{Pb}) \mathbf{Tio}_3 при 80 мол. \mathbf{x} \mathbf{srtio}_3 . Это означает, что здесь на кривой \mathbf{x} (\mathbf{T}) в точке \mathbf{T} = $\mathbf{T_0}$ спад переходит в плато, производная обращается в нуль и согласно выражению (9) можно сделать вывод, что для указанных СТР при $\mathbf{\Phi}\Pi$ выполняется условие $\mathbf{2x_0} = \mathbf{1x_0}$

Из рис. 4^В следует, что в системе (Ва, Рв) т10₃ глубина пиков проходит через минимум при малой концентрации Рьт10, и быстро возрастает при ее увеличении (см. также рис. 967. Необходимо отметить, что подобная аномалия - отступление от монотонности концентрационной зависимости в области малых концентраций рьт10, - у этой системы наблюдается и для других параметров: уменьшение глубины пиков сопровождается усиленным размытием (рис. II^B) и сокращением скачков Аle $(puc. 6^{6})$ и P_{ec} $(puc. 13^{6})$. Следует подчеркнуть, что исследование образцов методом микроскопирования в интервале концентраций, где наблюдаются аномалии, не выявило ощутимого отличия их структуры по сравнению с другими образцами той же системы (та же величина кристаллитов, их форма, плотность упаковки и др.). Поэтому причины возникновения отступлений от монотонности следует, по-видимому, глубже - в перестройке механизма спонтанной поляризации, охватывающей некоторый интервал концентраций. Возможно, что такое поведение вызвано изменением характера колебания мягкой оптической моды, которая вначительно отличается по величине вкладов координат симметрии S. (слетеровская мода)

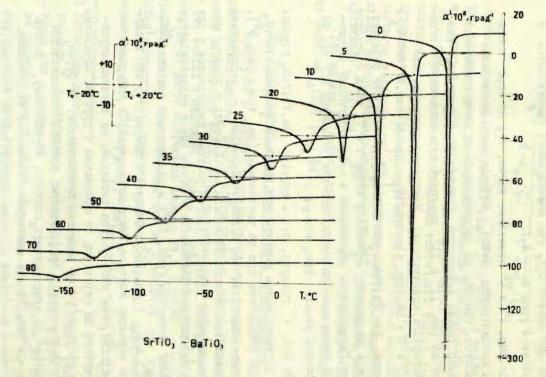
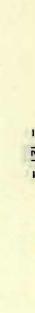


Рис. 4^а. Температурная зависимость КЛТР — \propto для системы (Ba,Sr)TiO3: x — концентрация SrTiO3 в мол.%



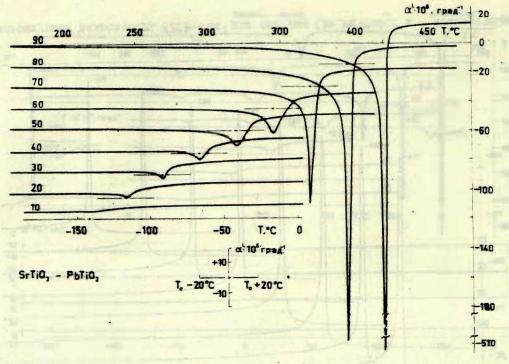
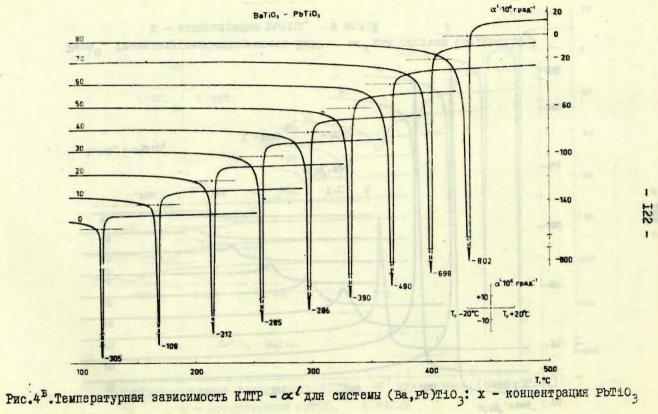


Рис4⁶. Температурная зависимость КЛТР - «Для системы (Sr, Fb)Ті03: x - концентрация Рьт103 в мол.%





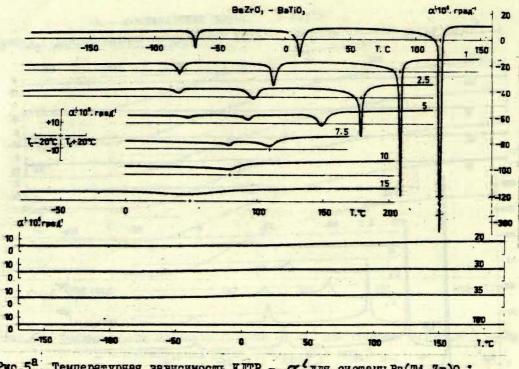


Рис.5^а. Температурная зависимость НЛТР - см. для системы Ва(Ті, Zr)03: х - концентрация ВаZrO3 в мол.%



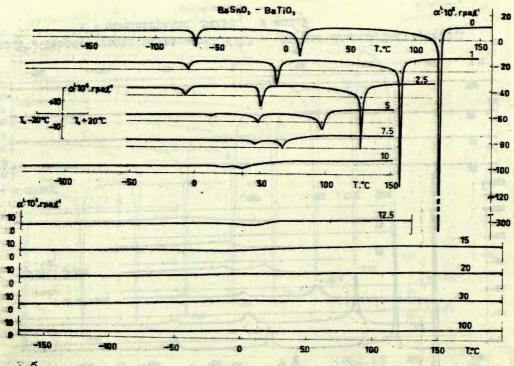


Рис. 56. Температурная зависимость КЛТР - « для системы Ва(Ti,Sn)03: х - концентрация ВаSnO3 в мол. %

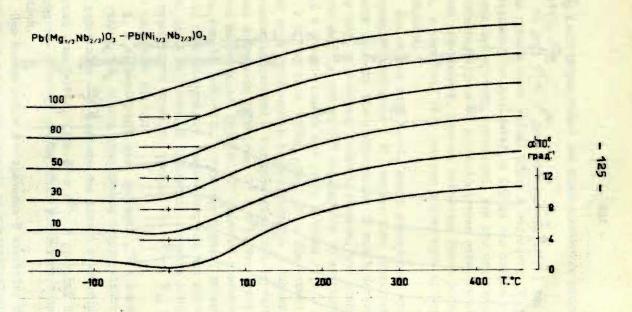
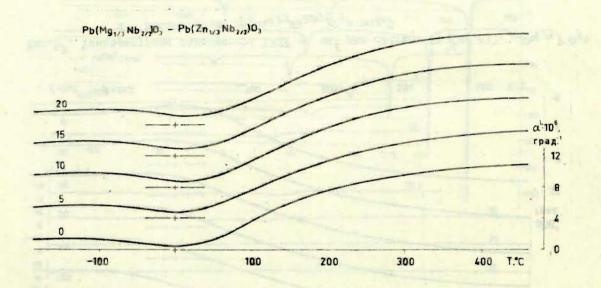


Рис. 5^B. Температурная зависимость КЛТР — \propto для системы Рь (Mg, Ni) $_{1/3}$ Nb $_{2/3}$ $_{1/3}$ Nb $_{2/3}$ Nb $_{2/3}$ Nb $_{2/3}$ мол. %



126 -

Рис. 5°. Температурная зависимость КЛТР – ∞ для системы Рь [(Mg, Zn)_{1/3}Nb_{2/3}]03: х – концентрация Рь(Zn_{1/3}Nb_{2/3})03 в мол.%

и S₂ (ластовская мода) для кристаллических решеток Ват103

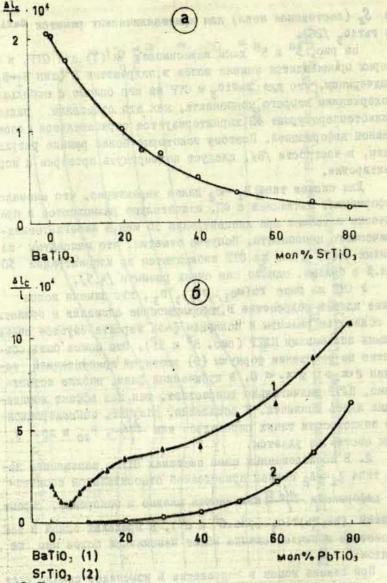
и Рьтіо, /26/.

на рис. 5^8 и 5^6 даны вависимости $\propto^l(T)$ для СТР, в которых производится замена ионов в подрешетке В (тип В $_1$ -В $_2$). Подчеркнем, что для $_3$ и СТР на его основе с небольшим содержанием второго компонента, как это отчетливо видно, низкотемпературные ФП характеризуется отрицательной спонтанной деформацией. Поэтому некоторые более ранние результаты, в частности /8/, следует подвергнуть проверке и корректировке.

Для систем типа $B_1 - B_2$ далее характерно, что аномалии деформации, связанные с $\Phi\Pi$, значительно размываются и практически исчезают при концентрации IO мол.% несегнетоэлектрического компонента. Попутно отметим, что максимумы на кривых e(T) в тех же СТР наблюдаются до концентраций 30 мол.% и больше, однако они очень размыты /4,5/.

- у СТР на базе $Pb(M_{B_1/3}Nb_{2/3})o_3$, где замена ионов также идет в подрешетке B, деформационные аномалии в области ФП полностью размыты и полярная фаза характеризуется очень малыми значениями КЛТР (рис. 5^B и 5^C). Это может быть объяснено на основании формулы (9) взаимной компенсацией величин $2 \propto_a > 0$ и $\propto_c < 0$. В кубической фазе, вполне естественно, КЛТР значительно возрастает, так как эффект компенсации здесь исключен. К сожалению, получить концентрационные зависимости таких параметров как $\frac{\Delta c}{l}$, P_{gc} и др. у этих систем не удается.
- 2. В исследованных нами системах СТР с замещением ионов типа $A_1 - A_2$ скачок приведенной относительной спонтанной деформации —— изменяется плавно и монотонно, кроме системы (B_2 , P_5) T_{10} 3 (рис. 6^a и 6^o). В пределах одной и той же системы величина скачка может изменяться более чем на порядок.

При замене ионов в подреметке В изменение скачка идет более резко и при концентрации несегнетоэлектрической компоненты 15 мол.% он практически падает до нуля (рис. ?). Следует отметить, что при больших концентрациях Рътіо



Рыс. 6. Концентрационная зависимость приведенного скачка относительной линейной спонтанной деформации при Т-Т_с для систем с замещением ионов в подрешетке А

спонтанная деформация достигает величины $\frac{4l_c}{\ell} > 10^{-3}$, что, возможно, обусловливает наблюдаемую механическую нестабильность (растрескивание) образцов, близких по составу к чистому Рът10 $\frac{1}{3}$.

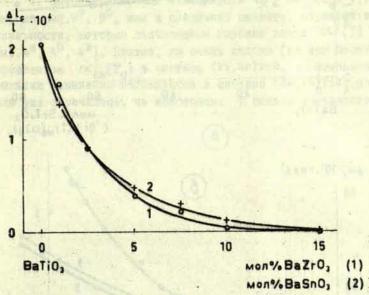
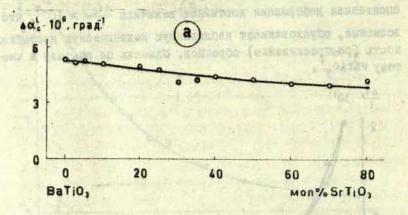


Рис. 7. Концентрационная зависимость приведенного скачка относительной линейной спонтанной деформации при Т=Т_С для систем с замещением ионов в подрещетке В

3. Величина скачка $\Delta \propto_C^2$ может служить в качестве меры перестройки кристаллической решетки при $\Phi\Pi$. Из рис. 8° , например, видно, что $\Delta \propto_C^2$ сильно возрастает с увеличением концентрации ${\rm PbTio}_3$. Последнее вполне понятно, так как увеличивается тетрагональность ячейки в полярной фазе. Когда $\Phi\Pi$ происходит при низких температурах, скачек $\Delta \propto_C^2$ нескольно увеличивается за счет крутого спада "основной" кривой ∞ (Т) в области $T < \theta$, где θ — температура Дебан.Последнее вообще характерно для СТР с большой концентрацией ${\rm SrTio}_3$ (рис. $8^{\rm S}$).

Для систем $Ba(Ti, Zr)O_3$ и $Ba(Ti, Sh)O_3$ не удается получить четкой концентрационной зависимости $\Delta \propto_C^2$ ввиду того,



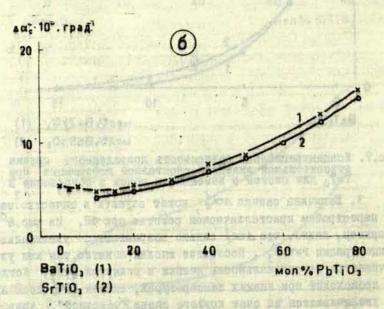


Рис. 8. Концентрационная зависимость приведенного скачка КЛТР при $T = T_{\rm C}$ для систем с замещением ионов в подрешетие A

OTON YEARS AND AND AND DESIGNATION OF THE PROPERTY OF ANY

что автрудняется экстраполяция кривой \propto (T) к T = T_C со стороны полярной фазы по причине сближения и перекрытия температурных областей всех трех фазовых переходов (см. рис. 5^8 и 5^6).

4. Концентрационные зависимости $(g L^{-\alpha}_{ah}(T_c)_{-7},$ видимые на рис. 9^a , 9^o , как и следовало ожидать, отражают закономерности, которым подчиняются глубины пиков (T) (см. рис. 4^a , 4^o , 4^b). Плавно, но очень сильно (на три порядка) изменяется (T_c) в системе $(P_b, S_r)^{10}_3$. Относительно меньшие изменения наблюдаются в системе $(B_a, P_b)^{10}_{3}$, но они, как уже отмечалось, не монотонны. В полном соответствии с

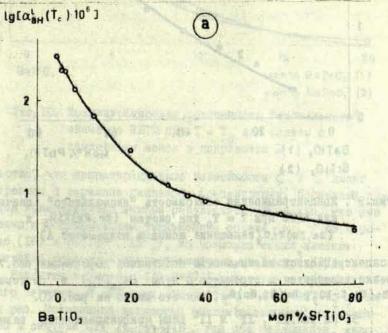


Рис. 9⁸. Концентрационная зависимость "аномального" значения КЛТР при $T = T_C$ для системы (Ва, 8г) T10 (замещение ионов в подрешетие A)

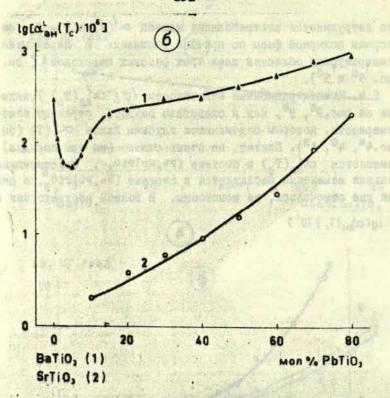


Рис. 9⁶. Концентрационная зависимость "аномального" значения КАТР при $T = T_0$ для систем (Sr.Pb) Tio_3 и (Ba,Pb) Tio_4 замещение ионов в подрешетие A)

нонцентрационной зависимостью спонтанной деформации(рис.7) резко изменяется и стремится к нулю $\propto_{\mathrm{at}}^{\ell}(T_{\mathrm{c}})$ в системах $\mathrm{Ba}(\mathrm{Ti},\mathrm{Sr})\mathrm{O}_3$ и $\mathrm{Ba}(\mathrm{Ti},\mathrm{Sn})\mathrm{O}_3$, как это видно на рис. IO .

5. На рис. II^8 , II^6 и II^8 даны концентрационные вависимости размытия ξ и четкости ξ для систем СТР типа $A_1 - A_2$. Напомним, что любая из названных величин была получена путем сопоставления глубины пика аномалии $\propto_{ah}^{\ell}(T_c)$ и скачка приведенной линейной деформации $\frac{A\ell_c}{\ell}$, в соответствии с формулой (28). Обращает на себя внимание то обстоя-

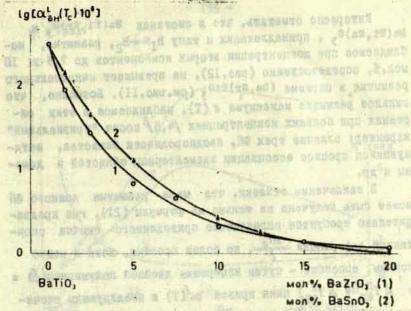


Рис. IO. Концентрационная зависимость "аномального" вначения КЛТР при $T = T_C$ для систем с замещением ионов в подрешетие В

тельство, что концентрационные зависимости & и & имеют вистремумы в середине диапазона концентрации. Последнее является принципиально важным результатом. Возможно, что это свявано с форсированным уменьшением объема V_{во} Гем.выражение (16) и рис.15⁸, 15⁰, но возможно также влияние флуктуаций состава в микрообъемах меньше I мкм /27/.

Размитие в системе (Ва, Sr)Т10, меняется в пределах одного норядка, в системах (Рь, Sr)Т10, и (Ва, Рь)Т10, около трех раз. Повышенной четкостью (малым размитием) отличаются фП в системе СТР (Ва, Рь)Т10, где оба компонента неляются сегнетоэлектриками. Эта система имеет дополнительный максимум размития в области малых концентраций РьТ10, где как мы видели, наблюдаются аномалии и других концентрационных зависимостей. Сравнительно большое размытие (абсолютное значение 5) наблюдается в системе (Рь, Sr)Т10, (рис. II)

Интересно отметить, что в системах $Ba(Ti, Zr)O_3$ и $Ba(Ti, Sh)O_3$, принадлежащих к типу $B_1 \rightarrow B_2$, размитие, наблюдаемое при концентрации вторых номпонентов до 7,5 и 10 мол.%, соответственно (рис. I2), не превыщает максимального размития в системе ($Ba, Sr)TiO_3$ (см. Dис. II). Возможно, что сильное размитие максимума s (T), наблюдаемое в этих сметемах при больших концентрациях /4,5/ носит "тривиальный" характер: слияние трех ФП, неоднородности вещества, затянувшийся процесс ассоциации элементарных областей в домены и др.

В заключение отметим, что мера размытия данного ФП может быть получена не только из формулы (21), где предварительно требуется определение приведенного скачна тонии, способом - путем измерения двойной полуширины(D = Д ТП + Д ТВ) пина кривой ∞ (Т) и последующим расчетом по формуле Q = 3,52 \$ /25/. Полученная, таким обравом, мера размытия вилючает, однано, вилад дополнительных механизмов размытия (например, влияние неоднородности химического состава и физического состояния), которые не учитываются при выводе (21) на основании модели влементарных областей ФП (см. $\S 2$). Поэтому, всегда $\xi^{0} > \xi$, как это видко из рис. II⁸, II⁰, II³ и I2. Общий вид зависимостей & (x) и & (x) значительно не отличается, однако харантерно, что видад посторонних механизмов больше в типа A₁ — A₂ с преобладанием компонента SrTiO₃. То же соот-ношение между с и с сохраняется в системе (Ba, Pb) тіО₃ во всей области концентраций, включая район "аномалии" (рис. II^B). Вилад посторонних механизмов весьма велик в СТР Tuna By -B, (puc.12).

6. На рис. 13⁶ и 13⁶ ноказани концентрационные зависимости приведенного скачка спонтанной поляризации Р₄₀, расчитанного по формуле (26) для систем (Ва, Вг) Т10₃, (Вг, Рв) Т10₃ и (Ва, Рв) Т10₃. В первой системе Р₄₀ изменяется весьма плавно, но нелинейно. Для ват10₃, использун при расчете

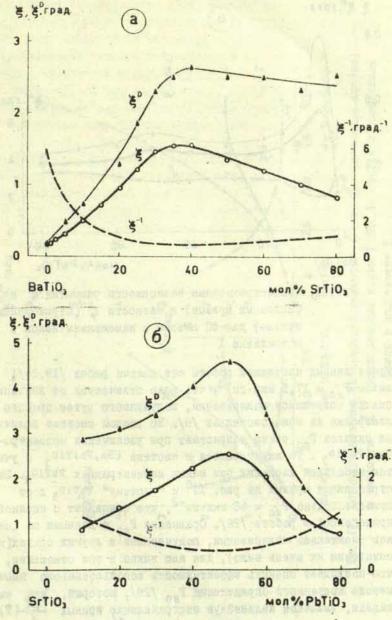


Рис. II. (подпись см. на следующей странице)

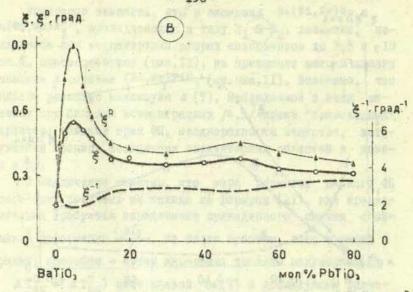


Рис. II. Концентрационные зависимости размытия & и & ... (сплощные кривые) и четкости & (штрихованные кривые) для ФП систем с замещением ионов в подрешетке A

кроме данных настоящей работы еще данные работ /19,24/, имеем $P_{SC} = 17.5$ мкк-см⁻², что мало отличается от значения скачка спонтанной поляривации, полученного путем прямого измерения на монокристаллах /9/. Во второй системе величина скачков P_{SC} резко возрастает при увеличении концентрации Рътіо₃. То же относится к системе (Ва.Ръ)тіо₃ с учетом небольшой аномалии при малых концентрациях Рътіо₃. Экстраполяция кривых на рис. 13° к "чистому" Рътіо₃ дает приблизительно $P_{SC} = 40$ мкк-см⁻², что совпадает с оценкой, приведенной в работе /28/. Сравнение P_{SC} с данными по скачкам спонтанной поляривации, полученными в других опытах(к сожалению их очень мало), для нас важно в том отношении, что позволяет оценить эффективность использованного нами метода косвенного определения P_{SC} /29/, который, как, мы видели, вилючает нелинейную экстраполяцию кривых —4 (Т) для установления приведенного скачка



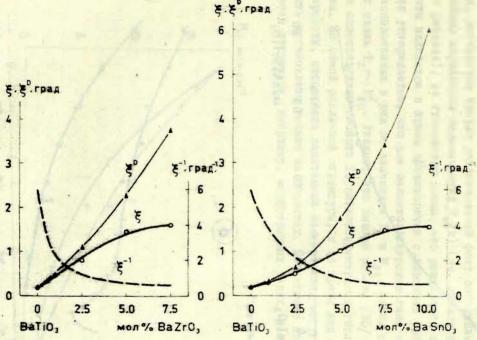


Рис. 12. Концентрационные зависимости размытия ξ и ξ^{o} (сплошные кривые) и четкости ξ^{o} (штрихованные кривые) для ФП систем с замещением монов в подрешетке В

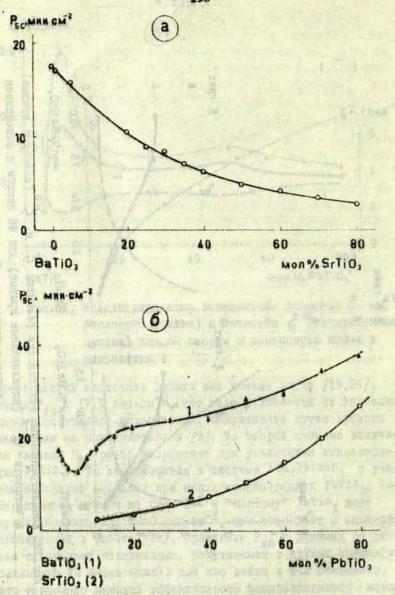


Рис. 13. Концентрационные зависимости скачка спонтанной полиривации при $T = T_C$ для систем с замещением монов в подреметие A

Важно отметить, что концентрационные зависимости $P_{SC}(x)$ для всех исследованных систем СТР имеют отчетливо выраженный нелинейный характер. Если этот, как нам кажется, достаточно твердо установленный факт сопоставить с линейным характером зависимостей $T_C(x)$ (см. начало настоящего раздела), то становится ясным, что результаты нашей работы находятся в ярком противоречии с выводами работы/30/, где утверждается, что для сегнетоэлектриков типа смещения, расположенных в ряд по значениям T_C и P_{SC} , якобы существует связь $T_C \sim P_{SC}^2$. Укажем, что выводы работы /30/ основаны на сопоставлении свойств I2 сегнетоэлектриков типа смещения, но самой различной структуры, в то время как закономерности, касающиеся спонтанной поляризации, могут надежно быть установлены только на объектах, достаточно близких по своей структуре, например, морфотропных рядах, изоморфинх

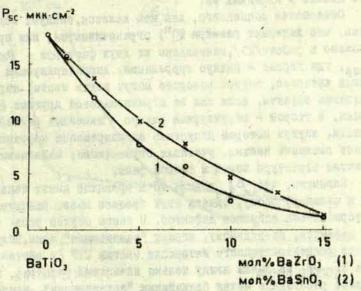


Рис. 14. Концентрационные зависимости скачка спонтанной поляризации при $T = T_{C}$ для систем с замещением ионов в подреметке В

СТР и т.п. С повиций структурного анализа выводы работы /30/ недавно были подвергнуты справедливой критике со стороны Фесенко /12/.

7. Концентрационные зависимости объема элементарной области (30) перехода V_{30} , расчитанного по формуле (24), показаны на рис. 15 6 , 15 6 для систем типа A_{1} — A_{2} , и на рис. 16 — для систем типа B_{1} — B_{2} .

В первую очередь отметим относительно малый дианазон изменения величины $V_{90}(x)$ в пределах отдельных систем: (Be, Sr)TiO₃ — 4 раза, (Ba, Pb)TiO₃ — 5 раз, Be(Ti, Zr)O₃ и Ba(Ti, Sn)O₃ — 3,5 раза, (Pb, Sr)TiO₃ — в виде исключения — II раз. Такое поведение резко контрастирует с величиной дианазона изменений других параметров, например, $\frac{dC_{c}}{dC_{c}}$,

 $\alpha_{\rm ah}^{\prime}(T_{\rm o})$, $P_{\rm so}$ (которые, как мы видели, в пределах одной системы СТР могут измениться на несколько порядков), и подтверждает положение о том, что $\nu_{\rm so}$ играет роль своеобразного кванта в явлениях ФП.

Объяснение последнего, как нам кажется, следует искать в том, что линейные размеря 90°) ограничиваются, как предположено в работе/25/, наименьшим из двух факторов — ρ_{κ} или $r_{\text{отр}}$, где первый — радиус корреляции, характеризурщий линейный интервал, внутри которого могут иметь место корреляционные эффекты, если они не ограничиваются другими факторами, а второй — отруктурный радиус — линейный размер области, внутри которой допустимо единовременно коррелированное смещение частиц, учитывая ограничения, налагаемые отличием отруктуры новой и старой фазы.

Напомним, что $\mathcal{P}_{\mathcal{K}}$ вблизи ФП в принципе имеет тенденцию к сильному росту, однако этот процесс может значительно тормозиться наличием дефектов. В нашем случае роль таних дефектов, по-видимому, играют "замещающие" ионы. Вблизи концов концентрационного интервала систем СТР (в системах типа В_Т—В₂ мы имеем ввиду только начальный участок), где среднее расстояние между ближайшими "замещающими" ионами

ж) Если приближенно считать $l_{90} \approx \sqrt{v_{90}}$, то двапазон изменения l_{90} в указанных системах СТР выражается сиромной цифрой 1,5 + 2 раза.



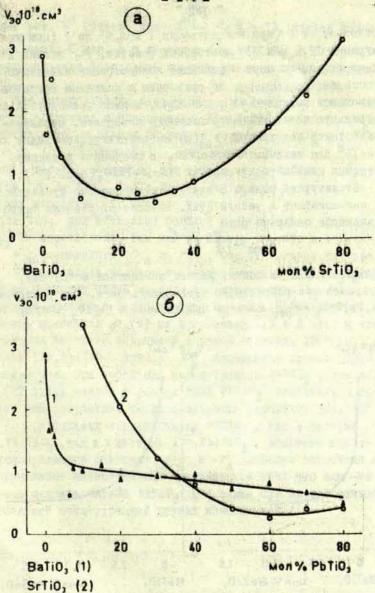


Рис. IS. Концентрационные зависимости объема элементарной области ФП для систем с замещением ионов в подрешетие A

составляет от 6 (при концентрации I мол.%) до 2 (при концентрации 12,5 мол.%) постоянных решетки, ρ_{κ} должен довольно резко, по мере нарастания концентрации замещающего компонента, уменьшаться по сравнению с исходным составом. Минимальное значение ρ_{κ} , очевидно, должно приходиться на центральную часть концентрационного интервала. Приблизительно такой ход кривой $v_{30}(\mathbf{x})$ мы действительно видим из рис. 15⁸ для системы (Ва, Sr)Т10 $_3$ и тенденция к такому поведению намечается у системы (Sr, Pb)Т10 $_3$ (рис. 15 6).

Структурный радиус в случае тетрагонально-кубического ФП, как показано в работе /31/, зависит от степени тетрагональности полярной фавы

 $r_{cmp} \sim (\frac{c}{a} - 1)^{-1}$

и в системе СТР, в общем, должен изменяться монотонно, уменьшаясь при вобрастании тетрагональности. Так в системе (ва.Ръ)т103 готр по мере приближения к Рът103, судя по

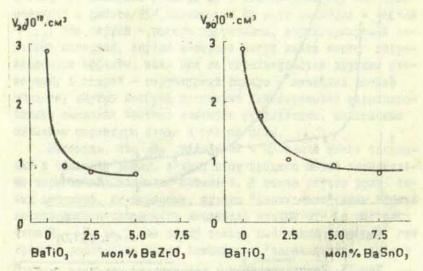


Рис. 16. Концентрационные зависимости объема элементарной области ФП для систем с замещением ионов в подрешетке В

данным рис. 6^6 (учтем, что $\frac{d_c}{l} \sim \frac{c}{a}$ - I), должен уменьшаться около 5 раз, а в системах (Ва, Sr) тіо, и (Рь, Sr) тіо, - неограниченно возрастать по мере увеличения концентрации srтіо,

Для интерпретации вида зависимостей V во(x) можно выдвинуть следующее предположение. Для ватіо и гьтіо , где дефектов мало, и вблизи ФП радиус корреляции $\rho_R > 10^{-6}$ см, главную (сграничивающую) роль играет фактор $r_{\rm crp}$, который в рытіо, несколько раз меньше чем в Ватіо, .Внутри систем (Ba,Sr)тіо, Ва(Ti,Zr)о, Ва(Ti,Sn)о, уже при небольших концентрациях второго компонента, а в системе (Рь, Sr)Т10, при несколько большей концентрации, фактор гото не играет роли, так как он быстро растет, и величину V_{20} определяет $\rho_{\rm R} < r_{\rm CTP}$. Следовательно, вид крикоторая проходит через минимум в системах типа Ат -- А2 монотонно убивает в системах типа В_--В2. По-видимому, диапазон изменения $\rho_R(x)$ не прервывает 1,5+2 раз, и его абсолютное значение сохраняет порядон величины 10-6 см. В системе (Ва,Ръ)тіо дактор Рк несомненно играет определяющую роль при небольших концентрациях Рьт10, так как Уво(х) здесь надает с ростом доли Рытіс, значительно бы-стрее, чем возрастает тетрагональность (сравнить рис. 15 и 6°). При больших концентрациях Рьтіо, , как в системе (Ba, Pb)TiO, Tak M B CHCTEME (Sr, Fb)TiO, , BOSMONHO NOHKYрирующее влияние факторов Рк и стр. Более подробная и исчернывающая интерпретация затрудняется тем, что нам не удалось изучить чистый Рьтіо, , а также СТР на его основе с небольшой концентрацией других компонентов.

тольно совподерже в рамом изветими деними, ролученнами другими митодини /9,28/. Вто пируверждает надежность применянием и населения реботе метода для спредодения моментального и прискисть реботе метода для спредодения

виводы

- І. Для исследованных систем СТР подтверждается близкая к линейной концентрационная зависимость температуры тетрагонально-кубического фазового перехода (ФП) Т_с(х).
- 2. Составы систем СТР, где замена ионов происходит в подрешетке A (типа $A_1 \rightarrow A_2$) в основном имеют четкие ФП ($\xi < I^0$); составы систем СТР с заменой ионов в подрешетке B (тип $B_1 \rightarrow B_2$) относятся к группе со средне размытым ФП; системы СТР на основе сегнетовлентрика сложного состава $Pb(M_{B_1/3}N_{B_2/3})_{0_3}$, где замена ионов танже происходит в подрешетке B, целиком относятся к группе с очень размытым ФП.
- 3. Максимум размытия в системах типа A_1 — A_2 приходится на середину концентрационного интервала. В системах типа B_1 — B_2 размытие монотонно растет с повышением концентрации несегнетоэлектрического компонента.
- 4. Концентрационные зависимости таких параметров, как приведенные к $T = T_C$ скачка спонтанной деформации $\frac{\Delta l_C}{\ell}$, коэффициента термического расширения $\Delta C C$ и спонтанной поляривации $P_{\theta C}$ для всех исследованных систем СТР имеют монотонный характер, кроме системы (Ba, Pb) Tio_3 , где наблюдается экстремум в области малых концентраций Ръ Tio_3 ,
- 5. Метод косвенного определения скачка спонтанной полиризации P_{g_0} (включающий нелинейную экстраполяцию для установления приведенного скачка $\frac{\Delta l_c}{l}$) дает результаты для исходных соединений ветіо и Рьтіо , удовлетворительно совпадающие с ранее известными данными, полученными другими методами /9,28/. Это подтверждает надежность примененного в настоящей работе метода для определения концентрационной вависимости P_{g_0} для СТР.

- 6. Концентрационные зависимости $P_{g_C}(x)$ для всех исследованных систем СТР имеют отчетливо выраженный нелинейный характер. Учитывая п.І настоящих выводов, следует, что результаты нашей работы противоречат утверждению, выдвинутому в работе /30/, о существовании соотношения $T_C \sim P_{g_C}^2$, якобы справедливого для сегнетоэлектриков типа смещения:
- 7. Концентрационная вависимость объема элементарных областей ФП от состава $V_{90}(x)$ выражена относительно слабо (на фоне значительных изменений остальных параметров). Это позволяет утверждать, что в рассмотренных системах СТР величина V_{90} является своебразной константой порядка 10^{-18} см³.
- 8. Характер установленной слабой концентрационной зависимости величини $V_{30}(\mathbf{x})$ для различных систем СТР можно объяснить конкурирующим влиянием структурного радиуса $r_{\text{стр}}$, с одной стороны, и величины радиуса корреляции ρ_{κ} с другой. Для исходных соединений образующих СТР ватло₃, Рътло₃ определяющим фактором является $r_{\text{стр}}$; для составое СТР внутри наждой из систем, определяющим фактором, по-видимому, является ρ_{κ}

В заключение авторы принссят глубокую благодарность В.Э. Юркевичу за помощь в части работы, связанной с программированием и вычислениями на ЭВМ и А.К.Броку за полезное обсуждение результатов.

" And Add American Charles of the Contraction of th

By my toll out obgains of the the others and the birthest and the

It, meaning mottal or whodrabas assurement wall reseases

ЛИТЕРАТУРА

- Г. Смоленский Г.А. Краткий обзор некоторых результатов исследования сегнетоэлектриков за последние годы. -"Известия АН СССР. Сер.физ.", 1957, т.21, вып.2, с. 233-263 с ил.
- Shirane G., Takeda A. Phase transition in solid solutions of PbZrO₃ and PbTiO₃. - "Journ.Phys.Soc. Japan", 1952, v.7, N 1, p. 5-11.
- Смоленский Г.А., Розгачев К.И. Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов в системе титанат бария титанат стронция. — "Журнал технической физики", 1954, т. 24, вып. 10, с. 1751—1760 с ил.
- 4. Смоленский Г.А., Исупов В.А. Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов станната бария в титанате бария. "Журнал сехнической физики", 1954, т.24, вып. 8, с. 1375-1386 с ил.
- Смоленский Г.А., Тарутин Н.П., Грудцин Н.П. Сегнетовлектрические свойства твердых растворов цирконата бария в титанате бария. – "Журнал технической физики", 1954, т.24, вып.9, с. 1584-1594 с ил.
- 6. Боганов А.Г., Хомутецкая Р.А. Дополнительные сведения о системе твердых растворов Рытіо3-srtio3. -"Известия АН СССР. Сер.фив.", 1957, т.21, вып.3, с. 433-438 с ил.
- 7. Смоленский Г.А., Исупов В.А., Аграновская А.И., Попов С.Н. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом. "Физика твердого тела", 1960, т.2, вып. II, с. 2906-2918 с ил.
- Kay H.F., Vousden P. Symmetry changes in barium titanate at low temperatures and their relation to its ferroelectric properties. "Phil.Mag.", 1949, v.40, N 309, p. 1019-1040.

- 9. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетовлентрические кристаллы. М., "Мир", 1965, с. 334.
- IO. Joho P. Präzisionsmessung der Gitterkonstante und des Ausdehrungskoeffizienten von Barium titanat. -"Zeitschrift für Kristallographie", 1964, v. 120, s. 329-341.
- 11. Känzig W. Röntgenuntersuchungen über die Seignetteelektrizität von Barium titanat. - "Helv.Phys.Acta". 1951, v. 24, fasc. 2, p. 175-216;
- Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сегнетовлектричество. - М., "Атомиздат", 1972, с. 201.
- 13. Борман К.Я., Фрицберг В.Я. Особенности температурной зависимости коэффициента линейного термического рас-вирения в поликристаллических твердых растворах титанатов бария и отронция. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971, с.83-96 с ил.
- 14. Фринферг В.Н., Ролов Б.Н. О некоторых факторах, определяющих характер сегнетоэлектрического фазового перахода. "Известин АН СССР. Сер.физ.", 1964, т.28, № 4, с. 649-652.

 Pritsberg V.J. One some particular properties of phase transformation in ferroelectric solid solutions. Proc. Intern. Meet. on Ferroelectr., Prague, 1966, v.1, p. 163-171.
- 15. Ролов Б.Н. Размитие фазовие переходы. Рыга, "Зинатие", 1972, 310 с. с ил.
- 16. Фрицберг В.Я. Проблемы исследования связи состава и свойств в сегнетоэлектрических твердых растворах типа перовскита. - "Известия АН СССР. Сер.физ.", 1970, т.34, № 12, с. 2628-2634 с ил.
- Фрицберг В.Я. О методине исследования поляризации сегнетоэлектриков в переменных электрических полях. – В кн.: Методика исследования поликристаллических

- сегнетоэлектриков. Рига, 1970, с. 5-42 с ил.
- 18. Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнето электриков типа титаната бария. - Рига, "Винатне", 1971, 228 с. с ил.
- 19. Фрицоврт П.А. Диэлектрические свойства сегнетоэлектрического твердого раствора (Ва, Sr)Т10₃ в области фазового перехода при высоких давлениях. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971, с. 117-122 с вл.
- 20. Поландов И.Н., Мылов В.А. Диэлектрические свойства поликриоталлического твердого раствора Ва(Т1,Zr)03 в области фазового перехода при высоких давлениях. "Фивика твердого тела", 1964, т. 6, вып.2, с.499-502 с ил.
- Поландов И.Н., Мылов В.П. Исследование сегнетоэлектрической керамики Вы(Ті,sn)0, при высоких давлениях. "Физика твердого тела", 1967, т. 9, вып.8, с 2319-2323 с ил.
- 22. Samara G.A. Pressure and temperature dependence of the dielectric properties and phase transitions of the ferroelectric perovskites: PbTiO₃ and BaTiO₃. "Ferroelectrics", 1971, v.2, p. 277-289.
- 23. Hegenbarth E., Frenzel C. The pressure dependence of the dielectric constants of SrT10, and (Ba_{0,05}.Sr_{0,95})T10, at low temperatures. "Cryogenics", 1967, v.7, # 6, p.331-335.
- 24. Брок А.Я., Фрицберт В.Я., Такере З.А., Олехнович Р.Я., Тункун З.А. Экспериментальная проверка выполнения обобщенного закона Кюри-Вейсса в системах твердых растворов со структурой типа перовскита. См. настоящий сборник с. 5-46 с ил.

- 25. Фрицберг В.Я. Основы теоретического анализа тепловых и поляризационных явлений в области размытого сегнетоэлектрического фазового перехода. - В печати.
- Александров К.С., Зиненко В.И. Фазовые переходы типа смещения. - Красноярск, Препринт ИФСО-5Ф, 1972.
- 27. Исупов В.А. К вопросу о причинах образования области Кюри в некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах. - "Журнал технической физики", 1956, т. 26, вып. 9, с. 1912-1916 с ил.
- 28. Гавриляченко В.Г., Спинко Р.И., Мартыненко М.А., Фесенко Е.Г. Спонтанная поляризация и коэрцитивное поле титаната свинца. "Физика твердого тела", 1970, т. 12, вып. 5, с. 1532-1534 с ил.
- Фрицберг В.Я. О возможности исследования фундаментальных свойств сегнетоэлектрических твердых растворов типа титаната бария. - В. кн.: Титанат бария. М., "Наука", 1973, с. 86-93 с ил.
- 30. Abrahams S.C., Kurtz S.K., Jamieson P.B. Atomic Displacement Relationship to Curie Temperature and Spontaneous Polarization in Displacive Ferroelectrics. - "The Physical Review", 1968, v. 172, N 2, p. 551-553.
- 31. Романовский Т.Б., Ролов Б.Н. Оценка размеров областей Кенцига на основе динамической теории кристаллической решетки. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектри-ках. Рига, "Зинатне", 1971, с. 67-74.

Л.А. Шебанов

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕТРАГОН ЛЛЬНО-КУБИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ СИСТЕМЫ (Ва, 3°) Ті 03

Методом рентгеноструктурного анализа в своё время были выявлены основные особенности фазовых переходов (ФП) в
титанате бария /1-3,5/. Большое значение рентгеноструктурный анализ имеет также при исследовании фундаментальных
свойств сегнетоэлектрических твердых растворов (СТР) /4/,
однако, по имеющимся у нас сведениям отсутствуют работы,
посвященные изучению температурных зависимостей параметров
влементарной ячейки в области ФП для СТР на основе титаната бария. Это объясняется, по-зидимому, некоторыми трудностями методического характера, заключающимися в сложности одновначной интерпретации картины рентгеновской дифракции для материалов с малой тетрагональностью структуры,

В настоящей работе исследована температурная зависимость параметров ячейки в области тетрагонально-кубического ФП для твердых растворов системы (Ва, Sr) ТіО3 в интервале концентраций 0 + 25 мол. % Sr ТіО3, имеющих температуру ФП выше комнатной. Решение поставленной задачи потребовало дальнейшего развития методики эксперимента.

Измерение температурной зависимости параметров элементарной ячейки ВаТі О₃ вблизи тетрагонально-кубического
ФП проводилось рядом исследователей /1-3,5/. Наиболее достоверными, очевидно, следует признать результаты работы
/5/, автор которой использовал стандартную методику Дебая-Перрера (метод порошка) о применением внутреннего
стандарта и контрольной экстраполяцией в кубической фазе
по Бредли-Джею. По сравнению с результатами предыдущих

авторов было получено заметное повышение точности измерения (согласно /5/, ошибка в определении межплоскостных расстояний составляла $\pm 1.10^{-4}$ кХ в тетрагональной области вдали от ФП и $\pm 6.10^{-5}$ кХ в кубической фазе). Однако из-за малой тетрагональности структуры в непосредственной близости от точки ФП точность снижалась до $\pm 10^{-3}$ кХ, что явно недостаточно для уверенной оценки разности $c-\alpha$. К тому же, при исследовании систем СТР метод мало пригоден из-за своей исключительной трудоемкости, поэтому нами был развит нескольно иной подход к решению задачи.

Трудности определения параметров элементарной нчейки вещества с небольшой тетрагональностью связаны с перекрытием дифракционных линий типа h 00,00h и т.д. для малых и средних углов и размытием, а часто и отсутствием подходящих линий при больших углах дифракции. С целью аналитического описания будем исходить из предположения, что профиль дифракционной линии аппроксимируется линейной комбинацией колоколообразных функций типа $\exp\left[\frac{(x-x_0)^2}{2}\right], \frac{1}{1+\kappa(x-x_0)^2}$ и т.п., параметрически зависящих от абсцисс своих максимумов θ_{0j} .

$$F(\theta) = \alpha_1 \varphi_1(\theta, \theta_{01}) + \alpha_2 \varphi_2(\theta, \theta_{02}) + \cdots \alpha_K \varphi_K(\theta, \theta_{0N}) \quad (1)$$

Справедливость сделанного предположения проверяется экспериментально. Нами установлено, что при правильной юстировнее дифрактометра и использовании керамических образцов экспериментальный профиль удовлетворительно описывается эвспонентами Гаусса. Из дальнейшего следует, что ограничение, связанное с требованием симметричности отдельных функций у, является несущественным и в принципе легко устранимо. Некоторые вопросы аппроксимации рентгеновской линии математическими кривыми рассмотрени в работах /6-8/.

В математическом аспекте задача заключается в нахождении амплитуд α_j и параметров θ_{gj} , наилучшим образом аппроксимирующих экспериментально определяемый профильдифракционной линии. В качестве критерия аппроксимации

выберем величину Φ , представляющую собой сумму кведратов отклонений линейной комбинации (I) от экспериментальных точек y_i

 $\varphi = \sum_{i=1}^{n} v_i^2 \tag{2}$

где $v_i = F(\theta_i) - y_i$, а n — число экспериментальных точек.

Предположим, что задача разложения профили экспериментальной дифракционной линии эквивалентна нахождению минимума функционала $\phi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n,\theta_0,\theta_0,\cdots,\theta_0)$, причем оцениваемые параметры α_j входят в F линейно, а параметры θ_0 нелинейно. При фиксированных θ_0 задача переходит в классическую проблему наименьших квадратов Гаусса.

Введем следующие матричные обозначения

$$f_{i} = \begin{vmatrix} y_{i}(\theta_{i}) \\ \vdots \\ y_{i}(\theta_{n}) \end{vmatrix}; \quad \alpha = \begin{vmatrix} \alpha_{i} \\ \vdots \\ \alpha_{K} \end{vmatrix}; \quad y = \begin{vmatrix} y_{i} \\ \vdots \\ y_{n} \end{vmatrix}; \quad F_{K} = \begin{vmatrix} f_{i}, f_{2}, \cdots f_{K} \\ \vdots \\ y_{n} \end{vmatrix}$$

$$(3)$$

В этих обозначениях вентор отклонений выразится следующим образом

$$v = a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_n f_n - y = F_n \alpha - y$$
 (4)

Требование минимума для Ф приводит к соотношению

$$\frac{1}{2}\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_j}=0 \qquad \text{для } j=1,2,\dots,\kappa \qquad (5)$$

Комбинируя формулы (2) и (4), получаем

$$v'\frac{\partial v}{\partial \alpha_i} = v'f_i = 0 \tag{6}$$

NUM

$$(\alpha' f'_{n} - y') f_{j} = f'_{j} (f_{n} \alpha - y) = 0,$$
 (68)

где знак " ' " обозначает транспонирование соответствуюмих матричных объектов. Совокупность и уравнений (6) можно объединить с помощью одного векторного уравнения

$$F_{\kappa}'(F_{\kappa}a-y)=0 \tag{7}$$

NILN

$$F_{\kappa}'F_{\kappa}\alpha = F_{\kappa}'y, \qquad (78)$$

откуда

$$\alpha = (F_K'F_K)^{-1}F_KY \tag{8}$$

и для Ф тіп имеем

$$\phi_{min} = v'v = v'(F_{\kappa}\alpha - y) = -v'y \qquad (9)$$

так как у Е О из условия минимума.

Подставляя (4) в (9), имеем

$$\phi_{min} = y'y - \alpha'(F_{\kappa}'y) \tag{10}$$

Очевидно, что описанный метод практически неприменим для оценки параметров Θ_{oj} , так как приводит к необходимости решения системы нелинейных трансцендентных уравнений. Поэтому нахождение полного набора оцениваемых параметров проводится в два этапа. Сначала находятся первые оценки амплитуд α_j , используя метод наименьших квадратов при некоторых заданных значениях Θ_{oj} . Затем, используя найденные значения α_j , производится дальнейшая минимизация Φ с помощью одного из следующих трех алгоритмов.

 Метод Гаусса-Зайделя: поочередным дискретным изменением параметров о добиваются дальнейшего уменьшения 2) Градиентный метод: начальный набор θ_{0j} изменяется одновременно для всех вначений j в направлении градиента функции ϕ (θ_{0j} , θ_{0j} ,... θ_{mi}).

3) Методы случайного поисна: в предположении случайного характера параметров о находится минимум функционала ф, "разыгрывая" набор о методом Монте-Карло.

Процедуру нахождения линейных параметров можно повторить, используя полученные вначения об . Описанный алгоритм осуществлялся нами при помощи вычислительной программы, составленной для машины БЭСМ-4. Блок-схема программы показана на рис. I.

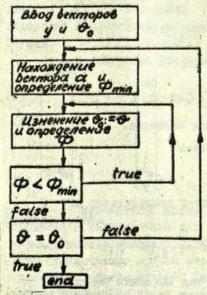


Рис. I. Блок-схема вычислительной программы "Дешифрация профиля рентгеновской линии"

Увеличение числа независимых оцениваемых параметров, входящих в сумму (I),
ваментно увеличивает время
работы ЭВМ, поэтому при практическом использовании были
введены следующие дополнительные условия (см. также
/9/).

I) Отношение I_{∞} для определенного анода рентгеновской трубки известно; например, для излучения $Fe K_{\infty}$, применявшегося в данной работе, $I_{\infty} = 0.491 / 10/.$

2) Междублетное расстояние для экспериментально используемого интервала углов меняется мало, поэтому его можно считать постоянным и известным.

3) Интегральная ширина отдельных функций (I) одна и та же и соответствующий параметр в сумме (I) считается фиксированным и определяется экспериментально из дифракционной линии, снимаемой по точкам в кубической фазе. Поправка на немонохроматичность изучения вводится согласно методике, изложенной в работе /IO/.

Используя вышеизложенный подход к дешифрации дифракционных линий сложного профиля, были исследовани образци твердых растворов ($B\alpha_{x,x},Sr_x$) RO_3 для значений x=0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; используя дифрактометр УРС-50 ИМ с высокотемпературной приставкой, обеспечивающей измерение в интервале температур $20+500^{\circ}$ C с температурной стабилизацией не хуже $\pm 0,2^{\circ}$ C. Низкотемпературная часть измерений для состава x=0,25 осуществлялась на серийной приставке УРНТ-180.

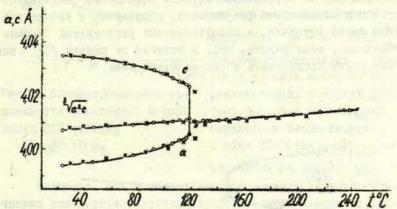


Рис. 2. Температурная вависимость параметров элементарной ячейки ВаТіО₃. Точки о - наши данные; точки х - данные работы /5/

Для определения параметров элементарной нчейки снимались по точкам дифракционные максимумы 002 и 200, что,естественно, несколько снизило точность полученных результатов, так как положение этих линий соответствует интервалу углов 57+60° (шкала 2 ° и Гек, ивучение), и ошибка в определении межплоскостных расстояний оценивается величиной ±5·10° %. Выбор именно этих линий обусловлен отсутствием других подходящих линий с достаточным расщеплением и интенсивностью при больших углах. Следует, однако, отметить, что при использовании нашей методики точность измерения мало вависит от степени перекрытия линий 00 /г и /г и испедованиях в непосредственной близости от точки ФП (сравн., например, с /5/).

На рис.2 приведена температурная зависимость параметров элементарной нчейки ВаТ/О3, полученная вышеописанным способом, используя в качестве внутреннего стандарта порошом серебра. Для сравнения приведены данные, полученные автором работы /5/. Весьма хорошее совпадение свидетельствует с достоверности результатов, полученных с использованием нашей методики, а невначительные расхождения вполне объяснимы, если учесть, что, в отличие от работы /5/, все наши опиты проводились в режиме схлаждения.

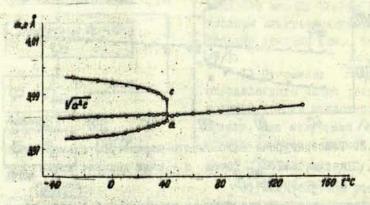


Рис.3. Температурная зависимость параметров элементарной ячейки СТР (0,75 Ва - 0,25 5) Т(03

Результати, полученные для СТР, позволяют определить концентрационную зависимость некоторых фундаментальных мик роскопических параметров сегнетоэлектриков системы $(Be_{1-x}Sr_x)TiO_3$. Концентрационная зависимость спонтанной

деформации, полученная из наших данных с использованием методики вычисления, описанной в /4/, представлена на рис. 4.

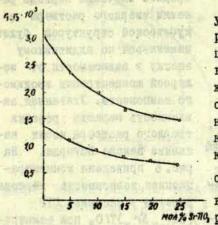


Рис.4. Концентрационные зависимости спонтанной деформации СТР системы (Ba, Sr) TiO₃

Полученная зависимость указывает на то, что по мере возрастания молярной концентрации Sr TiO, структура вещества все больше приближается к кубической. обусловлено и отсутствие настоящей работе данных для концентраций х = 0,25, так как при тетрагональности структуры $\frac{c}{a} - 1 < 2 \cdot 10^{-3}$ в нашем случае трудно увемол % 3гло, ренно оценить точку ФП из рентгеновских измерений. Температурная зависимость параметров элементарной

ячении СТР (Ва_{0.75} Sr_{0.25})Ті 03

приведена на рис.3.

Возможно, что при парадлельном проведении диэлектрических или других структурночувствительных измерений указанное препятствие можно преодолеть. Дальнейшие порспективы развитого нами метода открываются при использовании дифракционных максимумов при больших углах (например, 004). Выявление возможности получения указанных рефлексов тесно связано с исследованием технологии изготовления керамических образдов.

Концентрационная зависимость параметров элементарной ичейки при T = T_C показана на рис. 5. Обращает на себя внимание явная нелинейность полученной зависимости.

Известно, что, если степень перекрытия электронных оболочек различных атомов в процессе замещения в твердых растворях существенно не изменяется по отношению и пере-

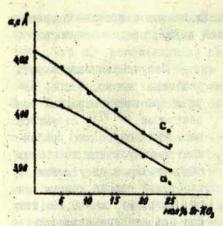


Рис.5. Концентрационная зависимость параметров элементарной нчейки СТР системы (Ва, Sr) T/O₃ в точке ФП (тетрагональная фаза)

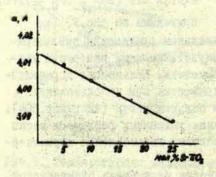


Рис. 6. Концентрационная зависимость периода решетки СТР системы (Ва, Sr) ТіО₃ в кубической фазе при Т = 180°C

крытию оболочек атомов в соответствующих исходных веществах, то можно ожидать, что среднее значение периода решетки твердого раствора кубической структурой будет изменяться по аддитивному вакону в зависимости от лярной концентрации вводимого компонента. Указанная зависимость периода решетки твердого раствора носит звание закона Вегарда. Ha рис. 6 приведена концентрапионная зависимость периода решетки в системе СТР (Bat- Sr)TiO3 npm температуре $T = 180^{\circ}$ С. Можно считать, что закон Вегарда полняется и в нашем случае, однако, анализ характера разброса экспериментальных точек указывает на возможность некоторого положительного отклонения от этой зависимости, что коррелирует с представлением о известной "рыхлости" сегнетоэлектрических структур. Указанный вопрос представляет самостоятельный интерес и требует дальнейшего исследования.

В заключение мы приводим, полученную из наших данных, концентрационную за-

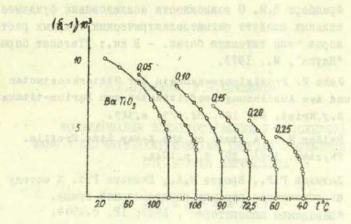


Рис.7. Концентрационная зависимость тетрагональности СТР системы (Ва, Sr) Ті O_3 в области фазового перехода (Т \leq T_0)

висимость изменения тетрагональности в области ФП (рис. ??), часто используемую в вычислениях.

Автор приносит благодарность В.Я. Фрицбергу за постоянный интерес к настоящей работе и ценные замечания при обсуждении.

ЛИТЕРАТУРА

- Megaw H.D. Temperature changes in the crystal structure of barium titanum oxide. Proc. Roy. Soc (London), 1947, AI89, p. 261.
- Kay H.F. Preparation and properties of crystals of barium titanate. Acta Crystallogr., 1948, I, p.229.
- 3. Kay H.F., Vousden P. Symmetry changes in barium titanate at low temperatures and their relation to its ferroelectric properties. Phil. Mag., 1949, 40, p. 1019.

- 4. Фрицберг В.Я. О возможности исследования фундаментальных свойств сегнетоэлектрических твердых растворов типа титаната бария. - В кн.: "Тиганат бария". "Наука", М., 1973.
- Joho P. Prazisionsmessungen der Gitterkonstanten und des Ausdehnungskoeffizienten von Barium-titanat.
 Z.f.Krist. Bd. 120, Hf.4/5, s.329.
- 6. Halder N.C. A study on the X-Ray Line Profile. Physica. 1964, 30, 5, p.1044.
- 7. Давыдов Г.В., Ерохов Н.А., Белнева Г.Ф. К методу аппроисимации профиля рентгеновской линии. "Заводская лаборатория", 1967, 12, с.1544.
- 8. Куколь В.В. Метод разделения компонентов дублета рентгеновских дифракционных линий. "Заводская лаборатория", 1963, 5, с.575.
- 9. Фрейманис В.А., Кручан Я.Я., Гаварс П.Э. Методика и некоторые результаты исследования фазового состава твердых растворов (Ръ,Ва)мь 206. В кн.: "Фазовые переходы в сегнетоэлектриках". "Зинатне", Рига, 1971.
- Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. Изд.физ.-мат.лит. М., 1961.

Э.Х.Пуриньи, В.Я.Фрицберг

исследование электрострикции в неполярной ФАЗЕ У СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТВЕРЛЫХ РАСТВОРОВ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА

BBEIEHNE

Электрострикция обусловлена деяствием электрического поля на структурные элементы атомов и молекул диэлектрика и наряду с поляризацией является фундаментальным свойством всех дизлектриков. Из физики дизлектриков известно /1/, что относительная деформация диалектрика пропорциональна квадрату приложенного влектрического поля или поляризации самого диалектрика:

$$r_{ij} = Q_{ijkl} P_k P_l$$
, (I)

$$r_{ij} = R_{ijnl} E_n E_l,$$
 (2)

- компоненти тензора деформации II ранга,

- векторы напряженности электрического поля,

Р., Р. - векторы поляризации,

Qijal, Rijal - коэффициенты электрострикции (компоненты тензора IJ ранга).

В матричных обозначениях выражения (1) и (2) при-HHMADT BUA:

$$r_i = Q_{ij} P_j^2, \qquad (I')$$

$$r_i = R_{ij} E_j^2. \qquad (2')$$

$$r_i = R_{ij} E_j^2. \tag{2'}$$

Количество компонентов тензора электрострикционных моэффициентов, отличных от нуля, зависит от симметрии кристадла. Так для сегнетоэлектриков типа перовскита в неполярной фазе имеются только три независимых коэффициента электрострикции Q_{11} , Q_{12} и Q_{44} (соответственно R_{11} , R_{12} и R_{44}). В твердых растворах той же структуры по причине макроскопической изотропности остаются всего две константы Q_{11} и Q_{12} (соответственно R_{11} и R_{12}).

Из термодинамики следует, что коэффициенты R_{ij} имеют аномалию в районе сегнетоэлектрического фазового перехо – да, а коэффициенты Q_{ij} не долины зависеть от температуры и являются "истиными" константами вещества /2/. Этот вывод подтверждают также экспериментальные данные /3,4/,

Здектрострикционные явления в перовскитах и особенно в сегнетоэлектрических твердых растворах этой структуры изучены еще сравнительно мало. В то же время у сегнето — электриков, у которых отсутствуют пьезоэлектрические свойства в парафазе, спонтанная деформация, пьезоэффект, тепловое расширение и электромеханические свойства в по-лярной фазе определяются электрострикционным характеристиками параэлектрической фазы. Таким образом, исследования электрострикционных свойств в неполярной фазе представляют значительной теоретический и практический интерес. Отставание исследований в этой области связано главным образом с экспериментальными трудностьями измерения малых деформаций в широком интервале температур.

В настоящей работе были поставлены следующие задачи:

I) Дать краткую характеристику существующих методов и результатов измерения коэффициентов электрострикдии и оценить их пригодность для определения соответствующих параметров для сегнетозментрических твердых растворов со структурой тяпа перовскита, учитывая, что последиме могут быть представлены исключительно в виде керамических образцов. 2) Используя методику измерения малых деформации при помощи индуктивного датчика /5/, определить на керамичес-ких образцах коэффициенты электрострикции Q_m и Q₁₂ для систем твердых растворов (Ba,Sr)TiO₃ и (Pb,Sr)TiO₃ в неполярной фазе и установить их концентрационную зависимость.

ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

Существуют несколько методов определения электрострикционных коэффициентов Q_{ij} и R_{ij} . Из выражения (I'),
(2') следует, что константи Q_{ij} (или соответственно R_{ij})
можно определить через поляризацию (электрическое поле)
и соответствующую деформацию. Здесь необходимо учитивать,
что у сегнетоэлектриков в полярной фазе наряду с электрострикцией существуют еще два механизма деформации во
внешнем электрическом поле — обратний пьезоэлектрический
эффект и доменные переориентации, кот рые вносят основной вклад в деформацию. Таким образом, уверенное определение электрострикции в немонодоменных кристанах возможно только в параэлектрической фазе.

Используя экспериментальные данные о величие возникмей при фазовом переходе спонтанной поляризации и изменении параметров элементарной яченки, можно провести расчет коэффициентов Q_{44} , Q_{42} и Q_{44} для монокристаллических образцов /6/ из соотношений:

 $\Delta \alpha_c = Q_{e2} P_{sc}^2$, где α_{ec} - параметр решетки кубической фазы при Т-Т_о, ΔC_c , $\Delta \alpha_c$ - скачки параметров решетки при фазовой переходе в тетрагональную фазу,

P_{SC} — скачек спонтанной поляризации. К сожалению, этот метод непригоден для керамических материалов.

Возможно также прямое измерение электрострикционной деформации и соответствующей поляризации в неполярной фазе. Этот метод определения коэффициентов Q_{44} и Q_{42} использовался Г. Пмидтом /7/ и также нами.

Некоторне авторы /3,8,9/ применяли следующия метод определения электрострикционных коэффициентов R_{ij} . На обравец одновременно подается постоянное смещающее поле E_3 и небольшое переменное поле ΔE_3 . Постоянное поле создает индуцированный пьезомодуль A_{3I} , величина которого измеряется обичными методами (например, методом резонанса – антирезонанса). Деформацию в этом случае можно написать в виде

После несловных преобразований получаем (учитывая , $что \triangle E_3 \ll E_3$):

nare + dy AE3 ,

где $r_{\rm g}$ не зависит от Δ E₃ , а $d_{31}^*=2R_{13}$ E₃ (индуцированный модуль). Получаем, что

$$R_{13} = R_{12} = R_{23} = \frac{d_{31}}{2E},$$

$$Q_{13} = Q_{12} = Q_{23} = \frac{R_{13}}{2E^2} = \frac{8\pi^2 d_{31}^2}{E^2 E_3},$$

где \mathcal{X} — восприничисвость, \mathcal{E} — проницаемость диалектрика. Аналогичные формулы справедливы для R_{44} и Q_{24} .

На монодоменных кристаллах этот метод позволяет определить электрострикционные коэффициенты также и в полярной фазе.

Существуют еще и другие методы определения электрострикционных коэффициентов. Например, Г. Шмидт /10/ и Ф. Прокерт /11/ применяют метод электрострикционного ревонатора.

Коэффициенты Q_{ij} и R_{ij} можно также определять из зависимостей обратной диалектрической восприимчивости или диэлектрической восприимчивости от механического напряжения или деформации /4/. Этот метод практически не используется из-за трудностей создания одноосних, однородних механических напряжений.

В литературе до настоящего времени практически отсут ствуют данные о значениях электрострикционных коэффициентов для сегнетоэлектрических твердых растворов перовскита. Наи более подробные данные имеются только для монокриставлов титанатов бария и стронция.

Определенные различными методами коэффициенти Q_{ij} для титаната бария, а также для титаната стронция хорошо согласуртся между собой. Так, для ВаТі 03, рассчитанные по величине спонтанной поляризации и параметрам кристаллической рететки имеет значения (в единицах СГСЭ) /6/:

$$Q_H = 1,23 : 10^{-12}$$
, $Q_{12} = -0.56 : 10^{-12}$, $Q_{44} = 0.70 : 10^{-12}$.

Из прямых измерений электрострикционной деформации и соответствующей поляризации для BaTiO3 в неполярной фазе Г. Емидт получил /7/:

$$Q_{11} = 1.26 \cdot 10^{-12}$$

 $Q_{12} = -0.47 \cdot 10^{-12}$

Коэффициент Q_{r2} рассчитанный по изменении пьезомодуля при наложении постоянного поля имеет величину -0',42,10"12 при $T=+30^{\circ}$ С и -0',35 . 10^{-12} при $T=+150^{\circ}$ С /3/.

Для монокристаллов S-Ti O₃ известны только значения Q_{tt} и Q_{t2} . Их определили Г. Пыидт и Э. Хегенбарт / I2/: $Q_{tt} = 0.88$; 10^{-12} ,

$$Q_{H} = 0.88$$
 : 10^{-12} , $Q_{12} = -0.17$: 10^{-12} при комнатной температуре, и $Q_{H} = 0.73$: 10^{-12} . $Q_{12} = -0.13$: 10^{-12} при $T = -193^{\circ}$ C.

Расчет по данным из работ / 8, \square / дает значение $Q_{12} = -0$, \square . 10⁻¹² при \square = +20°C.

Используя литературные данные о температурной зависимости параметров решетки /14/ и спонтанной поляризации /15/ монокристаллов Рь Ті O_3 , можно оценить величину G_{44} и G_{49} . При T = +490°C получаем:

$$Q_{H} = 0.88 \cdot 10^{-12},$$

 $Q_{D} = -0.26 \cdot 10^{-12}.$

На основании данных, полученных для монокристаллов, шутем усреднения можно найти коэффициенты электрострикции для поликристаллического материала в неполярной фазе. Формулы для усредненных компонентов симметричного тензора четвертого ранга даны Девонширом в работе /16/. В нашем случае

$$\overline{Q}_{11} = \frac{3}{5}Q_{11} + \frac{2}{5}Q_{12} + \frac{1}{5}Q_{44} \qquad \text{II} \qquad (3)$$

$$\bar{Q}_{12} = \frac{1}{5} Q_{44} + \frac{4}{5} Q_{12} - \frac{1}{10} Q_{44} \qquad (4)$$

Для керамического ВаТ: Q_3 из этих формул получаем (подставияя $Q_{44} = 1.23 \cdot 10^{-12}$, $Q_{42} = -0.56 \cdot 10^{-12}$, $Q_{44} = 0.7 \cdot 10^{-12}$):

 $\bar{Q}_{44} = 0.65 \cdot 10^{-12},$ $\bar{Q}_{42} = -0.27 \cdot 10^{-12}.$

Прявые измерения электрострикционной деформации в кубической фазе для поликристаллического ВаТ(0)3 дают для $Q_{H} = 0.58 \cdot 10^{-12} / 18/$ и 0.77 $\cdot 10^{-12} / 19/$, что находится
в удовлетворительном согласии с усредненными коэффициентами, рассчитанными по (3).

Чтоби получить значения Q_{44} и Q_{42} для поликристаллического Sr Ti O_3 , необходимо кроме Q_{44} и Q_{42} знать коэффициент Q_{44} для которого нет данных в литературе. Вклад Q_{44} в усреднение коэффициенти Q_{44} и Q_{42} для ВаTi O_3 составляет примерно 25 %, и мы можем в некотором приближении положить Q_{44} для монохристалла Sr Ti O_3 равным $0.5.10^{-12}$ ед. СГСЭ. Тогда для керамического Sr Ti O_3 получим

$$\overline{Q}_{99} = 0.56 \cdot 10^{-12}$$
 m
 $\overline{Q}_{92} = -0.01 \cdot 10^{-12}$.

Таким образом, если рассматривать систему твердих растворов (Ва,Sr) Ti O_3 , то, видимо, электрострикционные коэффициенты должны изменятся мело — приблизительно от 0.65. 10^{-12} до 0.56. 10^{-12} для \overline{Q}_H и от -0.20. 10^{-12} до -0.01. 10^{-12} для \overline{Q}_{12} . Такие результать подтверждаются нажими экспериментальными данными, которые приводятся ниже.

МЕТОЛИНА И РЕЗУЛЬТАТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Аля определения коэффициентов электрострикции Q_{H} и Q_{H2} сегнетоэлектрических твердых растворов в непомярной фазе была выбрана следующея методика измерений. На образец, имеющий форму прямоугольной призмы или диска с толщиной I-2 мм и большим ребром (диаметром) 7-15 мм накладивается электрическое поле в виде импульса длительностью порядка I сек. Напряженность поля в импульсе менядась от 4 до 16 кв.см⁻¹. Для определения Q_{H} измеряется деформация параллельно электрическому полв. а для Q_{H2} — перпендикулярно к этому направлению (рис.1). Одновременно с деформацией измерялась поляризация образца по схеме Сопера-Тауэра.

для измерения деформации применялась установка с индуктивным датчиком /5,20,21/, именцая чувствительность 10⁻⁷см на деление шкалы потенциометра ЭПП-09. При опредедении поляризации учитивалась проводимость образца /21/. Средняя погрешность измерения деформации осстанляла 5%, а поляризации - 3 %. Таким образом общая погрешность определения электрострикционных коэффициентов была 10-12%.

Температурный интервал измерения электрострикции обуславливался несколькими факторами, указанными нике.

I. Измерение деформации, вызванной "чистой" электро-

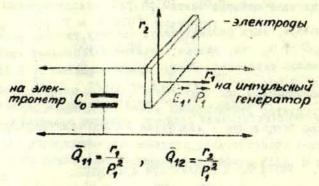


Рис. I. Схема измерения \overline{Q}_{44} и \overline{Q}_{42} (C₀ — эталонный конденсатор)

стрикцией было возможно только в температурном интервале от 10^0 до $50-70^0$ за разовим переходом ($T > T_c$). Ближе к точке Кири (T_c) возможен вклад полярной фазн, индуцированной внешним электрическим полем, а при более высоких температурах электрострикционные деформации становятся меньше порога чувствительности установки.

2. Указанный интервал температур еще более сумается при наличии проводимости исследуемого материала. В образцах с проводимостью более чем 10⁻⁹ ом⁻¹. см⁻¹ затруднен ее учет при определении поляризации, а также начинается экранизация внешнего электрического поля. При еще большей проводимости — возможно нагревание образца. По этоя причине становится невозможным определение электрострикционных коэффициентов у твердых растворов системы (Рь, Sr)Т(03, содержащих более чем 40 мол. Я РьТ(03.

Характерные зависимости деформации и поляризации от эдектрического поля показанны на рис. 2. Как видно, в занчительном интервале напряженностей сохраняется квадратичная зависимость деформации и динейная зависимость

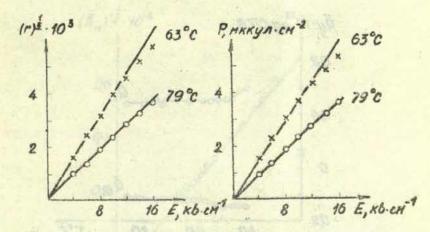


Рис. 2. Зависимость относительной деформации и поляризации от внешнего электрического поля для твердого раствора (Вао. 75 Sr o. 25) T/O 3

полеризации, что подтверждает наличии "чистой" электрострикции у исследуемого вещества.

Аналогичные графики строились для всех образцов. Из соотношения наклона прямых определялся соответствующий коэффициент электрострикции. Интересно отметить, что отклонение от линеяных зависимостея $\sqrt{r_i}$ (E) и P(E) при больших Е таково, что коэффициент электрострикции практически не зависит от электрического поля.

Нами экопериментальные исследования подтверидают такие независимость электрострикционных коэффициентов Q_{ij} от температуры при $T > T_0$ вне области фазового перехода (рис.З.). Небольное увеличение (особенно для $|Q_{ij}|$) вблизи фазового перехода наблидается у всех исследуемых составов с больной концентрацией Sr Ti O_3 . Так, например, для твердого раствора (0,04 Pb; 0,96Sr) Ti O_3 коэффициент Q_{ik} даже меняет знак, в то время как абсолютное изменение Q_{ik} составляет всего

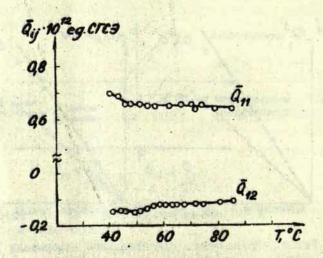


Рис. 3. Температурная зависимость электрострикционных коэффициентов Q_{11} и Q_{12} для твердого раствора (Ва $_{0.75}$ 3г $_{0.25}$) Ті $_{0.3}$

линь 0.04 . 10^{-12} ед.СГСЭ во всем исследуемом интервале температур. Харктерная температурная зависимость показана на рис. 3 для $(Ba_{0.75} Sr_{0.25})^{-10}$

Деформационные измерения показали, что в пределах описки у исследуемых веществ выполняется так называемый "квадратичный" закон для электрострикционных коэффициентов R_{ij} :

$$R_{ij} = \frac{R_{ij}^{*}}{(1-T_{1})^{2}} \,, \tag{5}$$

где R_{ij} и T_{I} - константи, T - температура (рис. 4.). И сожалению, ограниченная точность измерения деформации (и, следовательно, R_{ij}) и сравнительно узкий температурный интерван, которыи мог онть использован, не позволяли с доста - точной уверенностью определить R_{ij}^{o} и T_{I} для всех исследованных составов и получить соответствующие концентрацион-

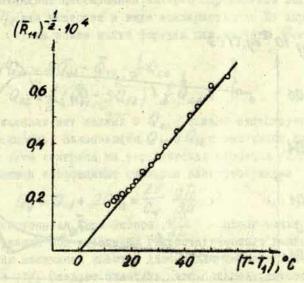


Рис. 4. Температурная зависимость электрострикционного коэффициента R₁₁ для твердого раствора (Ва_{0.75} Sr_{0.25}) T/O₃

ные зависимости.

Следует отметить, что довольно большой разброс данных (особенно для Q_{ij}) наблюдается также на концентрационных зависимостях Q_{ij} .

На рис. 5 приведена концентрационная вависимость, полученная прямым измерением электрострикционных коэффициентов Q_M и Q₁₂ для твердых растворов (Ва,Sr)Ті 0₃ и (Ро,Sr)Ті 0₄
Точки на рисунке соответствуют средней величине коэффициента для нескольких образцов одного состава (определены в
области 30-40° выше Т_с). Для образцов "чистого" титаната
стронция и растворов с малыми добавками (1 и 2 мол.Я
РВТі 0₃), электрострикционные коэффициенты измерялись при
температуре индкого азота.

Из приведенных данных видно, что в твердых растворах

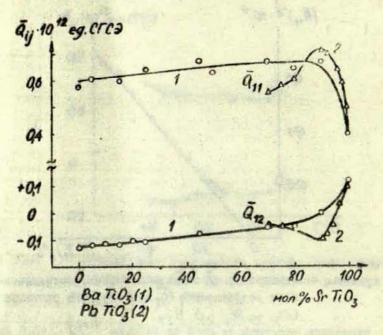


Рис.5. Концентрационная зависимость электрострикционных коэффициентов \overline{Q}_{44} и \overline{Q}_{42} для твердых растворов (Ba,Sr) $\overline{\chi}_{10}$ и (Pb,Sr) $\overline{\chi}_{10}$

(Ва, Sr) Ti O_3 Q_{H} постепенно увеличивается с ростом концентрации Sr Ti O_3 и достигает максимума в раноне 80-90 мол. S. К совелению, не было возможности исследовать образцы Sr Ti O_3 с небольшими добавками ВаTi O_3 . Коэффициент Q_{12} С возрастанием концентрации Sr Ti O_3 постепенно увеличивается, меняет знак и становится положительным для "чистого" титаната стронция.

На рис. 5. показани аналогичние зависимости от концентрации (х) для твердих растворов (Pb,Sr)Ti03. Здесь максимум на кривои Q_n (х) виражен более отчетливо, появляется минимум и на кривой Q_2 .

Предоставляет несомненный интерес определение величин Q_{44} и Q_{72} для вещества в виде монокристалла. Из выражений (3) и (4) мы можем найти формулы для расчета Q_{44} и Q_{72} :

 $Q_{12}: Q_{11} = 2\bar{Q}_{11} - \bar{Q}_{12} - \frac{1}{2}Q_{44},$ $Q_{12} = \frac{1}{2}(\bar{Q}_{11} - 3\bar{Q}_{12}) + \frac{1}{4}Q_{44}.$ (6)

К сожалению нет данных о Q_{44} , однако существует еще одна зависимость, связывающая Q_{44} и Q_{12} с величиной, которая может быть измерена на керамических образцах /22/. Это, так называемый коэффициент объемной электрострикции

$$Q_{\nu} = Q_{44} + 2Q_{42} = \frac{2\pi}{C_W} \frac{\partial T_c}{\partial \rho}$$
, (7)

где C_W — постоянная Кири-Вейсса , $\frac{\partial T_C}{\partial C}$ — сдвиг точки фазовово перехода под действием гидростатического давления.
О последних величинах имертся дажне для интересущих нас
систем /23-27/. Следует отметить, что большей достовер —
ностью обладают данные о величине постоянной Кири-Вейсса,
в то же время данные о сдвиге точки фазового перехода под
действием гидростатического давления у разных авторов имевт большой разброс.

Из выражений (3) и (4) следует, что $Q_{14} + 2Q_{12} = Q_{14} + 2Q_{12} = Q_V.$

M

Таким образом, ин можем наити еще две пары формулы для определения Q_{11} и Q_{12} :

 $Q_{11} = \frac{1}{2} (5\bar{Q}_{11} - Q_{\nu}) - \frac{1}{2} Q_{44},$ $Q_{12} = -\frac{1}{4} (5\bar{Q}_{11} - 3Q_{\nu}) + \frac{1}{4} Q_{44},$ $Q_{44} = 2Q_{\nu} - 5\bar{Q}_{12} - \frac{1}{2} Q_{44},$ $Q_{42} = -\frac{1}{2} (Q_{\nu} - 5\bar{Q}_{12}) + \frac{1}{4} Q_{44},$ (9)

Как видно из (6), (8) и (9), поправки вносимые Q_{44} одинаковы во всех трех случаях. Значение Q_{44} =0,7.10⁻¹² ед.СГСЭ известна только для ВаТ(0.3); оно определено в ром-

бической фазе и нет данных о прямых измерениях в кубической фазе. Следует отметить, что подстановка в выражениях (6),(8) и (9) полученных нами данных Q_{11} и Q_{12} для керамики ВаТі O_3 иЗгТі O_3 дает величины Q_{11} и Q_{12} хорошо совпадающие с данными, полученными на монокристаллах, даже если положить $Q_{44} \approx 0$. Это, очевидно, означает, что в выражениях (6),(8) и (9) член содержащий Q_{44} , не имеет большого вначения. Следовательно, если преследуется цель получения, главным образом, качественной картины для зависимостей Q_{44} (х) и Q_{42} (х), то величиной Q_{44} можно пренебречь.

Рассчитанные по формуле (7) коэффициенты объемной электрострикции для твердых растворов (Ва, Sr) То 03 и (Ро, Sr) То 03 с привлечением исходных данных из работ /23,24/ приведены на рис. 6. Там же показаны результаты, полученные нами на основании измерения электрострикционных коэффициентов Q₁₁ и Q₁₂ для этих веществ. Коэффициенты объемной электро стрикции, полученные обемми методами, качественно хорошо согласуются между собоя. По нашему мнений количественное отличие полученных результатов можно объяснить тем, что значения (Сро), данные в работе /24/; для твердих растворов (Ва, Sr) То 03 несколько занижены. Так величины (Сро), определенные по измерениям теплоемкости и термического расширения /28/ и совпадающие с /26,27/, для ВаТо 03 лучше согласуются с нашими результатами.

На рис. 7 приведени средние значения величин Q_{44} и Q_{42} для вещества в виде монокристалла, определенные из ссотношении (6),(8) и (9) (превебретая Q_{44}), используя измеренные нами Q_{44} и Q_{42} (рис. 5.) и такие Q_{44} рассчитанный по формуле (7) (рис. 6). Разброс результатов, из разных соотношении составляет около 15 % от среднего значения для титаната бария и постепенно уменьшается до нескольких % для твердых растворов с концентрацией титаната стронция более чем 70 мол. %. Это связано с отличием величины объемного злектрострикционного коэффициента, рассчитанным по формуле (7) и по нашим данным Q_{44} и Q_{42} (рис. 6).

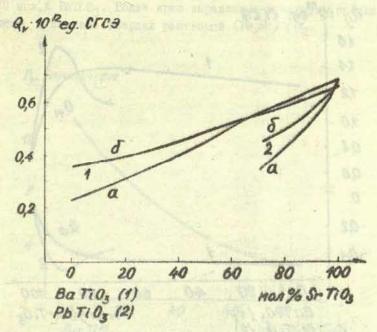


Рис. 6. Концентрационная зависимость объемного электрострикционного коэффициента Q_{ν} для твердых растворов (Ba, Sr) Ti O3 и (Pb, Sr) Ti O3. а - по данным $Q_{\nu} = \frac{2\pi}{C_{\nu\nu}} \frac{\partial Z_{\nu}}{\partial p}$, б - по данным $Q_{\nu} = \frac{2\pi}{C_{\nu\nu}} \frac{\partial Z_{\nu}}{\partial p}$,

Общий характер концентрационных зависимостей Q_{eq} и Q_{eq} и Q_{eq} и Q_{eq} для поликристаллических материалов. Значения Q_{eq} и Q_{eq} для похикристаллических материалов. Значения Q_{eq} и Q_{eq} для исходных компонентов довольно хорошо согласуртся с литературными данными. Так, для тытаната бария при $T = 150^{\circ}$ C мн получили $Q_{eq} = 1.25$. 10^{-12} и $Q_{eq} = 0.49$ 10^{-12} (в работе /7/ соответственно $Q_{eq} = 1.26$. 10^{-12}

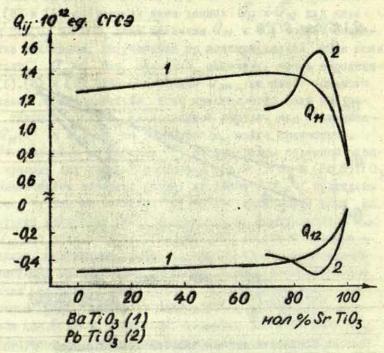


Рис. 7. Концентрационная зависимость электрострикционных коэффициентов Q_H и Q₁₂, рассчитанных для монокристаллов (Ва, Sr) TiO₃, (Pb, Sr) TiO₃ по данным ирминх на рисунках 5 и 6

и $Q_{12} = -0.47$. 10^{-12}), а для титаната стронция при $T = -196^{\circ}$ С $Q_{M} = 0.70$: 10^{-12} и $Q_{42} = -0.02$. 10^{-12} (в расоте /12/ соответственно 0.73 . 10^{-12} и -0.13 . 10^{-12} при температуре $T = -193^{\circ}$ С). Из рис. 7 цидно, что введение титанатов бария и свинца в исходный $SrTiO_3$ сильно увеличивает абсолютные значения электрострикционных коэффициентов.

Коэффициенты Q_{11} и Q_{12} достигают максимальных величин при концентрации 25 мол. % ВаТ(03 и соответственно и мол. % РоТ(03. Более ярко вираженные максимумы наблюдаться в системе твердых растворов (Ро. Яг)Т(03.

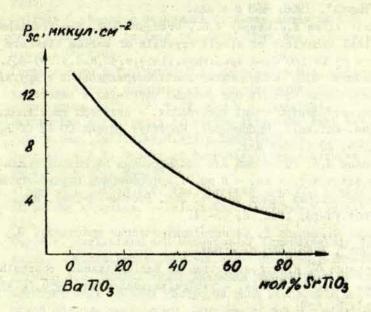


Рис. 8. Концентрационная зависимость скачка спонтанной поляризации при $T = T_c$ в системе твердых растворов (Ва, S-) T(03

Используя данные объемной спонтанной деформации $\frac{\Delta V_S}{V}$, полученные в измерениях линейного термического расширения /28/, и наши измерения для Q_V (рис.6), по формуле

 $P_{SC} = \sqrt{\frac{\Delta V_S}{V}} \tag{10}$

можно определить скачек спонтанной поляризации при фазовом переходе из кубической в тетрагональную фазу.Полученные результаты (рис.8) в общем хорошо согласуются с данными работы /28/.

ЛИТЕРАТУРА

- Губкин А.Н. Физика диалектриков.т.І. М., "Высшая школа", 1971, 272 с. с илл.
- Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков. М., "Наука", 1968, 463 с.с илл.
- Huibregtse E.J.Bessey W.H., Drougard M.E. Electromechanical behaviour of single crystals of barium titanate from 25 to 160°C.-J.Appl.Phys., 1959, v. 30, N.6, p. 899-905.
- 4. Зайцева М.П. Исследование электрострикционных и других физических свойств при фазовых переходах в некоторых сегнетоэлектрических кристаллах. - Автореф. дисс. канд. физ.-мат. наук, Красноярск, Институт физики СО АН СССР, 1968. 23 с. без илл.
- Балаш В.А. Установка для исследования магнитострикции и электрострикции. – В кн.: Авторефераты научно-исследовательских работ за 1961 год. Ростов-на-Дону, изд. Рост.ун-та, 1962, с. 73-74.
- 6. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллн. М., "Мир", 1965, 555 с. с илл.
- Schmidt G. Elektrostriktion in Bariumtitanat oberhalb des Curie - Punktes. - Naturwissenschaften, 1958, Jg. 45, H.1, S. 8-9.
- Ruprecht G., Winter W.H. Electromechanical behaviour of single-crystal strontium titanate. Phys.Rev., 1967,
 v. 155, N. 3, p. 1019-1028.
- 9. Berlincourt D., Jaffe H. Elastic and piezoelectric coefficients of single-cristal barium titanate. - Phys. Rev., 1958, v.111, N.1, p.143-148.
- Schmidt G. Der elektrostriktive Resonator. Phys. status solidi, 1965, v. 8, N. 1, 47-54.
- Procert F. Untersuchungen am kubischen Bariumtitanat nach der Methode des elektrostriktiven Resonators. -Chechosl. J.Phys., 1966, v.16, N. 5B, p. 404-408.

- 12. Schmidt G., Hegenbarth E. Elektromechanische Eigenschaften von Strontiumtitanateinkristallen. Phys. status solidi, 1963, v. 3, N. 2, p. 329-338.
- 13. Bell R.O., Rupprecht G. Dielectric constant in paraelectric perovskites.-Phys.Rev.,1964,v.135,N.3A,p.748-752.
- 14. Shirane G., Hoshino S., Suzuki K. X-ray study of the phase transition in lead titanate. Phys. Rev., 1950, v.80, N.6, p.1105-1106.
- 15. Гавриляченко В.Г., Спинко Р.И., Мартиненко М.А., Фесенко Е.Г. Спонтанная поляривация и коэрцитивное поле титаната свинца.—2ТТ, 1970, т.12., вып.5, с.1532—1534.
- Devonshire A.F. Theory of barium titanate. Part 2.— Philos.Mag., 1951, v. 42, N. 333, p. 1065-1079.
- 17. Devonshire A.F. Theory of ferroelectrics.-Advances Phys., 1954, v.3, N.10, p.85-130.
- Allsop H.L., Gibbs D.F. The electromechanical properties of barium titanate. - Philos. Mag., 1959, v.4, N.39, p.359-370.
- Kay H.F. Nucleation and kinetics of ferroelectric domains. - Kinet.React.Ion.Syst.New-York, 1969, p. 206-227.
- 20. Круминь А.Э. Исследование динамики поляризации сегнетоэлектрических твердых растворов типа перовскита в широкой области температур, напряженностей и времен действия электрического полн. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971. с.155-204.
- Методика исследования поликристаллических сегнетоэлектриков. Коллектив авторов. Рига, ЛГУ им.П.Стучки, 1970, 148 с. с илл.
- 22. Фрицберг В.Я. О возможности исследования фундаментальных свойств сегнетоэлектрических твердых растворов типа титаната бария.— В кн.: Титанат бария.М., "Наука", 1973, с.86-93.
- 23. Брок А.Я., Фрицберг В.Я., Такере З.А., Олежнович Р.Я.,
 Тункун З.А. Экспериментальные результаты исследования

- обобщенного закона Кюри-Вейсса в системах твердых растворов со структурой типа перовскита. - См. настоящий сборник, с.5-46.
- 24. Фрицферг П.А. Диэлектрические свойства сегнетоэлектрического твердого раствора (Ва,Sr)ТіО₃ в области фазового перехода при высоких давлениях. В кн.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Рига, "Зинатне", 1971, с. 117-122.
- 25. Hegenbarth E.The shifting of the transition temperature of (Ba_x,Sr_{1-x})TiO₃ solid solution (x≤0.1) by hydrostatic pressure.-J.Phys.Soc.Japan,1970,v.28,suppl.p407-409.
- 26. Samara G.A. Pressure and temperature dependence of the dielectric properties and phase transitions of the ferroelectric perovskites: PbTiO₃ and BaTiO₃. Ferro electrics, 1971, v. 2, p. 277-289.
- Samara G.A. The effects of hydrostatic pressure on ferroelectric properties. - J. Phys. Soc. Japan, 1970, v.28, suppl., p.399-403.
- 28. Фрицберт В.Я., Борман К.Я. Исследование спонтанной деформации и поляризации при фазовых переходах в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита. См. настоящий сборник, с. 99-149.

УДК 537.226.33

Экспериментальные результаты исследования обобщенного закона Кюри-Вейсса в системах твердых растворов со структурой типа перовскита. Брок А.Я., Фрицберг В.Я., З.А.Такере и др. — Учен. зап. ЛГУ им.П. Стучки, 1974, т. 189. Фавовые переходы в сегнетовлектриках со структурой перовскита. с. 5-46.

Применяя резонансную СВЧ методику измерения, установлено, что для перовскитовых сегнетоэлектрических твердых растворов (СЭТР) температурная висимость диэлектрической проницаемости в неполярной фазе подчиняется обобщенному вакону Кюри-Вейсса $\mathcal{E}(T) = \mathcal{E}_L + C_w (T - T_0)^{-1}$. And been enorming следованных СЭТР установлены монотонные концентрационные зависимости значений параметров С., (порядка 10^5 град) и T_0 . Значение $\mathcal{E}_i = 35 \pm 15$ невависимо от состава и концентрации СЭТР. Обобщенный закон Кюри-Вейсса в неполярной фазе СЭТР выполняется независимо от степени размытия сегнетовлектрического фазового перехода (СЭФП). В области размития СЭПФ наблюдается отклонение от этого закона. При этом для СЭТР типа $Pb(Mg,N1)_{1/3}Nb_{2/3}O_{3}$ выполняется со-отношение $\mathcal{E}(T) = A + B(T - T_{M})^{2}$, однако оно не имеет место для других СЭТР типа Вы(Ті, Sn)03, Ba(Ti,Zr)O3 и (Bi2/3,Sr)TiO3, также обладающих размитим СЭФП.

Илл. - 14, библиогр. - 31 назв.

УДК 537.226.33

Исследование диэлектрической нелинейности в твердых растворах типа титаната бария при температурах выше точки Кюри. Фрицберг В.Я., Гринвалд Г.Ж., Гаевский А.П. Учен. зап. ЛГУ им. П.Стучки, 1974, т. 189. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой перовскита, с. 47-98.

Проведен теоретический анализ поляризационных явлений, имеющих место в области фазового перехода I рода, и показано, что в сегнетокерамике в неполярной фазе при температуре $T > T_{\rm KD}$ во внешнем поле Е > Е, описание эффектов диэлектрической нелинейности успешно может быть проведено на основе выражения $E = \propto P + \beta P^3$, где $\alpha > 0$, $\beta > 0$. Рассмотрена зависимость нелинейности от температуры и поля. Выгоды теории сопоставлены с экспериментальными данными, полученными на сегнетоэлектрических твердых pacteopax (CTP) cucremu (Ba, Sr,) TiO3 $Ba(n_{+x}, n_x)$ в которых β имеет порядок 10^{-12} ед. СГСЭ и монотонно возрастает по мере увеличения концентрации второго компонента. В исследованных СТР коэффициент В монотонно (приблизительно линейно) растет с температурой. Установлено хорошее согласие экспериментальных результатов с предсказаниями тео-DNN.

Табл. 6, илл. - 15, библиогр. - 37 назв.

УЛК 537.226.33

Исследование спонтанной деформации и поляризации при фазовых переходах в сегнетовлектрических твердых растворах со структурой перовскита. Фрицберг В.Я., Борман К.Я. Учен.вап.ЛГУ им.П.Стучки, 1374, т. 189. Фазовие переходы в сегнетовлектриках со структурой перовскита, с. 99-149.

Рассмотрена связь макроскопической деформации образца с температурной зависимостью пераметров элементарной ячейки в области тетрагонально-кубического фазового перехода (ФП).

При помощи высокочувствительного дилатометра изучалась спонтанная деформация в твердых растворах систем (Ва, sr) tio_3 , (Pb, sr) tio_3 , (Ba, Pb) tio_3 , Ba(ti, sr) o_3 , Ba(ti, ti) o_3 , Pb tio_3 , Pb

На основании представлений теории размитых фазових переходов из полученных экспериментальных данных рассчитаны следующие характерные параметры (и определены их концентрационные зависимости): степень размытия ФП, приведенный скачок спонтанной деформации и поляризации P_{SC} , объем элементарной области ФП. Характер концентрационной зависимости $P_{SC}(x)$ опровергает выдвинутое в работе /30/утверждение о справедливости соотношения $T_{C} \sim P_{SC}^{2}$ в сегнетоэлектриках типа смещения (концентрационная зависимость $T_{C}(x)$ — линейна, в то время как зависимость $P_{SC}^{2}(x)$ — нелинейна).

Илл.-16, библиогр. - 31 назв.

YAK 537.226.33

Рентгеноструктурное исследование тетрагонально-кубического фавового перехода в сегнетоэлектрических твердых растворах (Ва,Sr)ТіО₃. Мебанов Л.А. Учен. зап. ЛГУ им.П.Стучки, 1974, т.189. Фавовые переходы в сегнетовлектриках со отруктурой перовскита, с. 150-160.

На основе разработанной методики дешифрации дифракционных линий сложного профиля определились температурные зависимости параметров элементарной ячейки твердых растворов (Ba, Sr) Т10 в области тетрагонально-кубического фазового перехода. Обработка виспериментальных данных проводилась с испольвованием ЭВМ. Дано описание вичислительной программы дешифрации. Достоверность методики проверялась на примере сравнения полученных данных для чистого ватто, с результатами работы других авторов. Найдено, что в интервале концентраций 0+25 мол. % srT10, тетрагональность структуры и относительная спонтанная деформация ичейки монотонно уменьшаются по нелинейному вакону. Приводится концентрационная зависимость параметров нчейки в точке фазового перехода и в кубической фазе при температуре Т = 180°С. Обсуждаются перспективы дальнейшего развития применяемой методики.

Илл. - 7, библиогр. - 10 назв.

УДК 537.226.33

Исследование электрострикции в неполярной фазе у сегнетоэлектрических твердых растворов со структурой перовскита. Пуриньш Э.Х., Фрицберг В.Я. Учен.зап. ЛГУ им.П.Стучки, 1974, т.189. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой перовскита, с.161-180.

Экспериментально определени коэффициенты электрострикции Q_{tf} и Q_{t2} в неполярной фазе в поликристаллических образцах сегнетоэлектрических твердых растворов (СТР) систем (Ва, Sr)тіо и (Рь, Sr)тіо и Предпринята попытка на основании этих результатов и с привлечением некоторых дополнительных данных, путем расчета определить Q_{tf} и Q_{t2} для СТР, представленных в виде монокристаллов. Для отдельных компонент СТР (Ватіо и Srтіо) получено хорошее совпадение с известными экспериментальными данными для монокристаллов. Установлено, что концентрационные зависимости коэффициентов $Q_{tf}(x)$ и $|Q_{t2}(x)|$ для обещх систем СТР резко возрастают при небольших концентрациях ватіо или Рътіо или

Илл. -.8, библиогр. - 29 назв.

содержание

Предисловие	3
Брок А.Я., Фрицберг В.Я., Таке-	
ре В.А., Олехнович Р.Я., Тун-	
к у н В.А. Экспериментальные результаты ис-	
следования обобщенного закона Кюри-Вейсса в	
системах твердых растворов сс структурой типа	
перовскита	5
Фрицоерг В.Я., Гринвалд Г.К.,	
Гаевский А.П. Исследование дивлектричес-	
кой нелинейности в твердых растворах типа титана-	
та бария при температуреж выше точки Кюри	47
Фрицоврт В.Я., Борман К.Я.	
Исследование спонтанной деформации и поляризации	
при фазовых переходах в сегнетоэлектрических	00
твердых растворах со структурой перовскита	99
Пебанов Л.А. Рентгеноструктурное исследо-	
вание тетрагонально-кубического фазового перехода	
в сегнетоэлектрических твердых растворах системы	
(Ba, Sr)TiO ₃	150
THE REPORT OF STREET, AND STREET, WITHOUT A	
Пуринь и Э.Х., Фрицберг В.Я.	
Исследование электрострикции в неполярной фазе у	
сегнетовлентрических твердых растворов со струк-	12. 14%
турой перовокита	161

Ученые записки, том 189 ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА

Редактор А.Круминьш Технический редактор Э.Бормане Корректор Э.Бормане

Редакционно-издательский отдел ЛГУ им. Петра Стучки Рига 1974

Подписано к печати 2.01.1974 ЯТ 06002 Зак. № 247. Ф/d 60x84/I6. Бумата № I. Физ.п.л. I2.0. Уч.-и.л. 9.0. Тираж 600 экз. Цена 90 к.

Отпечатано на ротапринте, Рига-50, ул. Вейденбаума, 5 Латнийский государственный университет им. П. Отучки LU bibliotēka

200023288

HEHA 90 KOL.

Учен. зап. (ЛГУ им. П. Стучки), 1974, т. 189. 1-186.